## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-094984

(43)Date of publication of application: 12.04.1996

(51)Int.CI.

G02F 1/13

(21)Application number: 06-235131

(71)Applicant: SHIBAURA ENG WORKS CO LTD

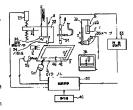
(22)Date of filing: 29.09.1994 (72)Inventor: HARA AKIRA NAKAI AKIRA

### (54) SEALING APPLICATOR OF SEALANT AND ITS METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a coating applicator of a sealant constituted to applying the sealant at a specified width size and height.

CONSTITUTION: This coating applicator includes a nozzle body 24 which is disposed above an X-Y table 4. is driven along a Z direction and discharges the sealant to be applied on a substrate 6, a scope 35 which picks up the image of the nozzle body and the substrate on the X-Y table from the side, an operating section 40 which sets the spacing between the front end of the nozzle body and the front surface of the substrate by the image from the scope 35, a distance detecting sensor 26 which detects the first height position on the front surface of the substrate when the spacing is set by the operating section and the second height position of the front surface of the substrate of the part to be coated with the sealant at the time of applying the sealant and a controller 30 in which the first height position detected by the sensor 26 is stored and which



compares the second height position to be detected at the time of applying the sealant with the first height position and corrects the position of the Z direction of the nozzle body in accordance with the comparison.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.08.2001

Date of sending the examiner's decision of

27 05 2003

rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3732538

[Date of registration]

21.10.2005

[Number of appeal against examiner's decision 2003-11984

Searching PAJ 2/2 ページ

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's 26.06.2003 decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



### (19) 日本国特許庁 (JP)

## (1)公開特許公報 (4)

### (11)特許出願公開番号

## 特開平8-94984

(43)公開日 平成8年(1996)4月12日

(51) Int. Cl. <sup>6</sup> 識別記号 GO2F 1/13 101

FΙ

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全7頁)

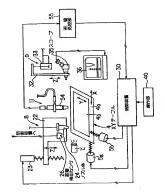
(21)出顯番号	特願平6-235131	(71)出願人	000002428 株式会社芝浦製作所					
(22) 出顧日	平成6年(1994)9月29日		東京都港区赤坂1丁目1番12号					
(00) 1-1-0.		(72)発明者	原曉					
			神奈川県横浜市栄区笠間町1000番地1	株				
			式会社芝浦製作所大船工場内					
		(72)発明者	仲井 章					
			神奈川県横浜市栄区笠間町1000番地1	B地1 株				
			式会社芝浦製作所大船工場内					
		(74)代理人	弁理士 鈴江 武彦					
		ļ						

#### (54) 【発明の名称】シール剤の塗布装置およびその方法

#### (57) 【要約】

[目的] この発明はシール剤を一定の幅寸法と高さで 塗布することができるようにしたシール剤の塗布装置を 提供することにある。

【構成】 XYテーブル4の上方に設けられる方向に治 で駆動されるとともに基板6に塗布されるシール網を 吐出するブスル体24と、ノズル体とXYデーブル上の 基板とを耐力から撮像するスコープ35と、スコープ3 かからの画像によってノズル体先端と基板上面との間隔 を設定する整件部40と、操作部によって「間路を設定したときの基板上面の第10高さ位置料はびシール判録を 市にシール料が強布される部分の基板上面の第2の高さ 位置を検出する距離検出センサ26と、センサ26によ り検出された第1の高さ位置が記憶されるとともに、シール判盤・市時に検出する第2の高さ位置を別に高さ 置と比較、その比較に基づいてノズル体の2万向の位置を 置を抽工する制御装置30とき具備したことを特徴とする。



(特許請求の範囲)

【請求項1】 液品用基板にシール剤を塗布する塗布装 置において、

#### 装置本体と、

この本体に設けられXY方向に駆動されるとともに上面 に上記基板が載置されるXYテーブルと、

このXYテーブルの上方に設けられ上記XYテーブルの 移動方向と直交するZ方向に沿って駆動されるとともに 上記基板に塗布されるシール剤を吐出するノズル体と、 このノズル体と上記XYテーブル上の基板とを側方から 10 提倫する提倫手段と、

この撮像手段からの画像によって上記ノズル体先端と上 記基板上面との間隔を設定する設定手段と、

ト記ノズル体と一体的に設けられ上記設定手段によって 間隔を設定したときの上記基板上面の第1の高さ位置お よびシール剤塗布時にシール剤が塗布される部分の基板 上面の第2の高さ位置を検出する検出手段と、

この検出手段により検出された第1の高さ位置が記憶さ れるとともに、シール剤塗布時に検出する上記第2の高 さ位置を上記第1の高さ位置と比較し、その比較に基づ 20 いて上記ノズル体の2方向の位置を補正する制御手段と を具備したことを特徴とするシール剤の塗布装置。

【請求項2】 シール剤をノズル体から吐出させ、その シール剤を液晶用基板に塗布する塗布方法において、 上記ノズル体をその先端が上記基板に当たることのない 所定の位置まで下降させて提像する工程と、

撮像された上記ノズル体と上記基板との画像から上記ノ プル体先端と上記基板上面との開隔を設定する工程と、 上記ノズル体先端と上記基板上面との間隔が設定された 高さ位置を検出して記憶する工程と、

シール剤塗布時に上記ノズル体を基準にしてシール剤が 途布される部分の基板上面の第2の高さ位置を検出し、 その第2の高さ位置を上記第1の高さ位置と比較し、そ の比較に基づいて上記ノズル体の2方向の位置を補正す る工程とを具備したことを特徴とするシール剤の塗布方 法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】この発明は液晶用の基板にシール 40 剤を塗布するためのシール剤の塗布装置およびその方法 に関する。

#### [0 0 0 2]

【従来の技術】一般に、液晶表示装置は一対のガラス製 の基板を所定の間隔で離間対向させて結合するととも に、これら基板間の空間部に液晶を充填して形成され る。上記空間部は周辺部がシール剤によって密封され

【0003】 ト記シール剤は一対の基板を結合する前 に、一方の基板の周辺部に釜布される。基板にシール剤 50 に変化することになるから、そのことによってシール剤

を除布する場合、スクリーン印刷による方法と、特開平 2-198417号公報に示されるようにノズル体を用 いて途布する方法とがある。

[0004]前者の場合、基板にスクリーンが接触する ため、スクリーンに付着した微粒子が基板に転移される ということがあり、またシール剤はスキージで上記スク リーンに刷り込んでそのパターン開口を通過させて印刷 されるため、塗布量が一定しずらいなどのことがあっ

[0005] これに対して後者の場合、基板にノズル体 を接触させずに、一定の間隔を保ちながらノズル体から 一定量のシール剤を吐出させることができるから、前者 の場合に比べて基板を汚すことなく、精度よく塗布する ことができる。

【0006】ところで、基板に塗布されるシール剤の幅 寸法や高さ寸法が一定しないと、一対の基板を結合した とき、シール剤が多い場合には基板に形成されたパター ン上に食み出し、少ない場合にはシール幅が十分に得ら れず、液晶の漏れが生じるなどのことがある。したがっ て、基板に供給されるシール剤の幅寸法や高さ寸法はμ m単位の精度で管理することが要求される。

【0007】ノズル体を用いてシール剤を塗布する場 合、上記ノズル体から吐出されるシール剤の圧力を一定 に制御することで、塗布されるシール剤の幅寸法や高さ 寸法を管理するということが行われている。

【0008】しかしながら、塗布されるシール剤の幅寸 法や高さ寸法は、シール剤の吐出圧力だけに影響される ものでなく、上記基板の上面と上記ノズル体の下端との 間隔によって大きく影響されるということが確認されて ときに上記ノズル体を基準にして上記基板上面の第1の 30 いる。そこで、上記基板とノズル体との間隔を設定して シール剤を塗布するということが行われている。

「0009】従来、上記基板とノズル体との間隔を設定 するには、塗布装置に基準板(ロードセル)を設け、ノ ズル体を下降させて上記基準板にノズル体の先端を接触 させ、その位置を0点(基準点)としてノズル体と基板 との間隔を設定するということが行われていた。 【0010】しかしながら、このような方法によると、

ノズル体を基準板に接触させたとき、ノズル体下端面の 形状変化、さらにはゴミの介在などによって0点が一定 しないということがあるため、上記ノズル体と基板との 間隔を精密に管理できないということがあった。

【0011】また、ノズル体先端と基板上面との間隔を 設定しても、基板は全体にわたって厚さが一様でなく、 また基板はXYテーブルに吸着保持されることで、その テーブルの上面の平面精度に応じてたわみが生じる。 【0012】 したがって、これらのことにより、ノズル 体先端と基板上面との間隔を上記基準板を基準にして設 定しても、ノズル体を所定の軌跡に沿って移動させなが らシール剤を塗布する際、その間隔が一定に維持されず 3

の幅寸法や高さ寸法が一定にならないということもあ る。

#### [0013]

【発明が解決しようとする課題】このように、従来はノ ズル体先端と基板上面との間隔を、上記ノズル体を基準 板に接触させ、その位置を基準点として設定していたの で、接触時の条件が変わることで、上記間隔を一定に設 定するということができないということがあった。

【0014】また、基板は全体にわたって厚さが一様で ないばかりか、XYテーブルに吸着されることで、上記 10 ば、ノズル体を基板に接触させずに、ノズル体先端と基 テーブルの平面精度に応じてたわみが生じるから、ノズ ル体と基板との間隔を基準板によって設定しても、ノズ ル体を移動させてシール剤を塗布する際に、それらの間 隔が変化してしまうということがあった。

【0015】この発明の目的は、ノズル体の先端を基準 板に接触させることなく、ノズル体先端と基板上面との 間隔を設定できるようにするとともに、基板の厚さが一 様でなかったり、XYテーブル上に吸着保持されること でたわみが生じたりしても、ノズル体先端と基板上面と の間隔を一定に維持しながらシール剤を塗布することが 20 を介して支持されたベース3を有する。このベース3上 できるシール剤の塗布装置およびその方法を提供するこ とにある。

#### [0016]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に請求項1に記載されたこの発明は、液晶用基板にシー ル剤を塗布する塗布装置において、装置本体と、この本 体に設けられXY方向に駆動されるとともに上面に上記 基板が載置されるXYテーブルと、このXYテーブルの 上方に設けられ上記XYテーブルの移動方向と直交する 2方向に沿って駆動されるとともに上記基板に塗布され 30 上記吸引機構によって吸着保持されるようになってい るシール剤を吐出するノズル体と、このノズル体と上記 XYテーブル上の基板とを側方から撮像する撮像手段 と、この提像手段からの画像によって上記ノズル体先端 と上記基板上面との間隔を設定する設定手段と、上記ノ ズル体と--体的に設けられ上記設定手段によって間隔を 設定したときの上記基板上面の第1の高さ位置およびシ ール剤塗布時にシール剤が塗布される部分の基板上面の 第2の高さ位置を検出する検出手段と、この検出手段に より検出された第1の高さ位置が記憶されるとともに、 シール創除布時に検出する上記第2の高さ位置を上記第 40 1の高さ位置と比較し、その比較に基づいて上記ノズル 体のZ方向の位置を補正する制御手段とを具備したこと を特徴とする。

【0017】請求項2に記載された発明は、シール剤を ノズル体から吐出させ、そのシール剤を液晶用基板に塗 布する徐布方法において、上記ノズル体をその先端が上 紀基板に当たることのない所定の位置まで下降させて掲 像する工程と、撮像された上記ノズル体と上記基板との 画像から上記ノズル体先端と上記基板上面との間隔を設 定する工程と、上記ノズル体先端と上記基板上面との間 50 まり基板上面の高さをμm単位の精度で検出する。

綴が設定されたときに上記ノズル体を基準にして上記基 板上面の第1の高さ位置を検出して記憶する工程と、シ 一ル剤涂布時に上記ノズル体を基準にしてシール剤が涂 布される部分の基板上面の第2の高さ位置を検出し、そ の第2の高さ位置を上記第1の高さ位置と比較し、その 比較に基づいて上記ノズル体の2方向の位置を補正する 工程とを具備したことを特徴とする。

#### [0018]

【作用】請求項1と請求項2に記載された発明によれ 板上面との間隔を設定することができ、また基板の厚さ に誤差があったり、基板がXYテーブルに吸着されるこ とでたわんだりしても、ノズル体先端と基板上面との間 隔を一定に制御しながらシール剤を塗布することができ る。

#### [0019]

【実施例】以下、この発明の一実施例を図面を参照して 説明する。図4はこの発明のシール剤塗布装置の正面図 で、同図中1は装置本体である。この本体1は防振台2 にはXY方向(二次元方向)に駆動されるXYテーブル 4が設けられている。このXYテーブル4は、図1に示 すようにモータからなる X 駆動源 5 a によって X 方向に 駆動されるXテーブル4aと、このXテーブル4a上に 設けられ同じくモータからなるY駆動源5bによってY 方向に駆動されるYテーブル4bとを備えている。

【0020】上記XYテーブル4上には図示しない吸引 機構を備えたステージ5が設けられ、このステージ5上 には液晶表示装置を形成するためのガラス製の基板 6 が

【0 0 2 1】 上記ペース 3 の上方には門型の架台 7 が設 けられている。この架台?にはノズル上下機構8、スコ ープト下機機9およびアライメントカメラ調整機構11 が設けられている。

【0022】上記ノズル上下機構8は、図5(a)、

(b) に示すように上記架台?に取付け固定される固定 板21を有する。この固定板21には可動板22が上記 XY方向がなす平面に対して垂直なZ方向に沿って移動 自在に設けられている。この可動板22は上記固定板2 1 に設けられたサーボモータ 2 3 によって 2 方向にμm 単位の精度で駆動されるようになっている。

【0023】上記可動板22にはノズル体24とZ方向 の微調整機構25を介して距離検出センサ26とが一体 的に設けられている。上記ノズル体24は、内部に供給 されて加圧されたシール剤を吐出して後述するごとく上 紀ステージ5に吸着保持された基板6の周辺部に沿って 途布するためのものであり、また上記距離検出センサ2 6は、上紀ノズル体24先端と基板6上面との間隔、つ

[0024] そして、上記距離検出センサ26からの検 出信号によって、上記基板6上面に上記シール剤を塗布 する際に、上記ノズル体24先端と基板6上面との間隔 が後述するごとく一定に制御される。

【0025】上記距離検出センサ26によって検出され た検出信号、つまり基板6の所定位置の高さ信号は図1 に示す制御装置30に入力される。この制御装置31 は、XYテーブル4を駆動して上記基板6にシール剤を 涂布する際、後述するごとく設定された、上記ノズル体 24先端と基板6上面との間隔Gを、上記距離検出セン 10 基板が用いられることもある。 サ26からの輸出信号によって補正する。

【0026】 つまり、後述するように、上記距離検出セ ンサ26からの輸出信号によって、基板6の厚さに誤差 があったり、吸着されることでたわんだりしても、その 上面とノズル体24先端との間隔Gが一定に保たれてシ ール剤が塗布されるようになっている。

[0027]上記スコープ上下機構9は、図6(a)、 (b) に示すように上記架台7に取付け固定される固定

板31を有する。この固定板31には可動板32が2方 向に沿って移動自在に設けられている。この可動板32 20 は上記固定板31に設けられたマイクロシリンダ33に よって2方向に駆動されるようになっており、その下端 部にはXY精密ステージ34が設けられている。このX V糖密ステージ34には構像手段としてのCCDカメラ からなるスコープ35が保持されている。

【0028】上記XYテーブル4を上記スコープ35の 下方から退避させた状態で上記マイクロシリンダ34を 作動させて上記スコープ35を下降させると、このスコ ープ35はXVテーブル4上に設置された基板6と、こ の基板6の上面に先端を対向させたノズル体24の先端 30 先端と基板6上面との間隔がμm単位の精度で一定に維 部とを撮像するようになっている。上記スコープ35に よる楊像部位は図1に示す光源ランプしによって照明さ

[0029] 上記スコープ34の撮像信号は図1に示す モニタ36に送られて表示される。モニタ36には図2 (a) に示すように、基板6とノズル体24との画像お よびその画像に対応する位置に目盛37が表示される。 したがって、この目盛37により、上記基板6上面と、 上記ノズル体24先端との間隔Gを読み取ることがで き、またその間隔Gは上記ノズル体24の2方向の位置 40 24からシール剤が所定の圧力で吐出されるとともに、 をサーボモータ23によって翻整することで、任意の値 に設定できる。

【0030】上記ノズル体24の2方向の位置の設定 は、上記制御装置30に接続された操作部40によって 行われる。この操作部40には図3に示すよう基板6上 面と上記ノズル体24先端との間隔Gの設定に関連する 開始スイッチ39、上昇スイッチ41、下降スイッチ4 2、設定スイッチ43、戻りスイッチ44が設けられ、 またシール剤塗布に関連するキャリブレーションスイッ チ45、運転スイッチ46、停止スイッチ47が設けら 50 板52がマイクロメータからなるX、Y、Z方向の微調

れている。操作部40はキーボードであってもよく、ま たはタッチ入力できるデイスプレイのいずれであっても

【0031】上記開始スイッチ39をオンすると、ステ ージ5に載置された基板6が真空吸着され、XYテープ ル4をギャップ設定ポジションに位置決めする。 つい で、スコープ35が下降し、モニタ36に基板6上面と ノズル体24下端との画像が表示される。なお、最初に 間隔Gを設定するときには基板6に相当する形状の基準

[0032] 上記上昇スイッチ41、下降スイッチ42 は上記サーボモータ23を作動させて上記ノズル体24 を上昇、下降させるためのスイッチで、上記設定スイッ チ43は上記上昇および下降スイッチによって間隔Gを 設定したのちオンすることで、その間隔Gを制御装置3 0 に記憶させる。それによって、間隔Gの設定が終了す。

【0033】上記戻りスイッチ44は、間隔Gの設定後 にオンすることで、スコープ35を上昇させるととも に、XYテーブル4を初期位置に戻す。上記キャリブレ ーションスイッチ45は、上記間隔Gの設定後にオンす ることで、自動的に測長のゼロポイントを捜し出し、そ の位置を上記制御装置30に記憶させる。シール剤塗布 時に、上記距離検出センサ26の検出信号と、記憶され たゼロポイントとが比較され、その差に応じてサーボモ ータ23が駆動されてノズル体24の2方向の位置が制 御される。つまり、シール剤塗布時に、基板6の厚さの 変化やたわみなどで設定された間隔Gに変化すると、そ の変化に応じて間隔Gが補正されるから、ノズル体24 持される。

【0034】この実施例においては、キャリプレーショ ンスイッチ45をオンすることで測長されるゼロポイン ト、つまり間隔Gを設定したときの基板 6 上面の高さを 第1の高さ位置とし、シール剤塗布時に上記距離検出セ ンサ26によって検出される基板6上面の高さを第2の 高さ位置とする。

[0035] 上記運転スイッチ46はシール剤の塗布を 開始するためのもので、オンすることで、上記ノズル体 制御装置30に予め設定されたデータに基づいてXYテ ーブル4がXY方向に所定の軌跡で駆動される。それに よって、XYテーブル4上の基板6の所定位置、つまり 図2 (b) に示す基板6に形成された回路パターンPの 届辺部に沿ってシール剤Sが矩形枠状に塗布されること になる。

[0036] 上記アライメントカメラ調整機構11は、 図7 (a)、(b) に示すように上記架台7に取付け固 定される固定板51を有する。この固定板51には可動 7

整機構53a~53cによって三次元方向に微調整可能 に設けられている。この可動板51にはアライメントラ メラ54が光軸を2方向に沿わせて設けられている。

[0037] 上記アライメントカメラ54はXYテーブル4上に吸着保持された基板6を機像する。アライメントカメラ54からの摄像信号は画像処理部55に入力されて処理され、その画像信号は上記制御装置30に入力される。

(0038)上記基板6の四周部には図2(b)に示すように十字状のアライメントマークmが形成されている。したがった、上記制即建設3のは上記画像処理部55からの画像信号を処理することで、上記基板6のXYテーブル4上における位置を検算する。この検算結果は、上記制制度施30において予め設定された設定値と比較され、その比較結果に差があれば、基板6にシール 羽を塗布するときに、上記XYテーブル4のXY方向の駆動の輸送が構定される。

[0039] つまり、XYテーブル4上に保持された基 板6の位置が一定でなくとも、XYテーブル4のXY方 向の駆動が補正されることで、上記基板6の定められた 20 位置にシール剤を塗布できるようになっている。

(0040)つぎに、上記構成の装篋によって基板6にシール剤を強布する手頭を脱引する。まず、XYテープルイが和別位配に位置決めされた状態でそのステージ5に基板66しくは基板6と同様の形状の基準基板)を載置、操作部40回開始スイッチ39をオンする。それによって、ステージ5に載置された基板6が真空吸着され、XYテーブル4はギャップ設定ボジションへ駆動される。ついで、スコープ上下機構9のスコープ35が下降し、ノズル体24下端部と基板6とを側方から撮像 30 オス

【0041】上記スコープ35からの画像はモニタ36 に表示される。このモニタ36には目盛37も同時に表示されるから、その目盛37によってノズル体24下端 面と基板6上面との間隔Gを目視によって確認すること ができる。

【0042】上記問隔には整布されるシール剤の幅寸法 するも と高さ寸法によって予め定められた値に設定される。た 第10 0 μmに設定される。つまり、モニタ36の画像を見な 40 れる。 がら上昇スイッチ41あるいは下降スイッチ42によっ てノズル体24を上昇または下降させ、上記問隔Gを 5のの

[0043] 間隔Gの設定が終了したら、設定スイッチ 43をオンすることで、設定された間隔Gが制御装置3 のに記憶される。ついで、キャリブレーションスイッチ 45をオンすることで、間隔Gが50μmのときの距離 検出センサ26のゼロボイントが自動的に捜されて制御 装置30に記憶される。つまり、基板6上面の第1の高 さ位置が記憶される。 [0044] つぎに、戻りスイッチ44をオンすること で、スコープ35が上昇し、XYテーブル4が初期位置 に戻る。開陽(の設定時に、甚板6に代わり、それと同様の基準基板を用いた場合には問題Gの設定後にXYテーブル4が初期位置に戻ったら、ステージ5から基準基 板を取り外し、シール剤を強布するための基板6に交換 する。

【0045】つぎに、シール剤を整布するために運転ス イッチ46をオンする。それによって、基板6がステー 10 ジ5に真空吸着されるとともに、その基板6をアライメ ントカメラ54が撮像する。撮像信号は画像処理部55 で処理され、その画像信号が新野装置30で演される ことで、アライメントマーグmのXY方向の位置が演算 される。この演算結果からステージ5上の基板6のXY 方向の機をが求められ、その位置が予め定められた設定 値と世をかまる。

【0046】上記基板6の実際の位置と、予め設定された設定値とに差があれば、シール剤の塗布時に、その差に応じてXYテーブル4の駆動が補正される。したがって、XYテーブル4がXY方向に駆動されるとともに、ノズル体24からシール剤が吐出されて塗布される際、基板6の保持状態(XY方向の積き)にかかわらず、上限基板6の予め定められた位置にシール剤を養布することができる。

【0047】基板6にシール剤を強布する際、距離検出 センサ26が基板6までの距離、つまり基板上面の第2 の高さ位置を検出し、その第2の高さ位置を制御装置3 の下予め設定されたゼロボイントである、第1の高さ位 置と比較する。

[0048] 上記第1の高さ位置と第2の高さ位置と先 差があれば、その美に応じて新御装置30からノズル上 下機構8のサーポモータ23に駆動信号が出力され、そ の差が0となる高さに、上記ノズル体24と距離検出セ ンサ26が一件的に設けられた可動体22を上下駆動する。

[0049] それによって、距離検出センサ26が検出 する基板6上面までの第2の高さ位置が予め設定された 第1の高さ位置(ゼロポイント)に一致するよう、上記 ノズル体24の高さが制御されながらシール剤が築布さ

[0050] つまり、基板6上面と、ノズル体24下端面との距離が一定に維持されながらシール剤が強力をあるので、基板6の厚さが一様でなかったり、たわんだりしていても、ノズル体24と基板6との間隔Gが一定になるよう補正されながらシール者が強布される。したがって、基板6に整布されるシール剤の幅寸法や高さ寸法にばらつきが生じるのを防止することができる。

[0051] この発明は上記一実施例に限定されるものでなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形可能で ある。たとえば、上記一実施例では基板上面とノズル体 9

下端面との間隔を設定する設定手段として、これらを側 方からスコープで撮像し、その画像から上記間隔を目視 で確認しながら上昇および下降スイッチを手動で操作し て設定するようにしたが、以下のようにして自動で行う こともできる。

【0052】つまり、スコープで基板とノズル体とを側 方から撮像した画像を画像処理部によって処理し、その 処理信号から基板とノズル体との間隔を算出する。ま た、制御装置には予め基準となる間隔を設定しておき、 その設定値と算出値とを比較し、その比較に基づいてサ 10 【図1】この発明の一実施例を示す概略的構成図。 ーポモータを駆動する。このようにすれば、手動で行っ ていた間隔の設定を自動で行うことができ、また上記一 実施例と同様、ノズル体を基板に接触させることなく行

[0.05.3] また、検出手段として1つの距離検出セン **サを用い、その1つの距離検出センサによって間隔を設** 定したときの基板上面の第1の高さ位置と、シール剤塗 布時における基板上面の第2の高さ位置との検出を行う ようにしたが、これら2つの検出を別々のセンサで行う ようにしてもよいこと勿論である。

#### [0054]

[発明の効果] 以上述べたようにこの発明は、ノズル体 先端と基板上面とを撮像し、その画像に基づいてノズル 体先端と基板上面との間隔を設定し、そのときの基板上 面の高さを第1の高さ位置として検出して記憶させると ともに、シール剤塗布時にシール剤が塗布される部分の 基板上面の高さを第2の高さ位置として検出し、その第 2の高さ位置を上記第1の高さ位置と比較し、その比較 に基づいてノズル体の高さを制御しながらシール剤を塗 布するようにした。

【0055】そのため、ノズル体を基板に接触させるこ となく、これらの間隔を設定することができ、また基板 の厚さが一様でなかったり、吸着保持されることでたわ みが生じるなどしてその上面の高さが部分的に変化して も、基板上面とノズル体下端との間隔が一定となるよう 補正されながらシール剤が塗布されるから、塗布された シール剤の幅寸法や高さ寸法を一定にすることができ る。

10

#### 「図面の簡単な説明】

[図2] (a) は同じくノズル体と基板との間隔を設定 するときのモニタ画面の説明図、(b)は同じく基板の 平面図。

[図3] 同じく制御装置に接続された操作部の説明図。 「図41 同じく途布装置の正面図。

【図5】(a)は同じくノズル上下機構の正面図、

(b) は同じく側面図。

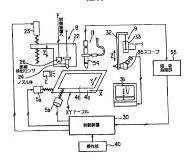
[図6] (a) は同じくスコープ上下機構の正面図、 (b) は同じく側面図。

20 【図7】 (a) は同じくアライメントカメラ調整機構の 正面図、(b)は同じく側面図。

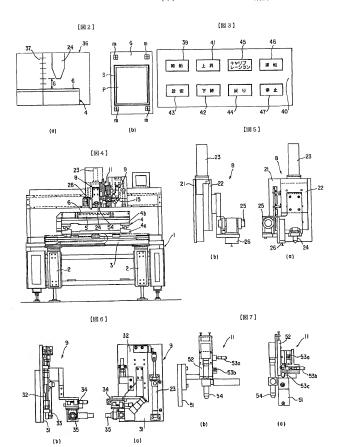
#### 【符号の説明】

4…XYテーブル、6…液晶用基板、9…スコープ上下 機構(撮像手段)、24…ノズル体、26…距離検出セ ンサ(検出手段)、30…制御装置(制御手段)、35 …スコープ(撮像手段)、36…モニタ(設定手段)、 40…操作部(設定手段)、41…上昇スイッチ(設定 手段)、42…下降スイッチ(設定手段)、43…設定 スイッチ(設定手段)。

30 [図1]



(7) 特開平8-94984





## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2003-222886

(43)Date of publication of application: 08.08.2003

(51)Int CI

GO2F 1/1341 1/13 G02F 1/1339

(21)Application number: 2002-020847 (22)Date of filing:

30.01.2002

(71)Applicant : CITIZEN WATCH CO LTD

(72)Inventor: TANAKA KATSUYUKI

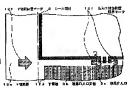
YOSHINO TAKESHI MURAMATSU KAZUTOSHI

# (54) LIQUID CRYSTAL DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a liquid crystal device wherein a liquid crystal injection port is perfectly sealed and whose cost is low.

SOLUTION: In the liquid crystal device wherein a liquid crystal upper substrate having a liquid crystal upper electrode and a liquid crystal lower substrate having a liquid crystal lower electrode are disposed so that the liquid crystal upper electrode and the liquid crystal lower electrode are opposed to each other, the gap part therebetween is closely sealed by a sealing member having the liquid crystal injection port for forming a liquid crystal cell part and a liquid crystal is encapsulated in the liquid crystal cell part, limitation marks of end positions of the injection port are provided near the injection port. The limitation marks of the end positions of the injection port are formed by using a transparent conductive film. The liquid crystal device has a color filter and the limitation mark of the end positions of the injection port is formed by using the color filter.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Searching PAJ 2/2 ページ

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

## (1)公開特許公報(A)

# (II)特許出願公開番号 特開2003 — 222886

(P2003-222886A) (43)公開日 平成15年8月8日(2003.8.8)

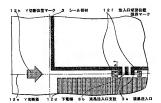
(51) Int. Cl.	識別記号	FΙ			7-7	J-1.	(参考)
G02F 1/1341		G02F 1/13	41		2H088		
1/13	101	1/13		101	2H089		
1/1339	505	1/1339		505			
		審査請求	未請求	請求項の数10	OL	(全)	0頁)
(21)出願番号	特顧2002-20847(P2002-20847)	(71)出顧人	00000196 シチズン	50 時計株式会社			
(22) 出顧日	平成14年1月30日(2002.1.30)		東京都西	東京市田無町の	7月1	番12号	}
		(72)発明者	田中 克	幸			
				東京市田無町7	7月1	番12号	シ
				計株式会社内			
		(72)発明者	吉野 武	-		m.or	
			.,	東京市田無町ス	∠1 目 T	番目で	i >
		(no) Parm dr		計株式会社内			
		(72)発明者	村松 一			75.40 F	
			.,	東京市田無町	41 B T	番12年	テン
			ナスン阿	計株式会社内			
					ñ	<b>最終</b> 頁	に続く
					-	~ ~	

### (54) 【発明の名称】液晶装置とその製造方法

#### (57) 【要約】

【課題】 液晶注入口の封止が完全であり低コストの液 品装置を得る。

【解決手段】 被晶上電報を有する液晶上基板と液晶下 電極を有する液晶下基板とを前記液晶上電板と前記液晶 下電板を対向させて双方の間に液晶セル部を構成するよ うに液晶柱入口を有するシール部材により密閉し該液晶 セル部に液晶を対止した液晶接硬において、前記往入口 に近接して注入口端部位置限界マークを設ける。前記注 入口端部位置限界マークは、透明棒電膜によって形成す る。また、前起液晶接端はカラーフィルタを有してお り、前記注入口端部位置限界マークがカラーフィルタに よって形成されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶上電極を有する液晶上基板と液晶下 電極を有する液晶下基板とを前記液晶上電極と前記液晶 下電極を対向させて双方の間に液晶セル部を構成するよ うに液晶注入口を有するシール部材により前記液晶セル 部を囲い該液晶セル部に液晶を封止した液晶装置におい て、 注入口端部位置限界マークを有することを特徴とす る液晶装置。

(請求項2) 前紀注入口端部位置限界マークは、前記 液晶注入口の側方の少なくとも一方に形成されているこ 10 に形成した液晶注入口の封止に関する。 とを特徴とする請求項1記載の液晶装置。

【満朮項3】 前記注入口端部位置限界マークは、前記 減品上基板あるいは液晶下基板の少なくとも一方に形成 されていることを特徴とする請求項1記載の液晶装置。 【請求項4】 前記注入口端部位置限界マークは、透明 導電膜によって形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項3のいずれか1項に記載の液晶装置。

「請求項5] 前記波晶装置はカラーフィルタを有して おり、前記注入口端部位置限界マークがカラーフィルタ によって形成されていることを特徴とする請求項1乃至 20 請求項3のいずれか1項に記載の被晶装置。

【請求項6】 前記注入口端部位置限界マークは、基 板の切断位置マークであるX切断位置マークおよびY切 断位置マークと同じ材料によって形成されていることを 特徴とする請求項4または請求項5に記載の液晶装置。 (請求項7) 前記注入口端部位置限界マークには、複数 の許容幅を有する液晶注入口端部の位置ずれの許容範囲 を示す部分が形成されていることを特徴とする請求項1 乃至請求項6のいずれか1項に記載の液晶装置。

【請求項8】 液晶上電板を有する液晶上基板の原板で 30 ある液晶上基板原板と、液晶下電極を有する液晶下基板 の原板である液晶下基板原板とを前記液晶上電極と前記 液晶下電極を対向させてシール部材により双方の間に液 品セル部を形成するように接合して液晶基板組立集合体 を構成し、該液晶基板組立集合体を切断して液晶基板組 立体を形成し、該液晶基板組立体の液晶注入口から液晶 セル部に液晶を充填して封止する液晶装置の液晶上基板 原板と液晶下基板原板とを接合する工程において、前記 液晶上基板あるいは液晶下基板の少なくとも一方に前記 注入口端部位置限界マークを形成し、前記注入口端部位 40 層限界マークが形成されている前記液晶上基板原板ある いは波晶下基板原板のいずれかに最初に前記シール部材 を接合することを特徴とする液晶装置の製造方法。

【請求項9】 前記注入口端部位置限界マークは、X切 断位置マークおよびY切断位置マークと同一工程で形成 することを特徴とする請求項8記載の液晶装置の製造方 法\_

【請求項10】前記注入口端部位置限界マークは、隣接 する演鳥其板細立体の電極の一部に形成することを特徴 とする請求項8記載の液晶装置の製造方法。

(発明の詳細な説明)

[0.001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶装置の構成に 関し、特に、海晶上基板の原板である液晶上基板原板と 液晶下基板の原板である液晶下基板原板との間をシール 部材によって液晶セル部を複数形成してシール部材によ り接着し液晶基板集合体を構成した後、該液晶基板組立 集合体を切断して液晶基板組立体を形成し、該液晶基板 組立体の液晶セル部に液晶を充填するためにシール部材

[0002]

[従来の技術] 従来における、液晶基板組立集合体を切 断して海晶基板組立体を形成し、該液晶基板組立体の液 晶セル部に液晶注入口から液晶を充填して封止して、こ の封止が完全であるか否かは封止を終わってから目視に より綸否を行っていた。

[0003] 図17、図18、図19、図20、図2 1、および図22を用いて従来例について説明する。図 17は、従来例における液晶基板組立集合体の一部をを 示す平面図である。図18は、図17に示す液晶基板組 立集合体を切断した液晶基板組立体の平面図である。図 19は、図18のE部矢視に示す液晶注入口503aを 封止部材508によって封止した状態を拡大して示す部 分詳細説明図である。図20は、図19と同様の部分に おける演品注入口503gの形状が不完全な状態を示す 部分詳細図である。図21は、従来例における液晶装置 501bとする前の液晶基板組立体501aの状態を示 す斜視図である。図22は、図19に示す封止前の液晶 基板組立体501aに液晶を充填した後封止部材508 によって封止して液晶装置501bとした状態を示す斜 視図である。

【0004】図17を用いて従来例における液晶基板組 立集合体511の概略の構成について説明する。液晶基 板組立集合体511は、下面に液晶上電極が形成されて いる液晶上基板原板と、上面に図示せぬ液晶下電極が形 成されている液晶下基板原板とを前記液晶上電極と前記 液晶下電極を対向させて双方の間にシール部材503に よって海昌セル郊を形成するように接合したものであ る。 波晶下基板原板には、液晶基板組立集合体 5 1 1 を 個別に分断するためのX切断線512mの目印となるX 切断位置マーク512hと、Y切断線512nの目印と なるY切断位置マーク512kが形成されている。

【0005】図18を用いて液晶基板組立体501aの 概略の構成について説明する。液晶基板組立体501a は、図17に示す液晶基板組立集合体511のX切断線 5 1 2 m および Y 切断線 5 1 2 n で切断したものであ り、シール部材503の一部に液晶注入口503aが形 成されている。図21に図18を斜め上方から見た状態 を示す。なお、図21は構造を理解しやすくするために 50 液晶基板組立体501aの厚さ方向の寸法を拡大して示 してある。

【0006】図19を用いて、図18のE部に矢視で示 した液晶注入口503aを封止部材508によって封止 した状態を説明する。液晶基板組立体501aの液晶注 入口503aから液晶を注入した後、封止部材508に よって液晶注入口503aを封止する。図22に図19 を斜め上方から見た状態を示す。なお、図22は構造を 理解しやすくするために液晶装置501bの厚さ方向の 寸法を拡大して示してある。

3

[0007] 図20を用いて、形状不良の液晶注入口5 10 03aを封止部材508によって封止した状態を説明す る。シール部材503によって形成された液晶注入口5 03aの2箇所の壁部の少なくとも一方が切断線の位置 まで届かない形状不良であった場合、液晶注入口503 aから液晶基板組立体501aのセル部に液晶を注入し た後、封止部材508によって形状不良の被晶注入口5 03aを封止した場合には、液晶注入口503aと封止 部材508との間に隙間ができて、その隙間からセル部 に注入した液晶が矢印 c のように流出する。従って、こ のように形状不良の液晶注入口503aを持った液晶基 20 板組立体501aは、液晶を注入する前に不良品として 廃棄する必要がある。上記および以下の説明では液晶注 入口支柱(例えば図7参照)を示したが、本願発明は液 品注入口支柱の有り無しに関わらず、適用できるもので ある。

#### [8000]

【発明が解決しようとする課題】従来の液晶装置におい ては、シール部材によって形成された液晶注入口が形状 不良で、液晶注入口と封止部材との間の隙間から液晶の 流出や、液晶注入時に十分な真空注入を行えない問題を 30 生じる。このような場合、液晶基板組立体は、製造工程 が進んで最終製造工程となる液晶注入工程の前に不良品 として廃棄することになり、それまでの製造コストをす べて無駄にすることになるので無駄が多く、液晶装置の コストを高いものにしていた。

[0009] 本発明の目的は、液晶注入口の封止が完全 であり低コストの液晶装置を得ようとするものである。 [0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明においては、液晶上電極を有する液晶上基板 40 と液晶下電極を有する液晶下基板とを前記液晶上電極と 前記液晶下電極を対向させて双方の間に液晶セル部を構 成するように液晶注入口を有するシール部材により前記 液晶ヤル部を囲い該液晶セル部に液晶を封止した液晶装 置において、前記液晶注入口に近接して注入口端部位置 限界マークを有することを特徴とするものである。 【0011】また、前記注入口端部位置限界マークは、

前記液晶注入口の側方の少なくとも一方に形成されてい ることを特徴とするものである。

前記液晶上基板あるいは液晶下基板の少なくとも一方に 形成されていることを特徴とするものである。

【0013】また、前紀注入口端部位置限界マークは、 透明邁霞際によって形成されていることを特徴とするも のである。

[0014] また、前記液晶装置はカラーフィルタを有 しており、前記注入口端部位置限界マークがカラーフィ ルタによって形成されていることを特徴とするものであ

【0015】また、前記注入口端部位置限界マークは、 其板の切断位置マークであるX切断位置マークおよびY 切断位置マークと同じ材質によって形成されていること を特徴とするものである。

【0016】また、前記注入口端部位置限界マークに は、複数の許容幅を有する液晶注入口端部の位置ずれの 許容範囲を示す部分が形成されていることを特徴とする ものである。

【0017】また、液晶上電極を有する液晶上基板の原 板である液晶上基板原板と、液晶下電極を有する液晶下 基板の原板である液晶下基板原板とを前記液晶上電極と 前記液晶下電極を対向させてシール部材により双方の間 に液晶セル部を形成するように接合して液晶基板組立集 合体を構成し、 診液品基板組立集合体を切断して液晶基 板組立体を形成し、該液晶基板組立体の液晶注入口から 液晶セル部に液晶を充填して封止する液晶装置の液晶上 基板原板と液晶下基板原板とを接合する工程において、 前記液晶上基板あるいは液晶下基板の少なくとも一方に 前記注入口端部位置限界マークを形成し、前記注入口端 部位置限界マークが形成されている前記液晶上基板原板 あるいは液晶下基板原板のいずれかに最初に前記シール 部材を接合することを特徴とするものである。

【0018】また、前記注入口端部位置限界マークは、 X切断位置マークおよびY切断位置マークと同一工程で 形成することを特徴とするものである。

【0019】また、前記注入口端部位置限界マークは、 隣接する海晶基板組立体の電極の一部に形成することを 特徴とするものである。

[0020]

【発明の実施の形態】以下発明の実施の形態を実施例に 基づき図面を参照して説明する。図1は、本発明に係る 第1実施例における液晶を充填した後封止部材8によっ て封止した液晶装置 1 bを示す斜視図である。図 2 は、 液晶基板組立集合体を分断して図1に示す液晶装置1 b を得る前の液晶基板組立集合体11の構成を示す斜視図 である。図3は、図2に示す液晶基板組立集合体11の 上面から見た状態を示す上面図である。図4は、図3に 示す液晶基板組立集合体11の液晶上基板原板14を、 シール部材3がすでに配設されている液晶下基板原板1 2 に接着する状態を示す説明図である。図5は、図3に 【0012】また、前記注入口端部位置限界マークは、 50 示す液晶基板組立集合体11を構成する前の液晶下基板 5

原板12を示し、(a) は上面から見た状態を示す上面 図、(b) は右側面図である。図6は、図5に示すB矢 根部の状態を拡大して示す詳細図である。図7は、図6 に示すC矢視部の状態を拡大して示す部分詳細図であ る。図8は、図6に示すD矢視部の状態を拡大して示す 部分詳細図である。

【0021】図9は、図3に示すA矢視部の状態を拡大 して示す詳細図である。図10は、図9に示す施品基板 担立業合体11を分所して破品素板組立体10に示すE矢視 10 総を示す上面図である。図11は、図10に示すE矢視 10 総を示す上面図である。図11は、図10に示すE矢視 10 図11と同様の部分における液晶法入口3 aの形状が不 完全な比能を示す部分詳細図である。図13は、図7と 円様の部分における第2歩施例の状態を示す部分詳細図 である。図14は、図7と同様の部分における第3実施 例の状態を示す部分詳細図である。図15は、第3実施 図における液晶基板組立集合体21の構成を示す結構 図である。図16は、図15に示す液晶基板組立集合体 211の財面の状態を拡大して示す斯面詳細図であるが、20 21が透明、2016は、2016に示すを正確をは 21に対象の表を指数している。2016は「21が振明、2016」

【0022】図1において、本発明に係る第1実施例の 該品接置1もの興路の順成とついて説明する。液晶接置 1 bは、下断に図示せぬ液晶上電板が形成されている液 品上基板4と、上面に図示せぬ液晶上電板が形成されて いる液晶下落板2とを前記液晶上電板と前記液晶下電極 を対向させて双方の間にシール部材3によって液晶セル 部を形成する5-15に接合し、旅船主入口3 あら前記液 品セル部に液晶を充填して封止部材8によって対止した ものである。液晶下基板2には、後述する液晶基板組立 体1 aを分断するときのための注入口端部位置限界マー 30 ク12 fが形成されている。

【0023】図2、および図3において、図1に示す被 品装置10を分断する前の液晶基板組立集合体11の構 成について説明する。液晶基板組立集合体11は、下 面に図示せ油液晶上電板が形成されている液晶上基板原 板14と、上部に図示せ油液面で電板が形成されている液晶上基板原 板14と、上部に図示せ油液面で電板が形成されている液晶上基板原 板14と、と前に図示せ油液面で電板が形成されている液晶上基板原 板12とを前記液晶上電板と前記液晶下電 極を対向させて双方の間にシール形材 3によって液晶セ ル節を形成するように接合したものである、磁面下基板 40 原板12には、液晶基板組立体1aのアドレスを表示するXアドレスマーク12gとソアドレスマーク12gとアドレスマーク12j、 および液晶基板組立集合体1を図別に分断上で図10 に示す液晶基板組立体1aを得るときの目印となるX切 新位置マーク12hとY切断位置マーク12kが形成されている。

[0024] 図3において、液晶基核組立集合体11の の範囲外であった場合には、後工程により液晶注入口3 機路の構成を説明する。図示せぬ液晶上機極を有する液 高上基板原板14と液晶下電極を有する液晶下基板原板 12とを部記液晶上電板と帆配液構下電極を対向させて 50 ので、この皮障で光学的あるいは目視により不良品と判

シール部材3により接着して双方の間に液晶セル部を構成している。

【0025】図4において、液晶下基板原板12と液晶 上基板原板14を接着して液晶基板組立集合体11を構 成する状態について説明する。上面にXアドレスマーク 12gとYアドレスマーク12jおよびX切断位置マーク 212hとY明節位置マーク12kが成され、シール 部材3が接着されている液晶干板原板12k線合札 基板原板14の下面を接着して液晶基板組立集合体11

【0026】 図5において、液晶下基板原板12の概略 の構成を説明する。液晶下基板原板12の上面には、X アドレスマーク12g とYアドレスマーク12 j および X切断位置マーク12 h と Y 切断位置マーク12 k が 形 成され、シール部材3 が後着されている。

【0027】図6、および図7において、液晶下基板原 板12の構成を更に説明する。液晶下基板原板12の上 面には、X切断位置マーク12hとY切断位置マーク1 2 k、電極12d、および注入口端部位置限界マーク1 2 f が透明導電膜によって形成され、さらにシール部材 3が配設されている。シール部材3の一部には液晶注入 口3aが形成されている。液晶注入口3aの中央部には 液晶注入口支柱3万が接着されている。この液晶注入口 支柱3 b は液晶下基板原板12と液晶上基板原板14と の間隔を維持するために補強部材であるが必要不可欠の ものではなく省略することも可能である。注入口端部位 置限界マーク12fは、Y切断位置マーク12kが指示 する Y 切断線 1 2 n の線上であると共に液晶注入口 3 a の面临に形成されている。注入口端部位置限界マーク1 2 f は、液晶注入口3 a の端部の位置ずれの許容範囲を 示す許容幅 8 1 を示している。

【0028】上流したように、往入口場解砂度限界マーク12 fは、火切所位置マーク12 hはよび火切所位置マーク12 hおよび火切所位置マーク12 kと共に透明導電線によって同一工程で形成したので、注入口端部位置現界マーク12 f を作成するための工程を別に設けることは不要であると共に、X切所位置マーク12 kに対する位置特度を高精度に形成することができる。なお、未実施例においては、X切断位置マーク12 kに対する位置マーク12 k、および往入口端部位置限界マーク12 f は液晶下基板原板 12 の上面に形成したが嵌温上基据照板 12 の上面に形成したが嵌温上基据照板 12 の上面に形成したが嵌温上基据照板 12 の上面に形成したが嵌温上基据照板 14 の下面でもよい。

(0029) 図8において、極層注入口3a形状不具の 場合について説明する。図8に示すようにシール部材3 によって形成された2箇所の被晶注入口3aの少なくと も一方が注入口端部位置限界マーク12fの許可幅の の範囲外であった場合には、後工程により液晶注入口3 を封止したときに、封止を完全にすることができず に、液晶セル内に充填した液晶が漏洩するおそれがある 7

定してこのアドレス(基板上の位置)の液晶基板組立体 1 aを、現物あるいは別の配限装置にマークしておき切 筋分離の後廃棄する。上記および以下の説明では液晶注 入口支柱を示したが、本瀬発明は液晶注入口支柱の有り 無しに関わらず、適用できるものである。

[0031] 図10において、図9に示す液晶基度超立 20 集合体 11を分断して液晶基板組立体 1aとした状態に ついて説明する。シール部材 3の一部には液量柱入口3 aが形成されており、注入口端部化面限界マーク 12 f が形成されてある。この後、液晶上入口3 aから液晶を 充填して対は能材 8によって対止する。

[0032] 図11において、液晶基板組立集合体11 に液晶を充填して液晶注入口3 aを封止部材8によって 封止した状態について説明する。シール部材3の一部に は液晶注入口3aが形成されており、注入口端部位置限 界マーク12 fが形成されているが、液晶注入口3 aの 30 端部が、図11に示すように注入口端部位置限界マーク 12 f の許容幅 a 1 の中にある場合には、液晶注入口3 a を封止部材5によって完全に封止することができる。 【0033】図12において、液晶注入口3aの端部が 注入口端部位置限界マーク12 f の許容幅 a 1 から外れ ている場合に、液晶基板組立集合体11に液晶を充填し て液晶注入口3 aを封止部材8によって封止した状態に ついて説明する。シール部材3の一部には液晶注入口3 aが形成されており、注入口端部位置限界マーク12 f が形成されているが、液晶注入口3 a の端部が、図12 40 に示すように注入口端部位置限界マーク12fの許容幅 a1から外れている場合には、液晶注入口3aを封止部 材8によって完全に封止することができず、充填した液 晶は矢印bのように漏洩してしまう。

【0034】図13において、第2束施例における液晶 下基板原板112の構成を説明する。液晶 F基板原板1 12の上順には、その一部に液晶柱入口103 aが形成 されているシール部材103が接着されていると共に、 切断位置マーク112k、下電機102d、および往 入口端部位置限界マーク1112 fが形成されているが、 住入口端部位置限界マーク112 fは隣接する液晶基板 組立体1 aの下電板102 dの一部に形成されている。 た入口端格化原界マーク112 ft、液晶注入口10 3 aの端部の位置ずれの許容範囲を示す許容種a1を示 している。液晶基板組立体101 aの注入口端部位置限 界マーク112 fが廃接する液晶基板組立体101aの下電極102 dと近接している場合には、上述のよう に、隣接する液晶基板組立体101aの下電極102 d の一部に注入口端部位置限界マーク112 fを形成する ことによって容易に形成することができる。

【0035】図14において、第3実施例における液晶 下基板原板212の構成を説明する。液晶下基板原板2 12の上面には、その一部に液晶注入口203aが形成 されているシール部材203が配設されていると共に、 Y切断位置マーク212k、下電極202d、および注 入口端部位置限界マーク212fが形成されている。注 入口端部位置限界マーク212fは、液晶注入口203 aの端部の位置ずれの許容範囲を示す許容幅 a 2、 a 3、a4、およびa5を示す部分が形成されている。注 入口端部位置限界マーク212 fが許容幅 a 2、 a 3、 a4、およびa5を持っていることにより、後で行われ る封止工程においてその許容できる範囲が大きい場合に は許容幅a5によって液晶注入口203aの端部の位置 ずれの合否を判定し、許容できる範囲が小さい場合には 許容幅a2によって液晶注入口203aの端部の位置ず れの合否の判定を行う。従って、封止の技術が向上すれ ばそれに応じて液晶注入口203aの端部の位置ずれに 対する精度の要求は低くすることができる。

【0036】関15において、第3実施例における液晶 接版2016の機路の構成について説明する、線晶接距 201bは、線晶下基板202と線晶上基板204と 双方の間にシール部材203によって接合されて液晶セ ル部が形成され、接線晶セル部には液晶性入口203a から液晶が充填され、液晶は入口203aは在入口場部 位置限界マーク212 fによって封止されている。

【0037] 図16において、液晶装置201bの所面 構成について説明する、液晶下基板202と液晶上基板 204との間に形成されている設晶とル部には減温20 7が充填されている、液晶下基板202は、ガラス等の 週明な材質によって形成されている下透明基板202 0上面には、カラーフィルク202b、保護膜202

c、下電極202d、下配向限202eが順次機器形成されている。また、液晶上基板204は、ガラス等の透 明な材質によって形成されている上透明基板204aの 下面には、上電標204b、上配向限204cが配次積 服形成され、上面には、位相差緒正板205. 個光板2 06が順次機器形成され、たている。

[0038] 前述した第1実施例では、注入口端部位置 限界マーク12fは透明導電膜によって形成されていた 50 が、本第3実施例においてはカラーフィルタ202bに よって形成されている。注入口端部位置限界マーク21 2 fと同様にX切断位置マーク212hおよびY切断位 置マーク212kもカラーフィルタ202bによって同 一工程で形成することにより、注入口端部位置限界マー ク212fを作成するための工程を別に設けることが不

要であると共に、X切断位置マークおよびY切断位置マ 一ク212kに対する位置精度を高精度に形成すること ができる。 【0039】注入口端部位置限界マークを用いて注入口

端部位置の良否を確認するのは、新機種やロットが変わ 10 集合体の構成を示す斜視図である。 った時や液晶装置の機種の切り替え時や、印刷スクリー ンを交換したとに、試験的に製造し(試流し)、液晶注 入孔の印刷位置を確認してから量産製造を行うのがよ

### 44. [0040]

[発明の効果]上述のように、本発明によれば、シール 部材によって形成された液晶注入口が形状不良で、液晶 注入口と封止部材との間の隙間から液晶が流出や注入時 に十分な真空注入できない不良に対して、液晶基板組立 体は、切断分離する前の液晶基板組集合体の状態で合否 20 判定ができるので、液晶注入後において、液晶装置を無 駄にすることがなく製造コストを低く抑えることがで

き、液晶装置のコストを低く抑えることができる。さら に、単個の液晶装置における液晶注入孔不良の選別も容 易に出来るため、不良品が市場にでることを防ぐことが より正確に判断できる効果を有する。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る第1実施例における液晶を充填し た後封止部材によって封止した液晶装置を示す斜視図で ある。

【図2】図1に示す液晶装置を分断する前の液晶基板組 立集合体の構成を示す斜視図である。

【図3】図2に示す液晶基板組立集合体の上面から見た 状態を示す上面図 (a) と側面図 (b) である。

[図4] 図3に示す液晶基板組立集合体の液晶上基板原 板に、シール部材が配設されている液晶下基板原板を接

着する前の状態を示す説明図である。 【図5】図3に示す液晶基板組立集合体11を構成する 前の液晶下基板原板を示し、(a)は上面から見た状態

を示す上面図、(b) は右側面図である。 【図6】 図5 に示すB矢視部の状態を拡大して示す詳細

図である。 【図7】図6に示すC矢視部の状態を拡大して示す部分

詳細図である。

【図8】図6に示すD矢視部の状態を拡大して示す部分 詳細図である。

【図9】 図3に示すA矢視部の状態を拡大して示す詳細 図である。

【図10】図9に示す液晶基板組立集合体を分断して液 晶基板組立体とした状態を示す上面図である。

1.0 【図11】図10に示すE矢視部の状態を拡大して示す 部分詳細図である。

【図12】図11と同様の部分における液晶注入口の形 状が不完全な状態を示す部分詳細図である。

【図13】図7と同様の部分における第2実施例の状態 を示す部分詳細図である。

【図14】図7と同様の部分における第3実施例の状態 を示す部分詳細図である。

【図15】図15は、第3実施例における液晶基板組立

【図16】図16は、図15に示す液晶基板組立集合体 の断面の状態を拡大して示す断面詳細図である。

【図17】従来例における液晶基板組立集合体の一部を

を示す平面図である。 【図18】図17に示す液晶基板組立集合体を切断した 液晶基板組立体の平面図である。

【図19】図18のE部矢視に示す液晶注入口を封止部 材によって封止した状態を拡大して示す部分詳細図であ る。

【図20】図19と同様の部分における液晶注入口の形 状が不完全な状態を示す部分詳細図である。

【図21】従来例における液晶装置とする前の液晶基板 組立体の状態を示す斜視図である。

【図22】図19に示す封止前の液晶基板組立体に液晶 を充填した後封止部材によって封止して液晶装置とした 状態を示す斜視図である。

#### 【符号の説明】

1 液晶装置

1 a 液晶基板組立体

1b、201b 液晶装置

11 液晶基板組立集合体

2. 202 液晶下基板

12.112、212 液晶下基板原板

2028 下透明基板

202b カラーフィルタ

202c 保護膜

2 d、 102 d、202 d 下電極

202e 下配向膜

40 7

12 f、112 f、212 f 注入口端部位置限界マー

12g Xアドレスマーク

12h X切断位置マーク

12 | Yアドレスマーク

12k、112k、212k Y切断位置マーク

12m X切断線

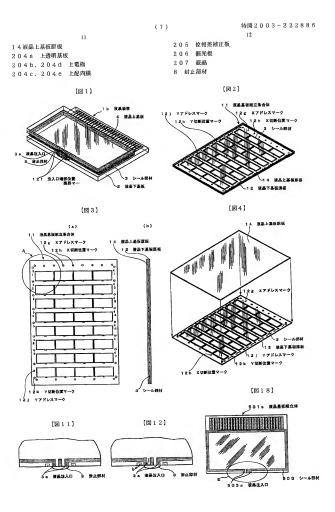
12n Y切断線

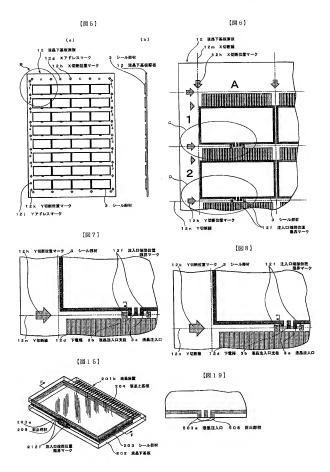
3、103、203 シール部材

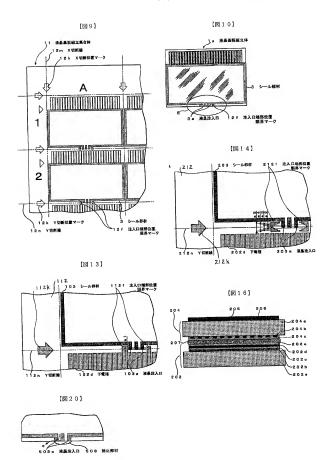
3 a. 103 a. 203 a 液晶注入口

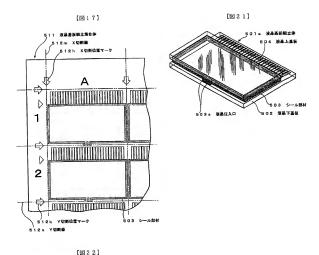
3 b 液晶注入口支柱

50 4、204 液晶上基板









501 放走原程 503 放走原程 503 放走原程 503 放走原程 503 放走原程 503 放走原程

フロントページの続き

ドターム(参考) 2H088 FA01 FA06 FA10 FA14 FA26 HA02 HA12 MA20 2H089 LA22 NA19 NA25 NA37 NA41 QA12 TA02 TA12



## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-110489

(43) Date of publication of application: 25.04.1995

(51)Int.CI.

G02F 1/1341

(21)Application number: 05-253916

(71)Applicant : ROHM CO LTD

(22)Date of filing:

12 10 1993

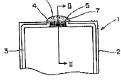
(72)Inventor: ONO KOICHI

## (54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase the fixing strength of a sealing material for sealing a liquid crystal injection port by a simple means and to improve hermeticity by directly and securely forming a projecting part in the region of the liquid crystal injection port on a transparent substrate, then sealing this projecting part so as to embed the projecting part with the sealing material.

CONSTITUTION: The sealing material 3 is formed between two sheets of the transparent substrates 2 so as to go along the peripheral edge of the transparent substrate 2 and constitute a terminal part 4 terminating toward one peripheral 3 edge side of the transparent substrates 2. Both transparent substrates 2 are stuck to each other via this sealing material 3. The liquid crystal injection port 5 is delineated by the terminal part 4 of the sealing material 3 between both transparent substrates 2 and the inside and outside of the element are made communicatable via the liquid crystal injection port 5. The projecting part 6 is formed to a band shape along the one peripheral edge side of the transparent



substrates 2 on the surfaces of the respective transparent substrates 2 facing the liquid crystal injection port 5. The liquid crystal injection port 5 is sealed to embed the projecting part 6 by dropping and curing the sealing material 7 so as to seal the liquid crystal material packed in the element.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



(19)日本国特許庁 (JP) (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-110489

(43)公開日 平成7年(1995)4月25日

(51) Int. Cl. " G02F 1/1341 識別記号

FΙ

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全4頁)

(21)出願番号 (22)出願日

特願平5-253916

平成5年(1993)10月12日

(71)出題人 000116024

ローム株式会社

京都府京都市右京区西院溝崎町21番地 (72)発明者 小野 耕一

京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株

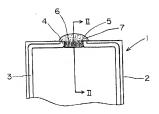
式会社内

(54) 【発明の名称】液晶表示素子の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 液晶注入口を封止する封止材の固着強度を増 大させ、気密性を向上させる。

【構成】 透明基板上の液晶注入口の領域に凸状部を形 成し、封止材により凸状部を埋めるように封止する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】透明電極を有する2枚の透明基板の周縁辺 に沿って設けられ前記両透明基板を相互に貼合わすシー ル材と、前記透明基板間に充填された液晶材とを有する 液晶表示素子の製造方法であって、前記シール材を前記 透明基板の1辺部にて終端する終端部を有するように形 成し、前記両透明基板の貼合わせにより前記シール材の 終端部により前記诱明基板間に前記素子の内外を連通さ せる液晶注入口を画成し、前記透明基板上の前記液晶注 入口の領域に凸状部を形成し、前記素子の内部へ液晶材 10 を充填後、前記液晶注入口を封止するための封止材を用 いて前記凸状部を埋めるように封止することからなるこ とを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【請求項2】前記凸状部は前記透明基板の透明電極と共 通の工程で形成する請求項1に記載の液晶表示素子の製 造方法。

【請求項3】前記凸状部は前記透明基板の前記液晶注入 口が形成された一周縁辺に実質上平行に帯状に形成され る請求項1に記載の液晶表示素子の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

[産業上の利用分野] 本発明は、液晶を注入した後に封 止材を用いて液晶注入口を封止する封止工程を含む液晶 表示素子の製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、表面上に透明電極を所要の形状に パターニングし、これにさらにポリイミド等からなる配 向離を積層形成した透明基板を、シール材を介して一定 の間隔離間させて、透明基板間に液晶材を注入させてな る液晶表示素子が知られている。この種の素子では、図 30 4 及び図5 に示すように、2 枚の透明基板A間にエポキ シ系樹脂等からなるシール材Bを透明基板の各周縁辺に 沿い、且つ、透明基板の一周縁辺近傍に素子の内外を連 通させる開口としての液晶注入口Cを形成するようスク リーン印刷等により塗布後、素子の両透明基板の側面を 加圧した状態でシール材を加熱硬化させて両透明基板を 貼合わしている。このように形成された空状態の素子に 液晶注入口を介して液晶材を充填後、封止材を液晶注入 口C上へ滴下させ、液晶注入口C内へ所要量入り込ませ た後、これを硬化させることにより素子の封止を行って 40 いる。

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来の製 造方法による液晶表示素子では、硬化後の封止材Dは、 図4に示すように、平坦な表面の2枚の透明基板A間に 挟着されているにすぎないため、封止材Dは液晶注入口 Cへ入り込んだ方向(以降単に「入り込み方向」と呼 ぶ)に対し固着強度が充分でなく、封止の信頼性に満足 が得られるものでなかった。

止材の滴下は、液晶注入口Cを介した液晶材の注入後に 行われるのだが、液晶材注入直後には液晶注入口Cは液 品材で濡れた状態にある。そのため、上記従来の方法で は、液晶材で濡れて、且つ平坦に形成された液晶注入口 C内に封止材を固着しているので、封止材Dの透明基板 Aに対する充分な固着強度を得ることができず、封止後 に素子内へ外部から空気が侵入してしまう問題があっ た。

【0005】従って、本発明の目的は、簡易な手段によ り、液晶注入口を封止する封止材の固着強度を増大さ せ、かつ気密性を向上させた液晶表示素子の製造方法を 提供することである。

### [0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を達成するた め、本発明によれば、透明電極を有する2枚の透明基板 の周縁切に沿って設けられ両透明基板を相互に貼合わす シール材と、透明基板間に充填された液晶材とを有する 液晶表示素子の製造方法であって、シール材を透明基板 の1辺部にて終端する終端部を有するように形成し、両 20 透明基板の貼合わせにりシール材の終端部により透明基 板間に素子の内外を連通させる液晶注入口を画成し、透 明基板上の液晶注入口の領域に凸状部を形成し、素子の 内部へ液晶材を充填後、液晶注入口を封止するための封 止材を用いて凸状部を埋めるように封止することからな ることを特徴とする液晶表示素子の製造方法が提供され

[0007]上記凸状部は透明基板の透明電極と共通の 工程で形成することができる。上記凸状部は透明基板の 液晶注入口が形成された一周縁辺に実質上平行に帯状に 形成できる。

## [8000]

[作用] 透明電極の透明基板上への形成時に、凸状部を 透明基板上の液晶注入口の領域に直接且つ強固に形成し た後、封止材でこの凸状部を埋めるように封止するの で、封止材はその入り込み方向に対して強固に固着す る。また、凸状部が封止材の入り込み方向に対して略直 角方向に延在するので、これが素子外部からの空気の侵 入に対し防壁として作用し、空気の侵入を有効に防止す る。

#### [00009]

【実施例】以下に、本発明の実施例を図面を参照しなが ら詳細に説明する。図1は本発明の方法による液晶表示 素子の要部の平面図であり、図2は図1中線II-IIに沿 う断面図である。本発明の液晶表示素子1は、従来の液 晶表示素子と同様に、2枚の透明基板2からなり、各透 明基板2上には透明電極膜(以下「ITO膜」と云う) からなる透明電極2'が所要の形状にパターニング形成 されている。透明基板2上には更に、透明電極2'を覆 うように、配向膜2"がポリイミドにより形成される。 【0004】更に、上述のように、液晶注入口Cへの封 50 両透明基板2間にはシール材3が透明基板2の周縁辺に 沿い、且つ透明基板の一周縁辺に向けて終端する終端部 4 を成するように形成され、このシール材3を介して両 透明基板は相互に貼合わされる。両透明基板2間にはシ **ール材3の終端部4により液晶注入口5が画成され、こ** の液晶注入口5を介して素子の内外が連通可能となる。 各誘明基板2の液晶注入口5を臨む面上には、凸状部6 が透明基板2の上記一周縁辺に沿って帯状に形成されて いる。この凸状部6は一本のみ形成してもよいが、複数 本平行状に形成すればより本発明の効果を得やすい。液 晶注入口5は素子内部に充填された液晶材を封止すべ く、封止材7を滴下及び硬化させることにより、凸状部 を埋めるように封止される。

[0010]次に、本発明の液晶表示素子の製造方法に ついて説明する。まず、各透明基板2に透明電極を形成 するのだが、このとき透明基板2の液晶注入口5を臨む 領域に凸状部6を同時に形成する。この透明電極2'及 び凸状部6は、例えばITO膜により500乃至200 0°Aの層厚に透明基板2上全面に蒸着法により形成 後、所要のパターンにエッチングすることにより形成す る。凸状部6は上述のように透明基板2の一周縁辺に沿 20 って帯状に形成するのだが、その幅寸法は特に限定され るものではないが、液晶注入口5の入り込み方向の長さ が、例えば3mmの場合、例えば1mm幅に形成すれば よい。このように透明電極及び凸状部6を形成した透明 基板2に、更に透明電板2'を覆うようにポリイミドか らなる配向膜2"を積層形成する。配向膜2"の形成 後、熱硬化性樹脂からなるシール材3を一方の透明基板 2上にその周縁辺に沿い、且つ透明基板2の一周縁辺に 向けて終端する終端部4を有するようにスクリーン印刷 により形成する。このように構成した2枚の透明基板2 30 を相互に貼合わすことにより、両透明基板2間にシール 材の終端部4により液晶注入口5が画成され、この液晶 注入口5を介して素子の内外が連通する空素子を得る。 【0011】空素子内に、公知の方法により液晶材を充 填後、素子の透明基板2の外即面に圧力を印加した状態 で、内部に封止材としてのUV硬化性樹脂を収納したノ ズル付きのデイスペンサ (図示せず) を用いて、一定量 の封止材を素子の液晶注入口5上に滴下する。封止材の 滴下後、印加圧力を解除することにより封止材7は液晶 注入口5を介して素子の内部へ入り込む。このとき、封 40 4 . . . シール材の終端部 止材7を液晶注入口5の凸状部6を埋めるまで入り込ま せる。封止材が一定量液晶注入口5内へ入り込ませた 後、封止材7に紫外線を照射することにより、封止材を

硬化させて、本発明の製造方法による液晶表示素子が得 られる。

[0012] 図3は本発明方法による液晶表示素子の変 形例を示す。図3 (a) は凸状部を、対向する凸状部に 対して封止材の入り込み方向へずらせた位置に形成した 例を示す。このように凸状部を構成することにより、封 止材の液晶注入口への入り込みはより容易となる。ま た、図3 (b) に示すように、凸状部をその両端が素子 の内方へ向くように透明基板上に円弧状に形成すれば、 10 封止材の入り込み方向に対するより強固な固着強度を確 保でき、より封止の信頼性を向上できる。

### [0013]

[発明の効果] 以上、詳細に説明したように、本発明の 液晶表示素子の製造方法によれば、液晶注入口の封止は 液晶材で未だ濡れていない透明基板上に直接且つ強固に 形成した凸状部を、封止材により埋めるように素子の封 止を行うので、封止材の入り込み方向に対する固着強度 を大幅に増大させることができる。更に、凸状部は入り 込み方向と略直角方向に帯状に形成されるので、素子外 部からの空気の混入を防止する防止壁として作用するの で、封止の気密性を大幅に向上させることができる。ま た、本発明の方法によれば、凸状部は上述のように、特 別な工程を要することなく、透明電極と共通の材料及び 工程で簡易に設けることができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の製造方法による液晶表示素子の要部の 基板内面側視平面図である。

【図2】図1の液晶表示素子の線II-IIに沿う断面図で

【図3】本発明の製造方法による液晶表示素子の変形例 【図4】従来の方法による液晶表示素子の基板内面側視

平面図である。 【図5】図4の液晶表示素子の線III-IIIに沿う平面図

である。 【符号の説明】

### 1 、... 液晶表示素子

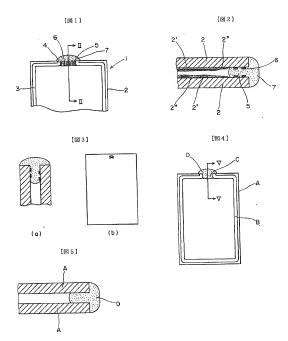
诱明基板 2 . . .

3 . . . シール材

5 、 . . 液晶注入口

6 . . . 凸状部

7 . . . 封止材





## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2002-174819

(43)Date of publication of application: 21.06.2002

(51)Int.CI.

H01L 49/02

(21)Application number: 2000-374301 (22)Date of filing:

08.12.2000

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(b)

(72)Inventor · KOBAYASHI MASAKI KODERA TAKUMI

### (54) METHOD FOR PRODUCING ELECTROOPTICAL DEVICE, ELECTROOPTICAL DEVICE AND ELECTRONIC APPLIANCE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing electrooptical device which easily inspects the cutting position with respect to an original substrate, fills an electrooptical substance in between substrates from a filling port and, thereafter, applies sealing material for the filling port in a proper range, an electrooptical device and an electronic appliance using the electrooptical device.

SOLUTION: Marks 100 having a width corresponding to tolerance at the time of cutting is formed on the original (c) substrate for an element substrate which constitutes a liquid crystal device so as to overlap a predetermined line L11. Therefore, if one part of the marks 100 respectively remains on both sides of cut place when the original substrate is cut along the predetermined line L11, it is judged that the cutting is performed with the precision in tolerance. Therein, the liquid crystal filling port 6a is opened between the marks 100 on the cut place and, therefore, no trouble due to the quantity of





the sealing material 60 occurs by applying the sealing material 60 so as not to reach the marks 100 after filling the liquid crystal.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of 22 03 2004

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

Searching PAJ 2/2 ページ

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



## (19)日本国特許庁 (JP) (12)公開特

## (12)公開特許公報 (A)

## (II)特許出願公開番号 特開2002-174819

(P2002-174819A) (43)公開日 平成14年6月21日(2002.6.21)

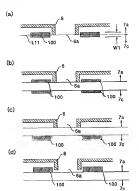
(21) 出願番号 特顧2000-374301 (P2000-374301) (71) 出額人 000002369		
CO2F   1/1341   2H039   1/1333   500   2H1090   1/1333   500   2H1090   1/1365   2H1090   1/1365   2H1090   1/1365   2H1090   1/1365   2H1090   2H1090	(参考	
1/1333   500   1/1333   500   24000     1/1365   24000   1/1365   24000     1/1365   24000   338   56435     343   343   2     審密請求 未請求 請求項の数:9 OL (全17頁) 最終頁		
1/1365		
CO9F     9/00     338     CO9F     9/00     338     5G435       343     343     2       審容請求     未請求     請求項の数19     OL     (全17頁)     最終頁		
343 Z 第空請求 未請求 請求項の数19 OL (全17頁) 最終頁 (21)出願番号 特額2000-374301(下2000-374301) (71)出願人 000002369		
**查請求 未請求 請求項の数19 OL (全17頁) 最終頁 (21) 出腳番号 特顯2000-374301(P2000-374301) (71)出顧人 000002369		
(21) 出額番号 特顧2000-374301 (P2000-374301) (71) 出額人 000002369	最終頁に続く	
	I Case (	
セイコーエプソン株式会社		
*************************************		
(22) High   1 Mars   1 m/2 o El Constitution		
	h / m	
長野県諏訪市大和3丁目3番5号	27 -	
ーエプソン株式会社内		
(72)発明者 小寺 琢己		
長野県諏訪市大和3丁目3番5号	セイコ	
ーエプソン株式会社内		
(74) 代理人 100095728		
弁理士 上柳 雅誉 (外1名)		
最終		

## (54) 【発明の名称】電気光学装置の製造方法、電気光学装置および電子機器

#### (57) 【要約】

【課題】 元基板に対する明形位置を容易に検査でき、 かつ、往入口から基板間に電気光学物質を往入した後、 の注入口に対する封止材を適正な範囲に強布すること のできる電気光学装置の製造方法、電気光学装置、およ びこの電気光学装置を用いた電子機器を提供することに ある。

【解決手段】 被晶装置を構成する素子基板別の元基板には、明新予定線上11に重なるように明新的の公差に対応する個のマーク100形成されている、後でて、明斯予定線上11に沿って元基板を明断したときに、切断個所の画側にマーク100 の部が各々残っていれば公内の精度で明晰が行われたと判断できる。また、この切断個所において、マーク100両で液晶法入日6aが開口するので、液晶を注入後、マーク100にかからないようにに対止対60の多葉に記収する大量が発生しない。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の基板を形成するための元基板を切 断予定線に沿って切断する切断工程と、前記第1の基板 に第2の基板を貼り合わせた空パネルにおいて前記元基 板に対する切断艦所で開ロする注入口を介して基板間に 電気光学物質を注入する注入工程と、前記注入口に封止 材を塗布して当該注入口を封止する封止工程とを有する 電気光学機両の製造方法において、

前記元基板のうち、前記切断予定線に重なり、かつ、前 記封上述の監索観測を指示する位置に所定幅のマークを 10 形成する工程を具備し、 前記切断工程では、切断箇所の両側には

前記切断工程では、切断箇所の両側に前記マークの一部 が各々残るように前記切断予定線に沿って前記元基板を 切断し、

前記封止工程では、前記マークを基準に前記封止材を所 定の範囲に塗布することを特徴とする電気光学装置の製 造方法。

【請求項2】 請求項1において、前記マークは、前記 注入口を挟む両側2箇所に各々形成され、前記對止工程 では、前記注入口の両側2箇所に移成された前記マーク 20 の前記注入口側の端部に重ならない範囲に前記封止材を 塗布することを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項3】 請求項1または2において、前記マーク を、前記元基板に形成される配線あるいは電気素子を構 成する薄膜と同時形成することを特徴とする電気光学装 層の刺洒方法。

【請求項4】 請求項1または2において、前記マークをTa膜またはCr膜から形成することを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項5】 請求項12ないし4のいずれかにおいて、 前記元基板に対して、前記列所予定線を挟んだ両側に所 定の預線を版で対向する第1のパターンと第2のパタ ーンとを形成するとともに、前記第1のパターンと前起 第2のパターンとの間には、これらのパターンと影態の 異なる境界パターンを形成する工程を美備し、

前記切断工程では、切断箇所の両側に前記境界パターン の一部が残るように前記元基板を前記切断予定線に沿っ て切断することを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項61 請求項61 初求項5において、前記第1のバターン を、前記第1の基板として切り出される基板形成領域に 40 形成される複数の配線の端部として形成する一方、前記 第2のパターンを、前記基板形成領域から切り離される 周辺領域に論能パターンとして形成し、前記境界パター ンを、前記第1のパターンの各々を前記第2のパターン に電気的に接続する中継パターンとして形成し、

前記切断工程を行う前に、前記第2のパターンから前記 境界パターンを経て前記第1のパターンに給電して、前 記第1のパターンあるいは該第1のパターンに電気的に 接続する導電膜に対して陽極酸化処理を行うことを特徴 とする需像光学装置の影流方法。 (請求項7) 請求項6において、前記陽極酸化処理 は、前記導帳膜、および該導電膜の表面に形成された絶 線膜を用いて電気素子を形成するための陽極酸化処理で あることを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項8】 請求項7において、前記電気素子は、画 素スイッチング用のTFD素子であることを特徴とする 電気光学装置の製造方法。

[請求項9] 請求項1ないし4のいずれかにおいて、 前記元基板に対して、所定幅をもって前記切断予定線を 繋ぐパターンを形成する工程を具備し、

前記切断工程では、切断箇所の両側に前記パターンの一部が残るように前記元基板を前記切断予定線に沿って切断することを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項10】 請求項1ないし4のいずれかおいて、 前記元法板に対して、前記切断予定線を挟んだ両側に所 定の距離を隔でて対向する第1のパターンおよび第2の パターン本形成する丁程を具備し、

前記切断工程では、切断簡所の両側で前記第1のパター ンおよび第2のパターンが欠けないように前記元基板を 前記切断予定線に治って切断することを特徴とする電気 光学装置の製造方法。

【請求項11】 請求項5ないし10のいずれかにおいて、前記パダーンの各々を、前記元基板に形成された配線からいは電気素子を形成する薄膜と同時形成することを締御とする僧気光学等歌の勢浩方法。

【請求項12】 請求項5ないし10のいずれかにおいて、前記パターンの各々をTa膜またはCr膜から形成することを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項13】 請求項1ないし12のいずれかに規定 30 する製造方法により製造したことを特徴とする電気光学

【請求項14】 第1の基板と第2の基板とがシール材で貼り合わされているとともに、酸シール材の途切れ部分からなる注入口が封止材で封止されてなる電気光学装備において、

前記第1の基板の縁部分には、前記封止材の盤布範囲を 示すとともに、前記第1の基板を元基板から切り出した ときの切断位置を検査するためのマークが付されている アトを特徴とする電気光学装置。

【請求項15】 第1の基板と第2の基板とがシール材 で貼り合わされているとともに、該シール材の途切れ部 分からなる注入口が封止材で封止されてなる電気光学装 蟹において、

前記注入口は、前記第1の基板の縁部分で開口してお

前記第1の基板の縁部分には、この縁部分に沿って前記 注入口の両側にマークが設けられていることを特徴とす る電気光学装置。

【請求項16】 請求項14または15において、前記 50 マークは、前記注入口を挟む両側2箇所に形成され、前 記封止材は、前記注入口の両側2箇所に形成された前記 マークの前記注入口側の端部に重ならない範囲に塗布さ れていることを特徴とする電気光学装置。

【請求項17】 請求項14ないし16のいずれかにお いて、前記マークは、前記第1の基板に形成された配線 あるいは電気素子を形成する薄膜と同一の組成を有して いることを特徴とする電気光学装置。

【請求項18】 請求項14ないし16のいずれかにお いて、前記マークは、Ta膜またはCr膜から構成され ていることを特徴とする電気光学装置。

【請求項19】 請求項13ないし18のいずれかに規 定する電気光学装置を表示部として備えていることを特 微とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

## [0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、元基板から切り出 した基板を用いた電気光学装置、およびこの電気光学装 置を用いた電子機器に関するものである。さらに詳しく は、元基板に対する切断位置を指示するための技術に関 するものである。

### [0002]

[従来の技術] 近年、携帯電話機、携帯型コンピュー タ、ビデオカメラ等といった電子機器の表示部として、 液晶装置などといった電気光学装置が広く用いられてい る。液晶装置では、第1の基板と第2の基板をシール材 によって貼り合わして、空セルと称せられる空のパネル を構成した後、シール材で区画された領域内に、電気光 学物質としての液晶が封入されている。

[0003] このような液晶装置に用いるパネルは、個 々のパネルに対応した第1および第2の基板を一枚ずつ 30 形成して貼り合わせる場合もあるが、小型の液晶装置を 製造する場合には特に、複数のパネルを形成できる大き な元基板に対して複数の液晶装置分の配線パターンを形 成するなど、製造工程の途中までは、大型の元基板のま まで処理を行い、その後、元基板を個々の基板に分割す ることが多い。

【0004】また、パネル1枚分の元基板を準備し、こ の元基板に対して、配線パターンなどの製造工程を行う 場合においても、製造工程の後半において元基板の周縁 部を除去した後、液晶の注入工程などを行うことがあ

【0005】これらのいずれの場合でも、元基板に対す る切断方法としては、カッター等を用いる方法、あるい は、元基板の表面に薄状の傷を形成し、その傷を形成し た部分に応力を加えることによって基板を破断させる方 法などが採用されている。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】液晶装置を構成する基 板を元基板から切り出す工程では、元基板に対する切断 位置がずれて基板の寸法や切断位置が所定の公差内に入 50

っていないと、後の実装工程等において不良が発生する 危険性があるため、切断した基板に対する検査が必要に なる.

[0007] しかしながら、元基板に対する切断が正確 に行われたか否かを知るためには、元基板から切り出し た基板の寸法を何箇所も計測する必要があるなど、検査 作業に多大な手間がかかるという問題点がある。

【0008】以上の問題点に鑑みて、本発明の課題は、 元基板に対する切断位置を容易に検査でき、かつ、注入 10 口から基板間に電気光学物質を注入した後、この注入口 に対する封止材を適正な範囲に塗布することのできる電 気光学装置の製造方法、電気光学装置、およびこの電気 光学装置を用いた電子機器を提供することにある。

【0009】また、本発明の課題は、このような電気光 学装置の製造方法を、新たな工程を付加することなく実 理可能な構成を提供することにある。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本発明では、第1の基板を形成するための元基板を 切断予定線に沿って切断する切断工程と、前記第1の基 板に第2の基板を貼り合わせた空パネルにおいて前記元 基板に対する切断箇所で開口する注入口を介して基板間 に電気光学物質を注入する注入工程と、前記注入口に封 止材を塗布して当該注入口を封止する封止工程とを有す る電気光学装置の製造方法において、前記元基板のう ち、前記切断予定線に重なり、かつ、前記封止材の塗布 範囲を指示する位置に所定幅のマークを形成する工程を 具備し、前記切断工程では、切断箇所の両側に前記マー クの一部が各々残るように前記切断予定線に沿って前記 元基板を切断し、前記封止工程では、前記マークを基準 に前記封止材を所定の範囲に塗布することを特徴とす

【0011】本発明では、元基板を切断するときの公差 に対応する幅のマークを元基板に形成しておくので、切 断予定線に沿って、元基板を切断したとき、切断箇所の 両側にマークの一部が各々残っているか否かを確認すれ ば、切断が精度よく行われていたか否かを容易に検査で きる。すなわち、切断が精度よく行われていれば、切断 箇所の両側にマークの一部が各々残るのに対して、切断 40 時の精度が悪ければ、切断箇所の一方にのみマークが残 り、他方にマークが残らないからである。また、第1の 基板と第2の基板とを貼り合わせた空パネルにおいて、 基板に対して電気光学物質を注入するための注入口は、 元基板に対する切断箇所で開口しているので、切断工程 の良否を検査するのに用いたマークを、元基板に対する 切断箇所のうち、注入口に塗布する封止材の塗布範囲を 示す位置に形成しておけば、マークを基準に封止材を塗 布できる。それ故、封止材の塗布量の多寡に起因する不 旦合の発生を回避できる。

【0012】本発明において、前記マークは、例えば、

5

前記住人口を挟む両側2 箇所に名々形成されている場合 があり、この場合には、前記封止工程において、前記注 人口の両側2 箇所に形成された前記マークの前記注入口 側の端部に重ならない範囲に前記封止材を整布すればよ い。このように構成すると、封止材の整布しすぎを防止 することができる。

[0013] 本発明において、前記マークを、前記元基 板に形成される配線あるいは電気素子を構成する機関と 同時形成することが好ましい。このように構成すると、 元基板にマークを形成するといっても、新たな工程を追 加する必要がない。

[0014] ここで、元基板に形成される配検あるいは 電気素子の構成は、電気光学装置のタイプによって様々 であるが、画素スイッチンクの能動素子として下FD素 子を用いた電気光学装置では、配線あるいは電気素子を 構成する頻繁として、Ta(タンタル)膜やCr(クロ ム)膜が用いられるので、前記マークをTa膜またはC て繋かる形成すればよい。

【0015】本発明において、前記元基板に対して、前 記切断予定線を挟んだ両側に所定の距離を隔てて対向す 20 る第1のパターンと第2のパターンとを形成するととも に、前記第1のパターンと前記第2のパターンとの間 に、これらのパターンと形態の異なる境界パターンを形 成する工程を具備し、前記切断工程では、切断箇所の両 側に前記境界パターンの一部が残るように前記元基板を 前記切断予定線に沿って切断することが好ましい。この ように構成するにあたって、第1のパターンと第2のパ ターンとを元基板を切断するときの公差に対応する距離 を隔てて形成し、この間に境界パターンを形成する。従 って、切断予定線に沿って元基板を切断したとき、切断 30 箇所の両側に境界パターンの一部が各々残っているか否 かを確認すれば、元基板に対する切断が精度よく行われ ていたか否かを容易に検査できる。すなわち、切断が精 度よく行われていれば、切断箇所の両側に境界パターン の一部が各々残るのに対して、切断時の精度が悪けれ ば、切断箇所の一方にのみ境界パターンが残り、他方に 境界パターンが残らないからである。

【0016】未発明において、前記第1のパターンを、前記第1の基板として切り出される基板形成領域に形成される接板を開始の増加をして形成する一方、前記第2 40のパターンは、前記基板形成領域から切り離される周辺領域に結論ボターンとして形成し、前記場別のパターンに電気的に接続する中継パターンとして形成し、前記切断工程を行う前に、前記第2のパターンから前記場第パターンを経て前記第1のパターンに総電して、前記切りパターンと経て前記第1のパターンに高気的に接続する導電版に対して陽極酸化処理を行うことが好ましい。ここで行う前記陽振酸化処理を行うことが好ましい。ここで行う前記陽振酸化処理は、例えば、前記率電域、に対して経緯電板の表面に形成された極極酸化の理は、例えば、前記率電域、に対して経緯電線の表面に形成された極極酸を用いて、ダイオ 50

ド素子やキャパシタ素子などといった電気素子を形成 する陽極酸化処理である。元基板に形成される配線ある いは電気素子の構成は、電気光学装置のタイプによって 様々であるが、画素スイッチングの能動素子としてTF D素子を用いた電気光学装置では、配線あるいは電気素 子を構成する導電膜としてTa膜を形成し、このTa膜 に対して、基板として切り出される周辺領域に形成した 給電パターン (第2のパターン) から、中継パターンお よび配線を介して給電して陽極酸化を行った後、中継パ ターンの部分で元基板を切断して給電パターンと配線と を切断する。従って、元基板に対する切断予定線を跨ぐ 領域に中継パターンが形成されることになるので、この 中継パターンを、切断工程の良否を検査するための境界 パターンとして、第1のパターンや第2のパターンと容 易に区別できる形態で形成すれば、このようなパターン が密に形成されている領域に対して、切断工程の良否を 检査するためのマーク等を追加する必要がない。

【0017】本発明においては、前記元基板に対して、 前記切断予定線を挟んだ両側に所定の距離を隔てて対向 する第1のパターンおよび第2のパターンを形成する工 程を具備し、前記切断工程では、切断箇所の両側で前記 第1のパターンおよび第2のパターンが欠けないように 前記元基板を前記切断予定線に沿って切断してもよい。 このように構成するにあたって、第1のパターンと第2 のパターンとを元基板を切断するときの公差に対応する 距離を隔てて形成する。従って、切断予定線に沿って元 基板を切断したとき、切断箇所の両側で第1のパターン および第2のパターンが欠けることなく残っているか否 かを確認すれば、元基板に対する切断が精度よく行われ ていたか否かを容易に検査できる。すなわち、切断が精 度よく行われていれば、切断箇所の両側に第1のパター ンおよび第2のパターンが欠けずに残るのに対して、切 断時の精度が悪ければ、切断箇所の一方で第1のパター ンあるいは第2のパターンが欠けてしまうからである。 【0018】本発明において、前記元基板に対して、所 定幅をもって前記切断予定線を跨ぐ境界パターンを形成 する工程を具備し、前記切断工程では、切断箇所の両側 に前記境界パターンの一部が残るように前記元基板を前 記切断予定線に沿って切断してもよい。このように構成 するにあたって、境界パターンの幅を元基板を切断する ときの公差に対応する寸法とする。従って、切断予定線 に沿って元基板を切断したとき、切断箇所の両側で境界 パターンの一部が各々残っているか否かを確認すれば、 元基板に対する切断が精度よく行われていたか否かを容 易に検査できる。すなわち、切断が精度よく行われてい れば、切断箇所の両側に境界パターンの一部が残るのに 対して、切断時の精度が悪ければ、切断箇所の一方にの み境界パターンが残り、他方に境界パターンが残らない からである。

【0019】このようなパターンについても、前記マー

クと同様、前記元基板に形成された配線または電気素子 を形成する薄膜、例えば、Ta膜またはCr膜と同時形 成することが好ましい。

【0020】このような製造方法を用いて製造した電気 光学装置では、例えば、以下の構成を有することにな る。すなわち、第1の基板と第2の基板とがシール材で 貼り合わされているとともに、該シール材の途切れ部分 からなる洋入口が封止材で封止された電気光学装置にお いて、前記第1の基板の縁部分には、前記封止材の塗布 範囲を示すとともに、前記第1の基板を元基板から切り 10 わゆるBack-to-Back構造として構成されている。このた 出したときの切断位置を検査するためのマークが付され ている.

【0021】また、本発明に係る電気光学装置では、第 1の基板と第2の基板とがシール材で貼り合わされてい るとともに、該シール材の途切れ部分からなる注入口が 封止材で封止され、前記注入口は、前記第1の基板の縁 部分で開口しており、前記第1の基板の縁部分には、こ の縁部分に沿って前記注入口の両側にマークが設けられ ていることを特徴とする。

[0022] 本発明において、前記マークは、前記注入 20 口を挟む両側2箇所に形成され、前記封止材は、前記注 入口の両側2箇所に形成された前記マークの前記注入口 側の端部に重ならない範囲に塗布されている。

【0023】本発明において、前記マークは、前記第1 の基板に形成された配線または電気素子を形成する薄膜 と同一の組成、例えば、Ta膜またはCr膜から構成さ れている。

【0024】このような電気光学装置は、例えば、携帯 電話機、携帯型コンピュータ、ビデオカメラ等といった 電子機器の表示部として用いられる。

#### [0025]

【発明の実施の形態】図面を参照して、本発明の実施の 形態を説明する。なお、以下に実施形態を説明するにあ たっては、各種の質気光学装置のうち、能動素子として TFD素子 (Thin Film Diode) を用いたアクティブマ トリクス方式の液晶装置を例に説明する。

【0026】 [液晶パネルの構成] 図1は、液晶装置の 電気的構成を模式的に示すブロック図である。図2

(a)、(b) はそれぞれ、液晶パネルにおいて液晶層 を挟持する1対の基板のうち、素子基板における1画素 40 分の平面図、および図2 (a) のA-A線断面図であ 3.

【0027】図1に示すように、波晶装置に用いられる 液晶パネル2では、複数の配線としての走査線51が行 方向 (X方向) に形成され、複数のデータ線52が列方 向 (Y方向) に形成されている。走査線51とデータ線 52との各交差点に対応する位置には画素53が形成さ れ、この画素53では、液晶層54と、画素スイッチン グ用のTFD素子56とが直列に接続されている。各走 査線51は走査線駆動回路57によって駆動され、各デ 50 は、例えば、液晶パネル2にFPC (Flexible Printed

ータ線52はデータ線駆動回路58によって駆動され る。本実施形態において、走査線駆動回路57およびデ ータ線駆動回路58は、図3を参照して後述する液晶駆 動用IC8aおよび液晶駆動用IC8bにそれぞれ構成 されている。

【0028】図2(a)、(b) において、TFD素子 56は、素子基板7aの表面に成膜された下地層61の 上に形成された第1TFD素子56aおよび第2TFD 素子56bからなる2つのTFD素子要素によって、い め、TPD素子56は、電流-電圧の非線形特性が正負 双方向にわたって対称化されている。下地層61は、例 えば、厚さが50~200nm程度の酸化タンタル(T a,O<sub>c</sub>) によって構成されている。第1TFD素子56 a および第2 T F D 素子 5 6 b は、第1 金属層 6 2 と、 この第1金属層62の表面に形成された絶縁層63と、 絶級膜63の表面に互いに離問して形成された第2金属 層64a、64bとによって構成されている。第1金属 層62は、例えば、厚さが100~500nm程度のT a単体膜、Ta合金膜等によって形成され、絶縁層63 は、例えば、陽極酸化法によって第1金属層62の表面 を酸化することによって形成された厚さが10~35 n mの酸化タンタル (Ta,O,) である。

[0029] 第2金属層64a、64bは、例えばクロ ム (Cr) 等といった金属膜によって50~300nm 程度の厚さに形成されている。第2金属層64aは、そ のまま走査線51となり、他方の第2金属層64bは、 ITO (Indium Tin Oxide) 等といった透明導電材から なる画素電極66に接続されている。なお、画素電極6 30 6はA1 (アルミニウム) 等といった光反射性材料によ って形成されることもある。

【0030】素子基板7aを構成する基板17aは、対 向基板7aを構成する基板17b(図4参照)と同様、 例えば、石英、ガラス、プラスチック等によって形成さ れる。ここで、単純な反射型の場合には素子基板基板1 7 aが透明であることは、必須要件ではないが、本実施 形態のように透過型の場合には、素子基板基板 17 a は 透明であることが必須の要件となる。

【0031】 [液晶装置の構成] このようにして走査線 51およびTFD素子56が形成された素子基板7a は、図3および図4を参照して説明するように、「TO 等といった透明導電材からなるデータ線52がストライ プ状に形成された対向基板7bと対向配置される。ここ で、素子基板 7 a と対向基板 7 b は、一列分の画素電極 66と1本のデータ線52とが互いに対向する位置関係 となるように互いに貼り合わされる。

【0032】図3および図4はぞれぞれ、液晶装置の分 解斜視図およびその断面図である。

[0033] 図3および図4に示すように、液晶装置1

Circuit:可挑性プリント基板)3a、3bを接続し、 さらに液温パキル2の裏面側に導光体4を取り付け、さ らに導光体4の裏面側に制御基板5を設けることによっ で形成される。

[0034]液晶パネルジにおいて、素子基板7aと対 向基板70とは、これらの基板のうちの一方に環状に施 布されたシール材6によって貼り合わされている。ま た、シール材6の途切れ部分によって液晶在入口6aが 形成され、この液晶在入口6aは、対止材60によって 窓がれている。

【0035】素子基板7aのうち、対向基板7bから張 り出す部分の表面には、ACF (Anisotropic Conductive Film: 異方性等電観)9によって液晶层動用IC8 aがCOG (Chip On Glass) 実装されている。また、 対向基板7bのうち、素子基板7aから振り出す部分に は、ACF9によって液晶密動用IC8bがCOG実装 されている。

 $\{0036]$  図4に示すように、素子基板7 aの内面には複数の固素電腦66 6かマトリクス状に形成され、その外面には個形質12 aが貼着されている。また、対向基2板7 bの内面には複数のデータ線52がストライプ状に形成され、その外面には個形板12 bが貼着されている。そして、素子基板7 a と外前基板7 b との基板間のうち、シール材6によって区画された間隙(セルギャップ)に、電気光学物質としての液晶1が封入されている。

【0037】なお、図4には示されていないが、素子基 板7aおよび対向基板7bには必要に応じて上記以外の 各種の光学要素が設けられる。例えば、液晶しの配向を 揃えるための配向膜が各基板の内面に設けられる。これ 30 らの配向膜は、例えば、ポリイミド溶液を塗布した後に 焼成することによって形成される。このポリイミドのボ リマー主鎖がラビング処理によって所定の方向へ延伸さ れ、基板間に封入された液晶し内の液晶分子が配向膜の 延伸方向に沿って方向配位する。また、カラー表示を行 う場合には、対向基板7bに対して、画素電極66と対 向する領域に、R(レッド)、G(グリーン)、B(ブ ルー) のカラーフィルタ (図示せず) が所定の配列で形 成され、画素電極66に対向しない領域にはブラックマ トリクス (図示せず) が形成される。さらに、カラーフ 40 ィルタおよびブラックマトリクスを形成した表面には、 その平坦化および保護のために平坦化層がコーティング され、この平均化層の表面にデータ線52が形成され

る。FPC3トの端部には複数の端子22が渡けられ、 ACF等を用いてそれらの端子が対向基板7トの端子1 3トに薄電接続されている。また、FPC3トの他の端 部に形成された複数の端子23は、制御基板5の端子 (観示せず)に接続されている。FPC3aでは、裏面 飯端部に複数のパネル側端子14が形成され、その反対

10

(図示せず) に接続されている。FPC3 a では、裏面 暗端部に複数のパネル間端子 1 4が形成され、その反対 側の端部においてその表面側には複数の制御基板側端子 1 6 が形成されている。ここで、FPC3 a の表面には 起線パターン 1 8 は、一方の端部で制押基板側端子 1 6 に直接に接続し、他方の端部がスルーホール 1 9 を介してパネル端子 4 に接続している。

[0039] 端光体4の液晶パネル2側の表面には、拡 酸板27水脱落等によって装着され、得光体4の液晶パ ネル2と反対側の表面には、反射板28が貼着等によっ て装着される。また、得光体4の1つの制面に設定され た光吸込み面4aに対向して発光手段としての複数のL ED (Light Bailting Diode) 21がLED基板38に 支持されて配置されている。

[0040] 図4に示すように、準光体4は、ゴム、ブ ラスチック等によって形成された緩衝射32を挟んで被 品パネル2の裏面側に取り付けられる。また、制御基板 5は場光体4の反射板28が装着された面に対向して配 波される。なお、制御基板5の端部には、外部网路との 接続をとるための端子33が形成される。

【0041】このように構成した液晶装置 I において、 LED 2 1 が発光すると、その光が導光体 4 へ構入さ れ、その導入された光が反射板 2 8 で反射して液晶パネ ル 2 の方向へ進行し、拡散板 2 7 によって平面内で一様 放強度となるように拡散された状態で液晶パネル 2 へ供 過した成分が液晶層へ供給され、さらに画素電框 6 ら データ線 5 2 との間に印加される竜圧の変化に応じて 素格に配向が制度は一次な晶によって画素体を変関さ

れ、さらにその変調光を表示側の偏光板12bに通すこ

とにより、外部に像を表示する。

【0042】 [被酷装置の製造方法] 図5は、本形態の 液晶装置1の製造が法の一例を示す工程図である。図6 は、液晶パネルクを構成する1 投め基板を製造するのに 用いた元基板を模式的に示す斜視図である。図7は、素 子基板形成用の元基板に対するシール材印刷工程、および 対向基板形成用の元基板に対するラピング工程までを終 えた状態を模式的に示す斜視図である。図9は、素子基 板形成用の元基板に対するラピング工程までを終 えた状態を模式的に示す斜視図である。図9は、素子基 板形成用の元基板と、対向基板形成用の元基板とを貼り 図74、中で 板形成 10円 (B) は表れぞれ、空のパネ ルを1 次切所工程により短冊状に切断した状態を示す逆 明図、およびこの短冊状で切消した状態を示す逆明図であ をの注入口を封止材で封止した状態を示す説明図であ る。

【0043】本形態において、液晶装置1まよび鉄晶パネル2を製造するにあたっては、図ちに示す能動業子形成工程りとルール材印刷12個ワちのなる素子基板形成工程と、カラーフィルタ形成工程P6〜ラビング処理工程P10からなる対向基板形成工程とは別々に行われま

【① 0 4 4 】まず、素子基板形成工程(能動素子形成工 が元素 程 P 1 ~ シール材印刷工程 P 5 )において、図6 におす が元素 ような太面積の元基板 2 4 a を準備する。この元基板 2 1 0 れる。 4 a は、例えば、ガラス、ブラスチック等といった透光 性材料によって形成されている。ここで、元基板 2 4 a れる。 後々、一点線像で示す板想の1次切断予定線 L 1 2 におり におり におり に対していることでは、後々、一点線を示す板型の二次切断予定線 L 1 2 におって助削されて素子基板 7 a が模数制取りされ、そ ッグリ

【0045】 本形能では、この元基版24aに対して、まず、能動業子形成工程P1を行うことにより、液晶パネル複数枚分の配除51もよび下り五素子66を形成する。図6では、便宜上、元基板24aの表面に液晶パネ20ル6枚分のパターンが形成されている様子を示してあるが、実際の工程では、より多数の液晶パネル分のパターンが元基板24aに上に検定される。

【0046】能動素子形成工程P1は、例えば、図7に示すように行われる。すなわち、下地層形成工程(a)において、元基板24aの表面にTa酸化物、例えば、Ta,O,を一様な厚さに成膜して下地層61を形成す

【0047】次に、第1金属層形成工程(b)におい て、例えば、Taをスパッタリング等によって一様な厚 30 さで成膜し、さらにフォトリソグラフィ技術を用いて走 査線51の第1層、および第1金属層62などを同時に 形成する。このとき、走査線51の第1層と第1金属層 62とはブリッジ部(図示せず)で繋がっている。 【0048】次に、絶縁層形成工程(c)において、走 査線51の第1層を陽極端子として陽極酸化処理を行 い、その走査線51および第1金属層52の表面に絶縁 膜63として作用する陽極酸化膜を一様な厚さで形成す る。これにより、走査線51の表面に絶縁層(第2層) が形成されるとともに、第1TFD素子56aおよび第 40 2 T F D 素子 5 6 b の絶縁層 6 3 が形成される。なお、 絶縁層形成工程(c)を行うにあたって、走査線51 は、図8および図13(a)を参照して後述するよう に、周辺領域7cに形成された給電パターン59に対し て、2次切断予定線L12に沿って形成された中継パタ ーン55を介して接続されており、給電パターン59か

【0049】次に、ブリッジ部除去工程(d) において (0056]次に、平担任衛星は、例えば、ドライエッチングによりブリッジ部を元差 ラーフィルタの上に平坦化層板24aから除去する。これにより、第1下下0素子5 50 に形成して表面を平坦化する。

ら各走査線51に対して電圧供給が行われる。

6 a および第2TFD素子56bの第1金属層62および絶縁層63が走査線51から島状に分断される。

[0050] 次に、第2金層階形成工程(e) におい て、Crをスパッタリング等によって一様な原さで成践 した後、フォトリソグラフィ技術を利用して、走査線5 1の第3層、第1下FD業子56aの第2金属層64bを 形成する。以上により、能動業子であるTFD業子56 が元基板24aの表面に被晶パネルの枚数分だけ形成さ れる。

【0051】次に、図5の製業電極形成工程P2が行かれる。具体的には、まず、図7の下地層形成工程(f)において、画業電極66に相当する領域の下地層61を除去して元基板24を選出させた後、電極工程(g)において、画業電磁66を形成するためのITOをスパッグリング等によって一様な厚さで成験し、さらに、フォトリソグラフィ技術により、1両素分の大きさに相当する所定形状の両表板66をその一部が第2金鳳層6り重なように形成する。これらの一連の工程により、図2に示す下FD素子56および画業電極66が形成される。この状態における元基板7aの様子は、図8に示すとおりでする。

(0052)しかる後には、図5の配向膜工程P3において、元基板24aの表面にポリイミド、ポリビニルアルコール等を一様な厚さに形成することによって配向膜を形成した後、ラピング処理工程P4において、配向膜に対してラピング処理を向め配向配列理を行う。

【0053】次に、シール材印刷工程P5において、図8に示すように、ディスペンサーやスクリーン印刷等に よってシール材6を現状に整布する。なお、シール材6の一部分には、液晶の拌入口6aが形成される。

【0054】以上の素子基板原成工程とは別に、対向基 板形成工程(カラーフィルク形成工程P6~ラピング処 理工程P10)を行う。それには、まず、図6におい て、例えば、ガラス、ブラスチック等といった選光性材 料によって形成された大面積の大型基板24bを用意し た後、カラーフィルタ形成工程P6において、元基板2 4bの表面上に液晶パネルの枚数分、カラーフィルタを 形成する。

【00551 この元基版24 bは、後々、一点鎖線で示す 仮想の」 次切所予定線121、および二点鎖線で示す 仮想の二次切所予定線122 とに沿って切断されて対向基版7 bが複数個取りされる。 なお、図6では、便宜上、元基版24 bの表面に級晶級置6個分が表されているが、実際の工程では、より多数の液晶装置分が形成される。ここで、カラー表示が必要なない場合には、カラーフィルタを形成する必要はない。

【0056】次に、平坦化層形成工程P7において、カラーフィルタの上に平坦化層(図示せず)を一様な厚さに形成して表面を平坦化する。

【0057】次に、対向電極形成工程P8において、I TO膜等によりストライプ状の対向電極、すなわち、データ線52を形成する。

【0058】次に、配向膜形成工程P9において、データ線52等の上にポリイミド等によって一様な厚さの配向膜を形成した後、ラピング処理工程P10において、配向膜に形してラピング処理工程P10において、配向膜に対してラピング処理などの15年の処理を施す。これにより対向基板を図9に示すように、非子基板形成用の元基板24点とを他配合かせし低いの方法が見りのである。 (24bとを位置合わせした上でジール材6を間に挟んで、元基板24a、24b同土を貼り合わせ低いり合わせて限り1)、さらに紫水体硬化、洗硬に又はその他の方法でシール材6を硬化させる(シール材硬化工程P12)。これにより、液晶を環境数例分を含んでいる空のパネル構造を2aが形成される。

【0060】その後、空のパネル構造体2aに対して、 図6を参照して説明した第1の切断予定線L11、L2 1に沿って切断溝を形成し、さらに切断溝を基準にパネ ル構造体2 a を、図10 (a) に示すような、短冊状の 20 パネル構造体2 bに切断する(1次切断工程P13)。 この短冊状のパネル構造体2bにおいて、元基板24 a、24bに対する切断箇所では、シール材6の途切れ 部分からなる液晶注入口6 aが外部に開口している。 【0061】次に、露出した液晶注入口6aからパネル 構造体2bの内側に液晶を減圧注入した後(液晶注入工 程P14)、図10(b)に示すように、各液晶注入口 6 a に対して樹脂等の封止材 6 0 を塗布して、各液晶注 入口6aを封止する(注入口封止工程P15)。なお、 この工程により、パネル構造体2bに液晶が付着するの 30 で、液晶を注入し終えたパネル構造体2bは洗浄処理を 受ける(洗浄工程P16)。

【00062】その後、パネル場合体20に対しては、図 を参照して説明した第2の切断予定線L12、L22 に沿って切断満を形成した後、この切断満に治って短冊 状のパネル構造体20において元素板24a、24bを 切断することにより、複数側の液晶パネル2が切り出さ れる(2次切断工程P17)。

【0063】しかる後に、液晶パネル2に液晶壓動用 I C8a、8b、制御基板5などを実装し、さらにFPC 40 3a、3bを接続することにより、液晶装置1が完成す る(実装工程P18)。

を示す説明図である。図13 (a)、(b) はそれぞれ、図8の丸Bで開んだ蜘蛛を拡大して示す平面図、およびこの部分で元基板を精度よく切断したときの様子を示す説明図であり、図13 (c)、(d) はいずれも、元基板を切断したときの構度が低かったときの様子を示す説明図である。図14 (a)、(b) はそれぞれ、図8の丸Cで囲んだ鍼娑を拡大して示す平面図 およびこの部分で元基板を構度よく切断したときの様子を示す説明図であり、図14 (c)、(d) はいずれも、元基板を切断したときの精子を示す説明図であり、ときの様子を示す説明図であり、図14 (c)、(d) にいずれも、元基板を切断したときの様子を示す説明図である。

(0065) 本発明に係る液晶装置1の製造方法において、貼り合わせ工程P11を行う直前の元素板24a は、図8に示すら上構成な1. この図8において、元 基板24aの丸Aで囲んだ領域では、図11(a)に示すように、1次切断予定線L11に沿って、1次切断予定線L10に入って、1次切断を建た11に完成を研究ので、2010に、1次切断工程P13を行う以前に実施される能動業干形に大変が断工程P13を行う以前に実施される能動業干形に、第1金属層が定工程(b)で第1金属層52と同時形成されるTa膜、第2金属器形式工程

(e) で第2金属層64a、64bと同時形成されたC r 膜、あるいはこれらの膜を積屑した多層膜である。 [0066] ここで、マーク100は、シール材6の途 切れ部分からなる液晶注入口6aの両側2箇所に形成されている。

【0067】このように構成した素子基板形成用の元基 版24名に対して対向基板形成用の元基板241を貼り をわせてバト規盤体2aを販した後、13切断工程 P13において、バネル構造体2aを1次切断予定線L 11、21に沿って切断するとき、マーク100の幅方 向の中央を適るように切断溝を形成してバトル階値と aを切断する。ここで、マーク100の幅寸法W1につ いては、この切断箇所の公差に対応した係可法にしてあ

【0068】従って、パネル構造体2 a を短離状のパネル構造体2 b に切断したとき、切断箇所の両側にマーク 100の一部が各々残っているか否かを確認すれば、切断が公差をクリアする精度で行われていたか否かを容易に検査できる。すなわち、切断が精度よく行われていれ、 図11(図11(b)に示すように、切断箇所の両側にマーク1000一部が各々残るのに対して、切断筒の制度が 駆ければ、図11(c)、(d)に示すように、切断箇所の一方にのみマーク100が残らない。

【0069】このような1次切断工程P13を終えた 後、短階状のパネル構造体2 bでは、10(a)および 図11(b)に示すように、その切断箇所で被晶社入口 6 a が関ロし、液晶注入口 6 a の両側2 箇所にマーク1 00の一部が残っている。

[0070] そこで、液晶注入工程P14においては、 短冊状のパネル構造体3bの状態で液晶注入口6aから 波晶を注入した後、封止工程P15においては、マーク 100を基準にして、液晶注入口6aに封止材60を塗 布する。すなわち、図12に示すように、液晶注入口6 aの両側に位置するマーク100の端部に封止材60が かからないように、即ち、液晶注入口6aの両側に位置 するマーク100の端部からはみ出さないように封止材 60を塗布し、しかる後に、封止材60を硬化させる。 それ故、被晶注入口 6 a を確実に封止できるとともに、 封止材60を塗布しすぎることもない。

[0071] また、本形態において、マーク100は、 図7を参照して説明した素子基板形成工程において、第 1 金属層形成工程(b)で第1金属層52と同時形成さ れたTa膜、あるいは、第2金属層形成工程(e)で第 2金属層64a、64bと同時形成されたCr膜であ り、このような膜については、TFD素子56を形成す る過程でフォトリソグラフィ技術を用いたパターニング により形成できるので、マーク100を形成するといっ ても新たな工程を追加する必要がない。さらに、このよ 20 うなTa膜やCr膜であれば、下地である基板から目立 つので、これを基準にして1次切断工程P13に対する 給香、あるいはマーク100を基準にしての封止材60 の塗布を行うのが容易である。

【0072】また、本形態では、その他の切断箇所にお いても、切断緒度を容易に検査できるような構成が採用 されている。

[0073] まず、図8において丸Bで囲った領域で は、図13に示すように、各走査線51の端部は、走査 線51に一対一で対応する中継パターン55を介して給 30 電パターン59に接続しており、この中継パターン55 を横切るように2次切断予定線L12が通っている。従 って、元基板24 aにおいて、走査線51の端部と給電 パターン59とは、2次切断予定線L12を挟んだ両側 に第1のパターン201と第2のパターン202として 所定の距離を隔てて対向し、かつ、第1のパターン20 1と第2のパターン202との間において、中継パター ン55は、第1のパターン201および第2のパターン 202と幅寸法、形状、色および形成位置などといった 形態の異なる境界パターン203として形成されてい る。また、境界パターン203が形成されている領域の 幅寸法W2は、この切断箇所での公差に対応する寸法に なっている。

[0074] それ故、2次切断工程P17において、短 冊状のパネル構造体2bに対して2次切断予定線L12 に沿って元基板24aを切断するとき、切断箇所の両側 に境界パターン203(中継パターン55)の一部が残 るように元基板24aを切断した後、切断箇所の両側に 境界パターン203の一部が各々残っているか否かを確 認すれば、元基板24aに対する切断が公差をクリアす 50 ン301、第2のパターン302、および境界パターン

る精度で行われていたか否かを容易に検査できる。すな わち、切断が精度よく行われていれば、図13 (b) に 示すように、切断箇所の両側に境界パターンの一部が各 々残るのに対して、切断時の精度が悪ければ、図13 (c)、(d)に示すように、切断箇所の一方にのみ境 界パターン203が残り、他方に境界パターン203が

16

残らない。 [0075] ここで、走査線51の端部からなる第1の パターン201、給電パターン59からなる第2のパタ 10 ーン202、および中継パターン55からなる境界パタ ーン203は、1次切断工程P13および2次切断工程 P17を行う以前に実施される能動素子形成工程P1に おいて、第1金属層形成工程(b)で第1金属層52と 同時形成されるTa膜、あるいは、陽極酸化処理後、こ のTa膜の表面に対して第2金属層形成工程(e)で第 2金属層64a、64bと同時形成されたCr膜が積層 された多層膜であり、このような膜は、TFD素子56 を形成する過程でフォトリソグラフィ技術を用いたパタ ーニングにより形成される。それ故、切断検査用の境界 バターン203などを形成するといっても新たな工程を 追加する必要がない。さらに、このようなTa膜やCr 職であれば、下地である基板から目立つので、これを基 準にして2次切断工程P17に対する検査を容易に行う ことができる。

[0076] さらに、本形態において、図8において丸 Cで囲った領域では、図14 (a) に示すように、端子 13aからなる第1のパターン301と、周辺領域に形 成された第2のパターン302とが、2次切断予定線し 12を挟んだ両側に所定の距離を隔てて対向し、かつ、

第1のパターン301と第2のパターン302との間に は、これらのパターン301、302と幅寸法の異なる 境界パターン303が形成されている。ここで、境界パ ターン303が形成されている領域の幅寸法W3は、2 次切断予定線L12で元基板24aを切断するときの公 差に対応する寸法になっている。

【0077】従って、2次切断工程P13において、短 冊状のパネル構造体2bを2次切断予定線L12に沿っ て切断するときは、切断箇所の両側に境界パターン30 3の一部が残るように元基板24aを切断し、しかる後 に、切断箇所の両側に境界パターン303の一部が各々 残っているか否かを確認すれば、元基板24aに対する 切断が公差をクリアする精度で行われていたか否かを容 易に検査できる。すなわち、切断が精度よく行われてい れば、図14(b)に示すように、切断箇所の両側に境 界パターン303の一部が各々残るのに対して、切断時 の精度が悪ければ、図14(c)、(d) に示すよう に、切断箇所の一方にのみ境界パターン303が残り、 他方に境界パターン303が残らない。

[0078] ここで、端子13aからなる第1のパター

303は、1次切断工程P13および2次切断工程P1 7を行う以前に実施される能動素子形成工程P1におい て、第1金属層形成工程(b)で第1金属層52と同時 形成されるTa膜、第2金属層形成工程(e)で第2金 **屋屬64a、64bと同時形成されたCr膜、あるいは** これらの膜を積層した多層膜であり、このような膜は、 TFD素子56を形成する過程でフォトリソグラフィ技 術を用いたパターニングにより形成できる。それ故、切 断検査用の境界パターン303を形成するといっても新 たな工程を追加する必要がない。さらに、このようなT 10 第2のパターン302が欠けないように元基板24aを a膜やCr膜であれば、下地である基板から目立つの で、これを基準にして二次切断工程P17に対する検査 を容易に行うことができる。

[0079] [その他の実施の形態] 図15 (a)、 (b) はそれぞれ、図13あるいは図14に示す構成に 代えて採用することのできる切断予定線付近の構成を示 す平面図、および説明図である。図16は、図13ある いは図14に示す構成に代えて採用することのできる切 断予定線付近の別の構成を示す平面図である。図17 ことのできる切断予定線付近のさらに別の構成を示す平 面図である。

【0080】図15 (a)、(b) に示すように、元基 板24aにおいて、端子13aは、Ta膜とCr膜の2 層構造として形成される場合が多いので、例えば、第1 のパターン401および第2のパターン402について は、Ta膜とCェ膜の2層構造とし、境界パターン40 3については、Ta膜のみから構成してもよい。このよ うに構成した場合、Cr膜とTa膜とは、色相が異なる ので、これらのパターン401、402、403の形状 30 が同一でも、切断箇所の両側に境界パターン403の一 部が各々残っているか否かを確認することが可能であ **3.** 

【0081】また、図16に示すように、元基板24a に対して、給電パターン59などを形成するときに、こ のパターンを、所定幅をもって二次切断予定線L12を 跨ぐ境界パターン503として形成しておくとともに、 切断工程では、切断箇所の両側に境界パターン503の 一部が残るように元基板24aを二次切断予定線L12 に沿って切断してもよい。

【0082】この際に、境界パターン403が形成され ている領域の幅寸法W5を、この部分を切断するときの 公差に対応する寸法としておく。従って、二次切断予定 線L12に沿って元基板24aを切断したとき、切断値 所の両側で境界パターンの一部が各々残っているか否か を確認すれば、元基板24aに対する切断が精度よく行 われていたか否かを容易に検査できる。すなわち、切断 が精度よく行われていれば、切断箇所の両側に境界パタ ーン503の一部が残るのに対して、切断時の精度が悪 ければ、切断箇所の一方にのみ境界パターン503が残 50 え、タイミングジェネレータ73によって生成された各

n. 他方に境界パターン503が残らないからである。 このようなパターンについても、元基板24aに形成さ れた配線または電気素子を形成する薄膜、例えば、Ta 職またはCr職と同時形成することができる。

18

[0083] さらに、図17に示すように、元基板24 aに対して、2次切断予定線L12を挟んだ両側に所定 の距離を隔てて対向する第1のパターン601および第 2のパターン602を形成しておき、切断工程P17で は、切断箇所の両側で前記第1のパターン301および 2次切断予定線L12に沿って切断してもよい。

[0084] このような構成は、例えば、図13 (a) を参照して説明した構成において、陽極酸化処理が終っ た後、切断工程を行う前に、中継パターン55を除去し ておき、切断工程で発生した静電気が中継パターン55 を介して基板内に侵入するような場合に相当する。

[0085] このような構成においては、第1のパター ン601と第2のパターン602とを元基板24aを切 断するときの公差に対応する距離W6を隔てて形成す は、図13あるいは図14に示す構成に代えて採用する 20 る。従って、二次切断予定線L12に沿って元基板24 aを切断したとき、切断箇所の両側で第1のパターン6 0 1 および第2のパターン602が欠けることなく残っ ているか否かを確認すれば、元基板24aに対する切断 が精度よく行われていたか否かを容易に検査できる。 す なわち、切断が精度よく行われていれば、切断箇所の両 側に第1のパターン601および第2のパターン602 が欠けずに残るのに対して、切断時の精度が悪ければ、 切断箇所の一方で第1のパターン601あるいは第2の パターン602が欠けてしまうからである。

> 【0086】なお、上記実施形態では、能動素子として TFD素子を用いたアクティブマトリクス方式の液晶装 置1を例に説明したが、能動素子として薄膜トランジス 夕を用いたアクティブマトリクス方式の液晶装置、ある いはその他の電気光学装置に本発明を適用してもよいな ど、請求の範囲に記載した発明の範囲内で種々に改変で きる。

【0087】 (電子機器の実施形態) 図18は、本発明 に係る液晶装置を各種の電子機器の表示装置として用い る場合の一実施形態を示している。ここに示す電子機器 40 は、表示情報出力源70、表示情報処理回路71、電源 回路72、タイミングジェネレータ73、そして液晶装 置74を有する。また、液晶装置74は、液晶表示パネ ル75及び駆動回路76を有する。液晶装置74および 液晶パネル75としては、前述した液晶装置1および液 品パネル2を用いることができる。

[0088] 表示情報出力源70は、ROM (Read On) y Memory) 、RAM (Random Access Memory) 等といっ たメモリ、各種ディスク等といったストレージユニッ ト、デジタル画像信号を同調出力する同調回路等を備

種のクロック信号に基づいて、所定フォーマットの画像 信号等といった表示情報を表示情報処理回路71に供給 する。

[0089]表示情報処理回路71は、シリアルーパラ レル変換回路や、増幅・反転回路、ローテーション回 路、ガンマ補正回路、クランプ回路等といった周知の各 種回路を備え、入力した表示情報の処理を実行して、そ の画像信号をクロック信号CLKと共に駆動回路76へ 供給する。駆動回路76は、図1における走査線駆動回 路57やデータ線駆動回路58、検査回路等を総称した 10 工程、および対向基板形成用の元基板に対するラビング ものである。また、電源回路72は、各構成要素に所定 の電圧を供給する。

【0090】図19は、本発明に係る電子機器の一実施 形態であるモバイル型のパーソナルコンピュータを示し ている。ここに示すパーソナルコンピュータは、キーボ ード81を備えた本体部82と、液晶表示ユニット83 とを有する。液晶表示ユニット83は、前述した液晶装 置1を含んで構成される。

【0091】図20は、本発明に係る電子機器の他の実 施形態である携帯電話機を示している。ここに示す携帯 20 ある。 電話機90は、複数の操作ボタン91と液晶装置1を有 している。

#### [0 0 9 2]

[発明の効果] 以上説明したように、本発明では、元基 板を切断するときの公差に対応する幅のマークを元基板 に形成しておくので、切断予定線に沿って、元基板を切 断したとき、切断箇所の両側にマークの一部が各々残っ ているか否かを確認すれば、切断が精度よく行われてい たか否かを容易に検査できる。すなわち、切断が精度よ く行われていれば、切断箇所の両側にマークの一部が各 30 々残るのに対して、切断時の精度が悪ければ、切断箇所 の一方にのみマークが残り、他方にマークが残らないか らである。また、第1の基板と第2の基板とを貼り合わ せた空パネルにおいて、基板に対して電気光学物質を注 入するための注入口は、元基板に対する切断箇所で開口 しているので、切断工程の良否を検査するのに用いたマ 一クを、元基板に対する切断箇所のうち、注入口に強布 する封止材の塗布範囲を示す位置に形成しておけば、マ 一クを基準に封止材を塗布できる。それ故、封止材の塗 布量の多案に記因する不具合の発生を回避できる。

【図1】本発明を適用した液晶装置の電気的構成を模式 的に示すプロック図である。

【図面の簡単な説明】

- 【図2】 (a)、(b) はそれぞれ、本発明を適用した 液晶装置の液晶パネルにおいて液晶層を挟持する1対の 基板のうち、素子基板における1画素分の平面図、およ び図2 (a) のA-A線断面図である。
- 【図3】本発明を適用した液晶装置の分解斜視図であ
- 【図4】本発明を適用した液晶装置の断面図である。

- 20 【図5】本発明を適用した液晶装置の製造方法の一例を 示す工程図である。
- 【図6】本発明を適用した液晶装置の液晶パネルを構成 する1対の基板を製造するのに用いた元基板の説明図で ある。
- 【図7】本発明を適用した液晶装置の製造工程のうち、 素子基板形成工程を示す工程断面図である。
- 【図8】本発明を適用した液晶装置の製造方法におい て、工程素子基板形成用の元基板に対するシール材印刷 工程までを終えた状態を模式的に示す斜視図である。
- 【図9】本発明を適用した液晶装置の製造方法におい て、索子基板形成用の元基板と、対向基板形成用の元基 板とを貼り合わせて空のパネルを構成した状態を模式的 に示す平面図である。
- 【図10】(a)、(B) はそれぞれ、図9に示す空の パネルを1次切断工程により短冊状に切断した状態を示 す説明図、およびこの短冊状のパネルに液晶を注入した 後、その注入口を封止材で封止した状態を示す説明図で
- 【図11】 (a)、(b) はそれぞれ、図8の丸Aで囲 んだ領域を拡大して示す平面図、およびこの部分で元基 板を精度よく切断したときの様子を示す説明図であり、 (c)、(d) はいずれも、元基板を切断したときの精
- 度が低かったときの様子を示す説明図である。 【図12】本発明を適用した液晶装置の製造方法におい て、短冊状のパネルに対して液晶を注入した後、液晶注
- 入口を封止材で封止した様子を示す説明図である。 【図13】(a)、(b) はそれぞれ、図8の丸Bで囲 んだ領域を拡大して示す平面図、およびこの部分で元基 板を精度よく切断したときの様子を示す説明図であり、
- (c) (d) はいずれも、元基板を切断したときの精 度が低かったときの様子を示す説明図である。 【図14】(a)、(b) はそれぞれ、図8の丸Cで囲
- んだ領域を拡大して示す平面図、およびこの部分で元基 板を精度よく切断したときの様子を示す説明図であり、 (c)、(d)はいずれも、元基板を切断したときの精
- 度が低かったときの様子を示す説明図である。 【図15】 (a)、(b) はそれぞれ、図13あるいは
- 図14に示す構成に代えて採用することのできる切断予 定線付近の構成を示す平面図、および説明図である。
  - 【図16】図13あるいは図14に示す構成に代えて採 用することのできる切断予定線付近の別の構成を示す平 面図である。
  - 【図17】図13あるいは図14に示す構成に代えて採 用することのできる切断予定線付近のさらに別の構成を 示す平面図である。
  - 【図18】本発明に係る液晶装置を用いた各種電子機器 の構成を示すブロック図である。
- 50 【図19】本発明に係る液晶装置を用いた電子機器の一

21

実施形態としてのモバイル型のパーソナルコンピュータ を示す説明図である。

【図20】本発明に係る液晶装置を用いた電子機器の一 実施形態としての携帯電話機の説明図である。

【符号の説明】

1 液晶装置 (電気光学装置)

2 液晶パネル

2 a 大型のパネル構造体

2 b 短冊状のパネル構造体

6 シール材

6 a 液晶注入口

7 a 素子基板 7 b 対向基板

8 a、8 b 液晶駆動用 I C

12a、12b 偏光板

17a 素子基板を構成する基板

17b 対向基板を構成する基板 24a 素子基板形成用の元基板

24a 素子基板形成用の元基板 24b 対向基板形成用の元基板

5 1 走査線

52 データ線

53 画素

5.4 液晶層

55 中継パターン

56 TFD素子

57 走查線駆動回路

57 走錐線驅勁凹路

58 データ線駆動回路

59 給電パターン 60 封止材

60 封止材 10 61 下地層

62 第1金属層

63 絶縁層

64a、64b 第2金属層

66 画素電極

100 マーク

201、301、401、601 第1のパターン

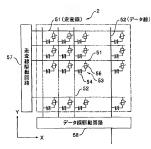
[図2]

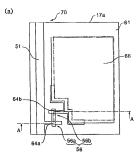
202、302、402、602 第2のパターン 203、303、403 境界パターン

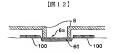
L11、L21 1次切断予定線

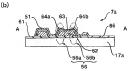
20 L12、L22 2次切断予定線

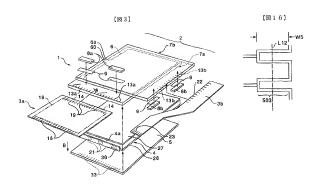
[2] 1]

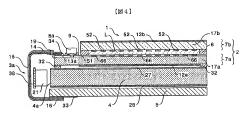


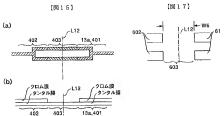


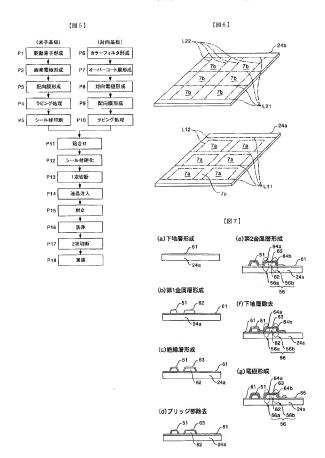


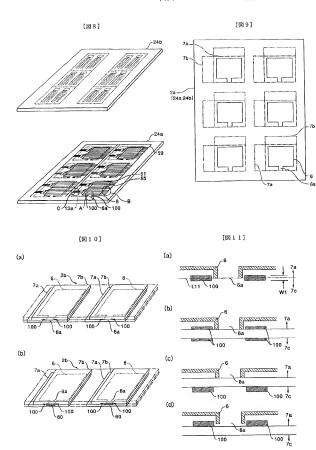


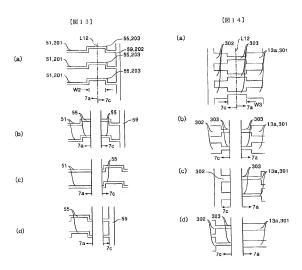


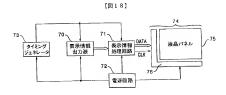


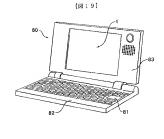














フロントページの続き

(51) Int. Cl. 1 G 0 9 F 9/00

H 0 1 L 49/02

識別記号 352

FI G09F 9/00 H 0 1 L 49/02

テーマコード(参考) 352

Fターム(参考) 2H089 LA22 LA24 NA24 QA16 TA12 2H090 JB02 JB03 JC11 JC13 LA15

2H092 GA50 JA01 JB22 MA05 MA13

MA19 MA24 NA25 PA08 5G435 AA17 BB12 CC09 EE32 BE36 EE37 EE40 KK03 KK05 KK10

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



1/2 ページ

(11)Publication number:

09-318957

(43)Date of publication of application: 12.12.1997

(51)Int.CI.

GO2F 1/1341 1/1333 GO2F

(21)Application number: 09-064735 (22)Date of filing:

18.03.1997

(71)Applicant : TOSHIBA CORP (72)Inventor · HIDA YOSHIHITO KIMURA TSUNEKI

(30)Priority

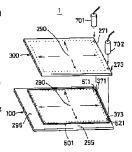
Priority number : 08 75616 Priority date: 29.03.1996 Priority country: JP

# (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS MANUFACTURE

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a liquid crystal display device having excellent production efficiency and a high production yield by disposing alignment marks for aligning first and second substrates to each other at least at one mouth hole regions of the respective substrates.

SOLUTION: The alignment marks 271, 273, 371, 373 for aligning the array substrate 100 and counter substrate 300 corresponding to the regions of the injection holes 511, 521 are arranged on the respective substrates. The respective alignment marks 371, 373 to be arranged on the array substrate 100 are formed by film forming and patterning simultaneously with the formation of scanning lines and gate electrodes and are formed to drop-out cruciform marks. The respective alignment marks 271. 273 arranged at the counter substrate 300 are formed by film forming and patterning simultaneously with the formation of light shielding films and are formed to approximate cruciform shapes. The alignment marks 271,



273, 371, 373 for aligning a pair of the electrode substrate 100, 300 to each other are arranged in the manner described above, by which the utilization efficiency of the substrates is enhanced and the excellent productivity is assured.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

Searching PAJ 2/2 ページ

[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



## (1)公開特許公報 (4) (19)日本国特許庁 (JP)

(11)特許出願公開番号

特開平9-318957

(43)公開日 平成9年(1997)12月12日

(51) Int. Cl. 6 識別記号 G02F 1/1341 500

1/1333

FΙ

G02F 1/1341 1/1333

500

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全12頁)

(21)出題番号

特國平9-64735

(22) 出頭日

平成9年(1997)3月18日

(32)優先日

(31) 優先権主導番号 特顧平8-75616

平8 (1996) 3 月29日 (33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出題人 000003078 株式会社東芝

神杏川県川橋市幸区堀川町72番地

(72)発明者 飛弾 佳人

兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会

社東芝姫路工場内

(72)発明者 木村 恒基

兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会

社東芝姫路工場内

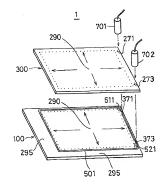
(74)代理人 弁理士 蔦田 璋子 (外1名)

(54) 【発明の名称】液晶表示装置及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 海島表示装置を構成する2枚の基板(100.3 00) について、基板(100,300) を大判基板から多面取りす るに際しては基板の利用効率を高めることができ、両基 板(100,300)を貼り合わせた後においては、不要な周辺 部分のスクライブ除去工程を要しない液晶表示装置及び その製造方法を提供する。

【解決手段】両基板(100,300)を互いに位置合わせする ためのマーク(271, 273, 371, 373)が、両基板(100, 300)を 貼り合わせた際には液晶注入のための二つの孔(511,52 1)の上下壁面となる個所に配置される。



【特許請求の範囲】

液品表示装置。

【請求項1】一つの表示領域を構成するように多数の表 示電極が形成された第1基板と、

前記第1基板に対向する第2基板と、

前記第1基板と前記2基板との間隙に保持される液晶材 料上

前記液晶材料の注入のための少なくとも一つの□孔領域 を形成すると共に、前記表示領域を取り囲むように前記

開闢中に配される第1封止材と、 前記□孔領域を封止する第2封止材とを備えた液晶表示 10 装置において、

前記第1基板及び前記2基板のそれぞれには、両基板を 互いに位置合わせするための位置合わせマークが、少な くとも一つの前記口孔領域に配されたことを特徴とした

【請求項2】前記第1封止材は少なくとも二つの前記□ 孔領域を含み、前記位置合わせマークは少なくとも二つ の前記□孔領域に形成されることを特徴とした請求項1 記載の液晶表示装置。

【請求項3】前記位置合わせマークが形成される口孔領 20 域が、前記液晶表示装置の一端辺に少なくとも二つ形成 されて成るととを特徴とした請求項1記載の液晶表示装 圈。

【請求項4】前記位置合わせマークが形成される□孔領 城が、前記液晶表示装置の対向する2 端辺のそれぞれに 少なくとも一つ形成されて成ることを特徴とした請求項 1記載の液晶表示装置。

【請求項5】前記位置合わせマークが形成される口孔領 域が、前記液晶表示装置にあって対角をなす二つの角部 に形成されて成ることを特徴とした請求項1記載の液晶 30 表示装置。

【請求項6】一つの表示領域を構成するように多数の表 示電極が形成された第1基板と、前記第1基板に対向す る第2基板とを用意する第1工程と、

液晶材料の注入のための一つ又は複数の口孔領域を形成 すると共に、前記表示領域を取り囲むようにして前記第 1 基板 F 又は前記第2 基板 F に配される第1封止材を介 して、前記第1基板と前記第2基板とを所定の位置に位 置合わせして貼り合わせる第2工程と、

より前記液晶材料を注入し、前記□孔領域を第2封止材 により封止する第3工程とを備えた液晶表示装置の製造 方法であって、

前記第2工程における位置合わせは、前記第1基板及び 前記2.基板のそれぞれに、少なくとも一つの前記□孔領 域に形成された位置合わせマークに基づくことを特徴と した液晶表示装置の製造方法。

【請求項7】前記位置合わせマークが形成される□孔領 域が、前記液品表示装置の対向する2端辺のそれぞれに 少なくとも一つ形成されるように前記第1封止材を配置 50 線と略平行する補助容量線が配置され、補助容量線と画

し、前記位署合わせして貼り合わせる工程の後、

一方の前記[17]、領域から排気を行いつつ。 他方の前記[1] 孔領域から前記液品材料を注入することを特徴とした請 求項6記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項8】前記第1基板上の前記位置合わせマーク が、前記第1基板上の走査線と同一の工程において同一 材料の金属薄膜から形成されることを特徴とした請求項 6記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項9】前記第2基板上の前記位置合わせマーク が、前記第2.基板上の遮光膜と同一の工程において同一 材料から形成されることを特徴とした請求項6記載の液 晶表示装置の製造方法。

【請求項10】前記第2基板上の前記位置合わせマーク が、前記第2基板上の色部と同一の工程において同一材 料から形成されることを特徴とした請求項6記載の液晶 表示装置の製造方法。

【請求項11】前記第2基板上の前記位置合わせマーク が前記第2基板上の対向電極と同一工程において同一材 料から形成されるか、又は、前記第1基板上の前記位置 合わせマークが前記画素電極と同一工程において同一の 透明材料から形成されることを特徴とした請求項6記録 の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[00011

【発明の属する技術分野】との発明は 一対の基板間に 液晶材料が保持されて成る液晶表示装置およびその製造 方法に関する。

[0002]

613.

【従来の技術】近年、液晶表示装置は、薄型、軽量、低 消費電力の特徴を生かして、パーソナル・コンピュー タ、ワードプロセッサあるいはTV等の表示装置とし て、更に投射型の表示装置として各種分野で利用されて

【0003】中でも、各画素電極にスイッチ素子が電気 的に接続されて成るアクティブマトリックス型表示装置 は 隣接画季間でクロストークのない良好な表示画像を 実現できることから、盛んに研究・開発が行われてい

【0004】以下に、光透過型のアクティブマトリック 前記第1基仮と前記第2基板との間隙に前記口孔領域に 40 ス型液晶表示装置を例にとり、その機成について簡単に 説明する。アクティブマトリックス型液晶表示装置は、 アレイ基板と対向基板との間に配向膜を介して液晶材料 が保持されて構成されている。

> 【0005】アレイ基板においては、ガラス基板上に複 数本の信号線と複数本の走査線とがマトリクス状に配置 され、各交点近傍にスイッチ素子として配置される薄膜 トランジスタ(以下、TFTと略称する。)を介して、 ITO (Indium Tin Oxide) から成る画素電極と各信号 線とが接続される。更に、このガラス基板上には、走査

素価級との間で補助容量 (Cs) が形成されるよう、補 助容量線と画素電極との間には絶縁膜が介在されてい

【0006】対向基板は、ガラス基板上にTFT並びに 画素電板展辺を遮光するためのマトリクス状の遮光膜が 配置され、この上にITOから成る対向電極が配置され て成っている。

【0007】以下に、従来の技術における、アレイ基板 と対向基板との位置合わせ及び液晶表示装置の組立工程 について図12~14を用いて説明する。

[0008]まず、第1の従来例を図12~13により 説明する。

【0009】アレイ基板及び対向基板(1100,1300)を原 基板から切り出す際に、最終外形の四方に余分の周辺領 域(1800)を有するようにし、予め両基板(1100.1300)の 周辺領域(1800)に位置合わせマーク(1271,1273,1371,13 73)を設けて置く。位置合わせマーク(1271,1273,1371.1 373)は涌常切り出された基板の角部に対角に設けられ る。両基板(1100,1300)を貼り合わせる際に、この位置 合わせマークについてカメラ(1701)等を用いて位置合わ 20 最終製品としては不要な領域を基板に設けることが軽減 せを行う。そして貼り合わせの後には、両基板(1100,13 00)の四方の周辺領域(1800)をスクライブ除去する。 [0010]次に、第2の従来例を図14を参照して説

明する。

【0011】 図に示すように、最終外形寸法よりも十分 に大きい外形寸法を有し、最終外形の外の周辺領域(180 0) にアレイ基板との二つの位置合わせマーク(1271, 127 3)を備えた対向基板(1300)を用い、この対向基板(1300) と、最終外形に裁断されたアレイ基板(1100)とを封止材 を介して貼り合わせた後、液晶材料の注入前、もしくは 30 注入後に不要な対向基板の周辺領域をスクライブ除去す ることが行われていた。

【0012】アレイ基板(1100)は、表示領域(1290)周辺 に外部回路との電気的な接続を得るための接続領域(129 5)を含むことから、表示領域(1290)に対して十分に大き い外形寸法を有している。従って、アレイ基板(1100)に おいては、対向基板(1300)との位置合わせ用のマーク(1 371, 1373) を表示領域外に配置するに際し十分な自由度 がある。

は、表示領域(1290)と大差なく、このためアレイ基板(1 100) との位置合わせ用のマーク(1371, 1373)を表示領域 (1291)外に配置することは困難である。

## [0014]

【発明が解決しようとする課題】 従来の技術では、大判 の基板から複数枚の対向基板を採取することが困難であ り、このため材料ロスが多く、生産効率の向上が困難で あった。

【0015】この発明は、上記した技術課題に対処して

留まりの高い液晶表示装置およびその製造方法を提供す ることを目的としている。

[0016]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載される発 明は、一つの表示領域を構成するように多数の表示電極 が形成された第1基板と、前記第1基板に対向する第2 基板と、前記第1基板と前記2基板との間隙に保持され る被晶材料と、前記液晶材料の注入のための少なくとも 一つの口孔領域を形成すると共に、前記表示領域を取り 10 囲むように前記間隙中に配される第1封止材と、前記口 3.領域を封止する第2.封止材とを備えた液晶表示装置に おいて、前記第1基板及び前記2基板のそれぞれには、 両基板を互いに位置合わせするための位置合わせマーク が、少なくとも一つの前記口孔領域に配されたことを特 徴とした液晶表示装置にある。

【0017】この発明によれば、上述したように、液晶 材料注入のための孔に対応する領域に、一対の電極基板 を互いに位置合わせするための位置合わせマークが配さ れている。このため、位置合わせマークを配するため、 される.

【0018】従って、最終外形寸法に近い基板を取り扱 うことが可能となるので、基板を大判基板から多面取り するに際しては基板の利用効率を高め、優れた生産性を 確保することができる。

【0019】しかも、基板を貼り合わせた後の、不要な 周辺部分のスクライブ除去工程を軽減することができ、 スクライブ不良に基づく製造歩留まりの低下を抑えるこ とができる..

【0020】請求項2に記載される発明は、請求項1記 載の液晶表示装置において、前記第1封止材は少なくと も二つの前記口孔領域を含み、前記位置合わせマークは 少なくとも二つの前記口孔領域に形成されることを特徴 とする。

【0021】この発明によれば、前記位置合わせマーク を他に設ける必要がなく、したがって、最終製品として は不要な領域を基板に設ける必要がない。

【0022】請求項3に記載される発明は、請求項1記 裁の前記位置合わせマークが形成される口孔領域が、前 【0013】これに対して、対向基板(1300)の外形寸法 40 配液晶表示装置の一端辺に少なくとも二つ形成されて成 ることを特徴とした液晶表示装置にある。

> 【0023】この発明によれば、減圧排気後に一端辺か ら被晶材料を注入することが容易に行える。

> 【0024】請求項4に記載される発明は、請求項1記 載の前記位置合わせマークが形成される口孔領域が、前 記被晶表示装置の対向する2端辺のそれぞれに少なくと も一つ形成されて成ることを特徴とした液晶表示装置に あろ

【0025】この発明によれば、二つの位置合わせマー 成されたものであって、生産効率に優れ、しかも製造歩 50 ク入りの口孔間の距離を大きく取れるため位置合わせが

5 容易である。また、一方の口孔を減圧排気孔として他方

の口孔からの液晶材料の注入を促進することもできる。 [0026] 糖求項5に記載される発明は、請求項1記 載の前記位置合わせマークが形成される口孔領域が、前 記液晶表示装置にあって対角をなす二つの角部に形成さ れて成ることを特徴とした液晶表示装置にある。

【0027】請求項6に記載される発明は、一つの表示 領域を構成するように多数の表示電極が形成された第1 基板と、前記第1基板に対向する第2基板とを用意する 第1工程と、液晶材料の注入のための一つ又は複数の口 10 孔領域を形成すると共に、前記表示領域を取り囲むよう にして前記第1基板上又は前記第2基板上に配される第 1 封止材を介して、前記第1基板と前記第2基板とを所 定の位置に位置合わせして貼り合わせる第2工程と、前 記第1基板と前記第2基板との間隙に前記口孔領域によ り前記波晶材料を注入し、前記口孔領域を第2封止材に より封止する第3工程とを備えた液晶表示装置の製造方 法であって、前記第2工程における位置合わせは、前記 第1基版及び前記2基板のそれぞれに、少なくとも一つ の前記口孔領域に形成された位置合わせマークに基づく 20 ことを特徴とした液晶表示装置の製造方法にある。

[0028] 請求項7に記載される発明は、前記位置合 わせマークが形成される口孔領域が、前記液晶表示装置 の対向する 2 端辺のそれぞれに少なくとも一つ形成され るように前記第1封止材を配置し、前記位置合わせして 貼り合わせる工程の後、一方の前記口孔領域から排気を 行いつつ、他方の前記口孔領域から前記液晶材料を注入 することを特徴とした請求項6記載の液晶表示装置の製 造方法にある。

び液晶の注入が容易に行える。

[0030] 請求項8に記載される発明は、前記第1基 板上の前記位置合わせマークが、前記第1基板上の走査 線と同一の工程において同一材料の金属薄膜から形成さ れることを特徴とした請求項6記載の液晶表示装置の製 造方法にある。

【0031】この発明によれば、第1基板上の位置合わ せマーク形成のために製造プロセスの増大を招くことが

[0032] 請求項9に記載される発明は、前記第2基 40 板上の前記位置合わせマークが、前記第2基板上の遮光 雌と同一の工程において同一材料から形成されることを 特徴とした請求項6記載の液晶表示装置の製造方法にあ る。

【0033】この発明によれば、第2基板上の位置合わ せマーク形成のために製造プロセスの増大を招くことが table

【0034】請求項10に記載される発明は、前記第2 基板上の前記位置合わせマークが、前記第2基板上の色 部と同一の工程において同一材料から形成されることを 50

特徴とした請求項6記載の液晶表示装置の製造方法にあ

【0035】請求項11に記載される発明は、前記第2 基板上の前記位置合わせマークが前記第2基板上の対向 電極と同一工程において同一材料から形成されるか、又 は、 前記第1基板上の前記位置合わせマークが前記画素 電極と同一工程において同一の透明材料から形成される ことを特徴とした請求項6記載の液晶表示装置の製造方 法にある。

[0036] この発明によれば、第2封止材を光又はU V照射のみにより完全に硬化させることができる。 [0037]

【発明の実施の形態】以下、本発明の第1の実施例のア クティブマトリクス型液晶表示装置(1)及びそのアレイ 基板と対向基板との位置合わせについて図1~6を参照 して詳細に説明する。

【0038】このアクティブマトリクス型液晶表示装置 (1)は、図1の分解斜視図に模式的に示すように、アレ イ基板(100)と対向基板(300)とを含む。そして、アレイ 基板(100)は、周辺に外部回路との棚状接続領域(295)を 配する必要上、その表示領域(290)に対して十分に大き い外形寸法を有し、また対向基板(300)はアレイ基板(10 0)の表示領域(290)と略同等の外形寸法を有している。 【0039】アレイ基板(100)の表示領域(290)は、図2 ~3に示すように、ガラス基板(101)上に、640×3 本の信号線(103)と480本の走査線(111)とが路直交 するように配置され、それぞれ、図1に示すようにアレ イ基板(100)が対向基板(300)と重なり合う領域から棚状 に突き出た棚状接続領域(295)に引き出されている。そ 【0029】この発明によれば、両基板の位置合わせ及 30 して、各信号線(103)と各走査線との交点近傍には、そ れぞれTFT(121)を介して画素電機(151)が配置され、 表示領域(290)は構成される。

【0040】このTFT(121)は、走査線から導出され たゲート電極(111)上に酸化シリコンと窒化シリコンと が積層されて成る絶縁膜(113)が配置され、絶縁膜(113) トにはa-Si:H膝が半導体膜(115)として配置され ている。また、この半導体膜(115)上には、ゲート電極 (111)に自己整合されて成るチャネル保護膜(117)として 窒化シリコンが配置されている。そして、半導体膜(11 5)は、低抵抗半導体膜(119)として配置されるn+型a-S : : H膜およびソース電極(131)を介してそれぞれの 画素電極([5])に電気的に接続されている。また、半導 体膜(115)は、低抵抗半導体膜(119)として配置される n +型a-Si: H膜および信号線(103)から延在されたド レイン電極(105)を介して信号線(103)に電気的に接続さ れている。また、走査線に対し略平行に、しかも画素電 極(151)と重複する領域を有して配置される補助容量線 (161)を備え、画素電板(151)と補助容量線(161)とによ って補助容量(Cs)が形成されている。

[0041]対向基板(300)は、透明なガラス基板(301)

Fに アレイ基板(100)に形成されるTFT(121)、信号 線(103)と画素電極(151)との間隙、走査線と画素電極(1 51)との間隙のそれぞれを遮光するため、酸化クロム薄 職と金属クロム薄膜との積層構造から成るマトリクス状 の遮光層(311)を備えている。そして、遮光層(311)間に は、カラー表示を実現するための赤(R),緑(G), 青 (B) の3原色で構成される色部(321:321-R,321-G,3 21-R)がそれぞれ設けられ、この上に I T O から成る対 向電極(331)が配置されて構成されている。

【0042】また、アレイ基板(100)と対向基板(300)の 10 ク(271, 273, 371, 373)が図5及び6に示すように互いに 各外表面には、図3の積層断面図において模式的に示す ように偏光板(611,613)がそれぞれ貼り付けられてい る。

[0043] そして、このようなアレイ基板(100)と対 向基板(300)とは、表示領域(290)を取り囲むように配置 される封止材(501)を介して5ミクロンの間隙を維持し て対向配置され、アレイ基板(100)と対向基板(300)との 間にはそれぞれ配向膜(601,603)を介してツイスト・ネ マチック型の液晶組成物(400)が挟持されている。

【0044】この封止材(501)は、図1に示すように、 液晶表示装置(1)の一端辺側の離間した位置に2つの液 晶注入孔(511,521)を構成するように配置され、この注 入引(511,521)から液晶組成物(400)は注入される。更 に、図1には省略されているが、注入孔(511)付近の拡 大平面図である図4に示すように、注入孔(511,521)が 村止材(551,553)によって封止されている。

[0045] そして、この実施例の液晶表示装置(1)に よれば、図1に示すように注入孔(511,521)の領域に対 広するアレイ基板(100)および対向基板(300)のそれぞれ に、互いに位置合わせするための位置合わせマーク(27) 1.273.371.373)が配置されている。

【0046】アレイ基板(100)に配置されるそれぞれの 位置合わせマーク(371,373)は、走査線およびゲート電 極(111)の形成と同時に成膜、パターニングされて成 り、図5に示すような白抜き十字マーク状である。ま た、対向基板(300)に配置されるそれぞれの位置合わせ マーク(271,273)は、遮光膜(311)の形成と同時に成膜、 バターニングされて成る、図5に示す略十字状である。 【0047】この実施例でアレイ基板(100)に配置され るそれぞれの位置合わせマーク(271,273)を走査線と同 時に形成したのは、製造プロセスの増大を避けるためで あり、更に走査線のパターニングが他のパターニングに 対して基準となるため誤差の少ない位置合わせが可能と なるためである。しかしながら、パターニングの基準が 信号線(103)となるのであれば、位置合わせマーク(271、 273) は信号線(103) 等と同時に形成するものであっても かまわない。

【0048】また、この実施例で対向基板(300)に配置 されるそれぞれの位置合わせマーク(271,273)を遮光膜 (311)と同時に形成したのは、やはり製造プロセスの増 50 【0053】この後、注入孔(511,521)に注入孔用封止

大を避けるためでが、この他にも色部(321)と同時に形 成するものであってもかまわない。そして、この実施例 では、対向基板(300)に配置されるそれぞれの位置合わ せマーク(271,273)、更には注入孔(551,553)領域には I TOから成る対向電極(331)が延在されて被覆されてい る。これは、ガラス基板(301)、あるいは位置合わせマ 一ク(271,273)等から不所望な不純物が液晶組成物(400) 注入時に内部に侵入することを防止するためである。 【0049】そして、このような2組の位置合わせマー 位置合わせされて、アレイ基板(100)と対向基板(300)と は位置合わせされている。

【0050】図5に位置合わせマーク(271,273,371,37 3) の形状を詳細に示す。対向基板側の位置合わせマーク (271,273)は、幅広等長の二つの線分からなる直交十字 部分(271a)と、これらの線分より幅が狭く長さの短い線 分からなる正方形部分(271b)とが重なり合った形状であ る。アレイ基板側の位置合わせマーク(371,373)は、幅 広の十字形からその内側を抜き取った中抜き太十字部分 20 (371a)と太十字の間の各スパン中に配される正方形の4 つの称りつぶし部分(371b)からなる。図1及び5により 示すように、両基板(100,300)を貼り合わせる前に、二 つのカメラ(701,702)により2対の位置合わせマーク(27 1,273)及び(371,373)付近を上方から観察しながら、両 基板(100.300)間の位置を調整する。2対の位置合わせ マーク(271,273)及び(371,373)が最も良く重なり合った ときに位置合わせが行われたと判断する。

【0051】図6には、アレイ基板側の位置合わせマー ク(271)と対向基板側の位置合わせマーク(371)とがカメ ラ画像中において完全に位置合わせされた状態を示す。 30 位置合わせの際には、まず、上記中抜き太十字部分(371 a) と上記錄りつぶし部分(371b) と上記正方形部分(271b) とにより囲まれた4つの太し字状の領域(711,712,713,7 14)の形状を互いに比較する。これにより、両位置合わ せマーク(271,371)の位置ずれの方向および位置ずれの 程度を容易に判別できるので迅速に位置合わせを行うこ とができる。さらに、上記中抜き太十字部分(371a)の抜 き部分が十字の先に向かって段階的に狭まる形状である ため、上記中抜き太十字形部分(371a)と上記直交十字部 分(271a)との間の間隙(720)を観察することにより、最 終的な位置合わせを行うことができる。

【0052】このようにして両基板(100,300)間の位置 合わせが達成されたならば、両基板(100,300)を互いに 押しつけて貼り付ける。そして、加熱により封止材(50 1)を完全に硬化させる。このようにして得られた空セル を十分に減圧排気した後、減圧のままの状態で、注入孔 (511,521)が形成された端辺を液晶組成物中に浸漬し大 気圧雰囲気に戻す。しばらく後に液晶組成物の注入が完 アオス.

材(551,552)を封入しUV照射により硬化させる。

【0054】図4は、注入孔用封止材(551)を封入した 後の注入刊(511)付近の上面からの平面図であり寸法が 記入されている。この図の例に示すように、注入孔用封 止材(551)は位置合わせマーク(271,371)の領域と重なる ことが多く、例えばアレイ基板側からUVを照射した場 合には、アレイ基板側の位置合わせマーク(271)の影に なる部分にはUVが照射されない。しかし、この影の部 分の面積と幅は小さい。UV硬化樹脂といえども、一般 V硬化樹脂として適当な加熱により硬化が完了するよう なものを選択することができる。

【0055】以上説明したように、この実施例の液晶表 示装置(1)によれば、2つの液晶注入孔(511,553)領域に 対応するアレイ基板(100)には位置合わせマーク(271,27 3)が、また2つの液晶注入孔(511,521)領域に対応する 対向基板(300)には位置合わせマーク(371,373)がそれぞ れ配置され、これに基づいて互いに位置合わせされて構 成されている。

0)とを封止材(501)を介して貼り合わせるに際し、対向 基板(300)として表示領域(290)と略等しい最終外形寸法 のものを用いることができる。よって、大判のガラス基 板から多数個の対向基板(300)を採取することができ、 材料ロスを抑え、しかも生産性を向上させることができ た。

[0057] また、アレイ基板(100)と対向基板(300)と を貼り合わせた後に、対向基板(300)の周辺の不要部分 をスクライブ除去する必要もないので、スクライブ除去 時にアレイ基板(100)に損傷を与える、あるいは不所望 た位置でスクライブされるといったことが防止され、嬰 造歩留まりを大幅に向上させることができる。

[0058] 次に、第2の実施例のアクティブマトリク ス型液晶表示装置(2)を図7に示す。この実施例におい ては、第1の実施例と同様の構成において、液晶組成物 (400)を注入する際に用いる二つの孔(551,552)が被晶表 示装置(2)の相対向する2短辺の略中点に形成されて おり、両基板(100,300)におけるこれらの孔(551,552)の 孔壁をなす個所に位置合わせマーク(271,273)及び(371, 373)が配されている。

【0059】本実施例においては、封止材(501)硬化後 の空セルに液晶組成物(400)を注入する際に、片方の孔 (551)から排気しつつもう片方の孔(552)から液晶物質を 注入させる。このような方法により、第1の実施例に比 べて短時間で液晶の注入をより容易に行うことができ る。また、第1の実施例に比べて2対の位置合わせマー ク(271,273)及び(371,373)の間の距離がより大きいため 位置合わせの精度をより高めることができる。

【0060】第3の実施例の液晶表示装置(3)を図8に 示す。本実施例では、第2の実施例と同様の構成におい 50 れの基板の最終外形の外の周辺領域(800,900) に配され

て、A(551.552)が液晶表示装置(2)の対角に設けられ、 ている。このため、2対の位置合わせマーク(271,273) 及7以(371,373)の間の距離がさらに大きくなり両基板間 (100,300)の適切な位置合わせがさらに容易となる。

10

[0061] 第4の実施例の液晶表示装置(4)について 図9を用いて説明する。第1の実施例と同様の構成にお いて、対向基板側の位置合わせマーク(271)がITOか らなり対向電極(331)と同時に形成された後パターニン グされる。対向基板(300)の孔(551)に対応する領域は [ には常温以上の温度では徐々に硬化が進行するため、U 10 TOによって被覆することはできないが、十分な厚さと 信頼性をもった配向膜(603)を配することで、液晶組成 物(400)中への不所望な不締物の侵入を防止することが できる。この実施例によって、UV照射により注入孔用 封止材全体を完全硬化させることができさらに加熱硬化 を行う必要がない。

[0062] 次に、第1の変形例の液晶表示装置(5)に おける位置合わせについて図10を用いて説明する。第 1の実施例と同様の構成において、孔(511)が一つだけ であって液晶表示装置 (5) の一短辺の中点付近に配さ [0056] このため、対向基板(300)とアレイ基板(10 20 れており、一方の対の位置合わせマーク(271.371)がこ の孔(511)に設けられる。他方の対の位置合わせマーク (273, 373)の中で、アレイ基板側の位置合わせマーク(37 3)は、走査線側棚状接続領域(296)にあって前記一方の 位置合わせマーク(271,371)から最も遠いところに設け られる。これに対応する対向基板側の位置合わせマーク (273)は、対向基板(300)の最終外形の外にあって、アレ イ基板(100)の走査線側棚状接続領域(296)と同一寸法の 層辺領域(800)に配置される。したがって、両基板(100. 300)の貼り合わせの後に、この周辺領域(800)をスクラ 30 イブ除去する必要がある。しかし、アレイ基板側にあっ て走査線側棚状接続領域(296)のみに位置合わせマーク (1371, 1373)を用いる従来の技術に比べて、2対の位置 合わせマーク(271, 273)及び(371, 373)の間の距離を大き く探ることができるため容易に適切な位置合わせを行う ことができる。一方、前記他方の対の位置合わせマーク (371, 373)の平面的な位置は、走査線側棚状接続領域(29 6)の範囲内にあって比較的自由に設定できるため、ある 節囲内で基板サイズが変更された場合にも2対の位置合 わせマーク(271,273)及び(371,373)の位置を一定とする 40 ができる。すなわち、基板サイズの変更が走査線側棚状 接続領域(296)の幅の範囲内であれば、カメラ(701,702) の位置を固定したまま位置合わせ工程を行うことができ る。したがって、上記の実施例の場合のように孔(511,5 21)の位置を変える必要がない。

> 【0063】次に、第2の変形例の液晶表示装置(6)に おける位置合わせについて図11を用いて説明する。-方の対の位置合わせマーク(271, 273)は第1の変形例と 同様であり、他方の対の位置合わせマーク(371,373) は、アレイ基板側のものも対向基板側のものも、それぞ

る。したがって、両基板(100,300)を張り合わせて封止 材を硬化させた後には、両基板(100,300)のそれぞれか ら周辺領域(800,900) をスクライブ除去しなければなら ない。しかし、位置合わせマーク(271,273)及び(371,37 3)を液晶表示装置の対角に配置した場合に、基板サイズ が変更されても周辺領域(800,900) を加えたスクライブ 前の基板の寸法を一定とすることによって、カメラ(70 1,702)の位置を固定したまま位置合わせ工程を行うこと ができる。

[0064]上述したこれら実施例及び変形例では、半 10 を示す模式的な斜視図である。 薬体膨としてa-Si:H膜を備えた逆スタガ橋造のT FTをスイッチ素子として備えたアクティブマトリクス 型の液晶表示装置を例にとり説明したが、この発明はこ の実施例に限定されるものではなく、半導体膜として多 結晶シリコン等を用いたもの、スイッチ素子としてスタ ガ構造のTFTを用いたもの、あるいはスイッチ素子と してMIM (Metal Insulator Metal) 素子を用いたも の等であってもかまわない。また、基板上に駆動回路を 一体に構成したものであっても構わない。

## [0065]

[発明の効果] この発明の液晶表示装置によれば、注入 孔に対応する領域に、一対の電極基板を互いに位置合わ せするための位置合わせマークが配されているため、位 置合わせマークを配するため、最終製品としては不要な 領域を電極基板に設けることが軽減され、これにより基 板の利用効率を高め、優れた生産性を確保することがで きる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例のアクティブマトリクス 型液晶表示装置における基板の位置合わせについて模式 30 的に示す全体斜視図である。

【図2】アクティブマトリクス型液晶表示装置の表示領 域の基本構成について説明するための、絶縁膜及び半導 体膜を省略した模式的な分解斜視図である。

【図3】第1の実施例の液晶表示装置における機能膜の 積層構造について説明するための、模式的な縦断面図で ある。

12 【図4】第1の実施例の液晶表示装置における、位置合 わせマークが配された液晶注入孔について示す部分拡大

平面図である。 【図5】アレイ基板及び対向基板の位置合わせマークの 形状と位置合わせの様子について示す模式的な斜視図で

ある。 【図6】図5の一対の位置合わせマークがカメラ視野中 で合致した際の画像を示す画像図である。

[図7] 第2の実施例における位置合わせマークの配置

【図8】第3の実施例における位置合わせマークの配置 と位置合わせ操作について示す模式的な斜視図である。

【図9】第4の実施例における位置合わせマークの構成 を示すための、図3と同様の形式の模式的な縦断面図で ある。

【図10】第1の変形例における位置合わせマークの配 置と位置合わせ操作について示す模式的な斜視図であ る。

【図11】第1の変形例における位置合わせマークの配 20 置と位置合わせ操作について示す模式的な斜視図であ

【図12】第1の従来例における位置合わせマークの配 置と位置合わせ操作について示す模式的な斜視図であ

「図13】第1の従来例における暦辺領域のスクライブ 除去について説明するための模式的な斜視図である。

【図14】第2の従来例における位置合わせマークの配 置と位置合わせ操作について示す模式的な斜視図であ る。

【符号の説明】

(1)…アクティブマトリクス型液晶表示装置

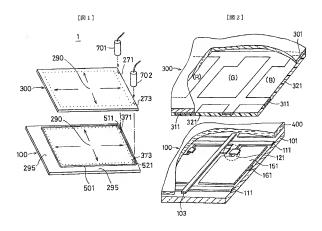
(100)…アレイ基板

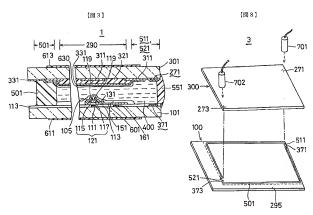
(271), (273), (371), (373)…位置合わせマーク (300)…対向基板

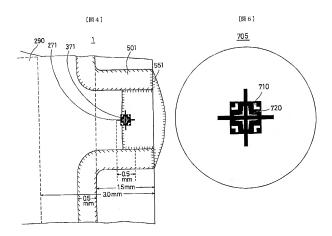
(400)…液晶組成物

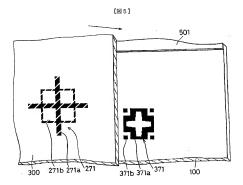
(511)、(521)…液晶注入のための孔

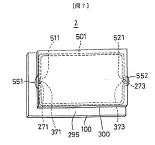
(551), (552)…封止材

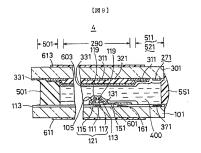


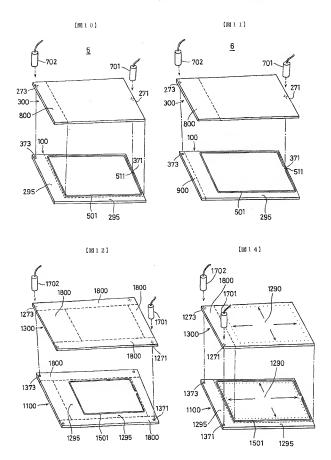




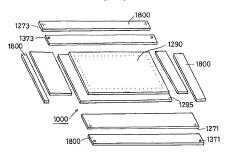








[図13]





## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-303842

(43)Date of publication of application: 18.10.2002

(51)Int.CI.

1/1343 9/00

9/30

(21)Application number: 2001-106275 (22)Date of filing:

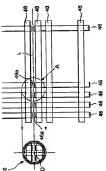
04.04.2001

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP (72)Inventor: NAKAMURA TAKESHI

(54) LIQUID CRYSTAL DEVICE, AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR. AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal device having high accuracy of alignment mark positions for preventing misalignment of assembly between substrates constructing a liquid crystal panel. SOLUTION: The liquid crystal device comprising a twoscreen driving liquid crystal display panel is provided with a plurality of 1st electrodes 46 which are arranged on a 1st substrate forming the liquid crystal panel and separated into two in the longitudinal direction, a plurality of 2nd electrodes 48 which are arranged on a 2nd substrate stuck together with the 1st substrate with a sealing material and faced so as to be orthogonal to the 1st electrodes, and alignment marks 50 which are arranged on the 1st and 2nd substrates, respectively, and formed in the same shape as that of the arrangement the 1st or 2nd electrodes 46, 48 in the separated area A of the 1st electrodes 46, and is characterized in that the center O of the alignment mark 50 is almost positioned on the center line L of the separated area A of the 1st electrodes 46.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

02.02.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

Searching PAJ 2/2 ページ

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (n)公開特許公報 (A)

# (II)特許出願公開番号 特開2002-303842

(P2002-303842A) (43)公開日 平成14年10月18日(2002.10.18)

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

弁理士 上柳 雅誉 (外1名)

(74)代理人 100095728

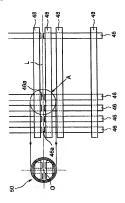
(51) Int. Cl	. 7	識別記号	FΙ					7-7	l-h' (参考)	
G02F	1/13	101	G02F	1/13		101		2H088		
	1/1339	505		1/13	39	505		2H089		
	1/1343			1/13	43			2H092		
G09F	9/00	338	G09F	9/00		338		5C094		
	9/30	343		9/30		343	7	5G435		
			審	查請求	未請求	請求項の	)数13	OL	(全12頁)	
(21)出願番号 2		特願2001-106275(P 2001-106275	(71) 出	(71)出額人 000002369						
			i		セイコー	エブソン	株式会	社		
(22)出願日		平成13年4月4日(2001.4.4)	1		東京都新	宿区西新	宿27	1日4番	. 号	
			(72) 発	明者	中村 猛					

最終百に続く

## (54) 【発明の名称】液晶装置、液晶装置の製造方法および電子機器

## (57) 【要約】

【課題】被晶パネルを構成する基板同士の組み付けズレを防止するためのアライメントマークの位置精度が高い液晶装置の提供を目的としている。



【特許請求の範囲】

「糖业項1] 二面面駆動の液晶表示パネルから成る液 品装置において、

波思表示パネルを形成する第1の基板上に設けられ、そ の長さ方向で2つに分断された複数の第1の電極と、

前記第1の基板とシール材によって貼り合わされる第2 の基板上に設けられ、前記第1の電極と略直交するよう に対向される複数の第2の電極と、

前記第1の基板と前記第2の基板のそれぞれに設けら れ、前記第1の電極の分断領域における前記第1または 10 電極の配置形態と同じ形態を成すアライメントマーク

第2の電極の配置形態と同じ形態を成すアライメントマ ークと、

を具備し、

前記アライメントマークの中心は、前記第1の電極の分 断領域における中心線上にほぼ位置していることを特徴 とする液晶装置。

【請求項2】 液晶が注入される前記シール材の開口部 が、前記第1の電攝の分断領域における前記中心線上に 形成され、シール材の前記開口部に前記アライメントマ ークが形成されていることを特徴とする請求項1に記載 20 の液晶装置。

【請求項3】 前記アライメントマークは、前記第1の 基板上に設けられた第1のマークと、前記第2の基板上 に前記第1のマークに対応して設けられた第2のマーク とから成り、

前記第1のマークは、第1の電板の分断領域における第 1 の雷振の配置形態を成すパターンが円形の枠内に描画 されて成り、

前記第2のマークは、前記分断領域における第2の電極 の配置形態を成すパターンが円形の枠内に描画されて成 30 装置の製造方法。 ることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の液 品装置。

【請求項4】 二画面駆動の液晶表示パネルから成る液 晶装置において、

液晶表示パネルを形成する第1の基板上に設けられ、そ の長さ方向で2つに分断された複数の第1の電極と、 前記第1の基板とシール材によって貼り合わされる第2

の基板上に設けられ、前記第1の電極と路直交するよう に対向される複数の第2の電極と、

前記第1の基板と前記第2の基板のそれぞれに設けら れ、前記第1の電極の分断領域における前記第1または 第2の電板の配置形能と同じ形態を成すアライメントマ ーカン.

を具備し、

前記アライメントマークは、液晶が注入される前記シー ル材の開口部と対応する位置に設けられ、その中心が前 記第1の電極の分断領域における中心線上にほぼ位置し ていることを特徴とする液晶装置。

【請求項5】 請求項1ないし請求項4のいずれか1項 に記載された液晶装置を表示部として備えていることを 50 1の母基板上に形成するとともに、前記第1の電極と略

特徴とする電子機器

2 【請求項6】 互いに貼り合わされる2枚の基板間に液 品を封入して液晶装置を製造する方法において、

その長さ方向で2つに分断された複数の第1の電極を第 1の母基板上に形成するとともに、前記第1の電極と略 直交するように対向される複数の第2の電極を第2の母 基板上に形成する工程と、

前記第1の母基板と前記第2の母基板のそれぞれに、前 記第1の電極の分断領域における前記第1または第2の を、その中心が前記第1の電極の分断領域における中心 線トにほぼ位置するように形成する工程と、

第1の母基板と第2の母基板とをシール材によって貼り 合わせて大判パネルを形成する工程と、

前記大判パネルを割断して、短冊状のパネルを形成する 1 次プレーク工程と、

前記シール材に設けられた液晶注入口を通じて、前記短 冊状パネルのセル内に液晶を注入した後、前記液晶注入 口を封止する工程と、

液晶が注入された前記短冊状パネルを割断して、所望の 大きさのパネルを形成する2次プレーク工程と、

を具備することを特徴とする液晶装置の製造方法。

【請求項7】 前記アライメントマークは、第1または 第2の電極を母基板上に形成する時にこれらと同時に同 様の方法で形成されることを特徴とする請求項6に記載 の液晶装置の製造方法。

【請求項8】 一画面駆動の液晶表示パネルの電極パタ ーン形成に用いられるマスクを使用して、前記電板をパ ターン形成することを特徴とする請求項7に記載の液晶

【請求項9】 前記シール材の液晶注入口を、前記第1 の電極の分断領域における前記中心線上に形成し、シー ル材の前記開口部に前記アライメントマークを形成する ことを特徴とする請求項6ないし請求項8のいずれか1 項に記載の液晶装置の製造方法。

【請求項10】 前記アライメントマークは、前記第1 の基板上に設けられた第1のマークと、前記第2の基板 上に前記第1のマークに対応して設けられた第2のマー クとから成り、

40 前記第1のマークは、第1の電板の分断領域における第 1 の電極の配置形態を成すパターンが円形の枠内に描画 されて成り、

前記第2のマークは、前記分断領域における第2の電極 の配置形態を成すパターンが円形の枠内に描画されて成 ることを特徴とする請求項6ないし請求項9のいずれか 1項に記載の液晶装置の製造方法。

【請求項11】 互いに貼り合わされる2枚の基板間に 液晶を封入して液晶装置を製造する方法において、

その長さ方向で2つに分断された複数の第1の電極を第

直交するように対向される複数の第2の電極を第2の母 基板上に形成する工程と、

前記第1の母基板と前記第2の母基板のそれぞれに、前 記第1の電極の分断領域における前記第1または第2の 電極の配置形態と同じ形態を成すアライメントマーク を、その中心が前記第1の電極の分断領域における中心

線上にほぼ位置するように形成する工程と、 第1の母基板と第2の母基板とをシール材によって貼り

合わせて大判パネルを形成する工程と、 前紀大判パネルを割断して、短冊状のパネルを形成する 10

1 次プレーク工程と、 前記シール材に設けられた液晶注入口を通じて、前記短 冊状パネルのセル内に液晶を注入した後、前記液晶注入 口を封止する工程と、

液晶が注入された前記短冊状パネルを割断して、所望の 大きさのパネルを形成する2次ブレーク工程と、

を具備し、

前記アライメントマークは、前記シール材の液品注入口 と対応する位置に形成されることを特徴とする液晶装置 の製造方法。

【請求項12】 液晶装置を構成する2枚の基板を互い に貼り合わせる方法において、

2つに分断された複数の第1の電極を第1の基板上に形 成し、前記第1の電極と略直交するように対向される複 数の第2の電極を第2の基板上に形成する工程と、

前記第1の基板と前記第2の基板のそれぞれに、前記第 1の電極の分断領域における前記第1または第2の電極 の配置形態と同じ形態を成すアライメントマークを、そ の中心が前記第1の電極の分断領域における中心線上に ほぼ位置するように形成する工程と、

前記アライメントマークを利用して前記第1の基板と前 記第2の基板とをシール材によって貼り合わせる工程 Ł,

を具備することを特徴とする基板の貼り合わせ方法。 【請求項13】 前記アライメントマークは、前記シー ル材の液晶注入口と対応する位置に形成されることを特 巻とする請求項12に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0 0 0 1]

【発明の属する技術分野】本発明は、特に二画面駆動単 40 純マトリックス液晶表示パネルを形成する2枚の基板同 士の組み付けズレを防止できる液晶装置及びその製造方 法、並びに、このような液晶装置を備えた電子機器に関 する.

## [0002]

【従来の技術】近年、携帯電話機、携帯型コンピュー タ、ビデオカメラ等といった電子機器の表示部として、 液晶装置が広く用いられている。この液晶装置は、原理 的には、電極が形成された基板間に挟持された被晶に電 圧を印加することによって素子を通過する光を制御する 50 め、品質上の大きな問題となってしまう。

電気光学装置である。

【0003】 このような液晶装置を製造する場合には、 まず、ガラス基板上に形成されたIT〇膜をパターンニ ングして駆動用電極を形成し、電極が形成された面に液 晶配向用の有機膜を印刷焼成により形成するとともに、 有機膜の表面を配向処理する。続いて、配向処理された 2枚のガラス基板同士を一定の間隔(セル厚)をもって 対向させ、シール材(接着剤)で貼り合わせる。その 後、貼り合わされたガラス基板を所定のパネル形状に切 断して分離する。そして、最後に、パネル内に電気光学 物質としての液晶を注入して、パネルを駆動用の回路に 接続すれば、液晶装置が完成する。

【0004】ところで、単純マトリックス液晶表示パネ ルにおいては、画面サイズが大きくなると、走査電極の 増加を図る目的から、二画面駆動が行なわれることが多 い。図14には、二画面駆動単純マトリックス液晶表示 パネルを構成する2枚の基板に設けられる電極の形成形 態が示されている。2枚の基板は、この平面図に示され るように、一方の基板上に形成される信号電板122と 他方の基板上に形成される走査電極132とが路直交す る状態で対向するように、互いに貼り合わされる。この 場合、二画面駆動型を実現するために、信号電極122 は、表示領域の略中心線し付近で2つに分断されてい る。なお、走査電極132は二画面駆動でない単純マト リックス液晶表示パネルの場合と同様に切れ目無く延び ている

[0005] 図において、走査電極122と信号電極1 32とが液晶表示パネルの厚さ方向で重なる部分が、そ れぞれの画素となる。つまり、画素となるべき部分にお いては、液晶表示パネルの厚み方向の上下に必ず走査電 30 極132と信号電極122とが配置されている必要があ る。したがって、信号電極122が2つに分断されてい る二両面駆動型の液晶表示パネルを組み立てる場合にお いては、図15に示されるように、信号電極122の長 さ方向 (図中、X方向) での2枚の基板間の組み付けズ レが所定量を超えると、信号電極122の分断に沿った 画素のサイズが減少し、分断部(信号電極の突き合わせ 部分) において、画素間のギャップが増大して、線状の 点灯不良が発生する可能性がある。しかも、二画面駆動 単純マトリックス液晶表示パネルにおけるこの信号電極 1 2 2 の長さ方向の組み付けズレの許容量は、正常な画 素間のギャップの大きさが同程度の二画面駆動でない単 純マトリックス液晶表示パネルに比べると、遥かに小さ い。そのため、二画面駆動単純マトリックス液晶表示パ ネルにおいては、信号電極122の長さ方向の組み付け ズレが特に問題となることが多い。そして、このような 信号電板122の分断部付近の画素間ギャップの増加 は、ごく僅かな場合であっても、人間の目の特性とし て、他の部分と異なる箇所がはっきりと認識されるた

【0006】こうしたことから、従来においては、液晶 表示パネルを形成する2枚の基板にアライメントマーク を施し、各基板のアライメントマークが一致するように 基板同士を貼り合わせることにより、基板間の組み付け ズレを防止するようにしている。

[0007] 図16は、液晶パネルを多数個取ることが できる大判パネルにおけるアライメントマークの形成形 態を示している。一般に、液晶装置に用いる液晶パネル は、個々のパネルに対応した第1および第2の基板を1 枚ずつ形成して貼り合わせる場合もあるが、特に小型の 10 電極の配置形態と同じ形態を成すアライメントマークと 液晶装置を製造する場合には、液晶パネルを多数個取る ことができる大判パネルに対して複数の液晶装置分の配 線パターンを形成するなど、製造工程の途中までは、大 判パネルのままで処理を行ない、その後、大判パネルを 個々の基板に分割することが多い。

【0008】 このような大判パネル142 におけるアラ イメントマーク140は、大判パネル142を構成する 2枚の透明な各大判ガラス基板142A, 142B上の 周級部に複数個、最終的な製品となる1パネル分に相当 する各パターンP内に例えば1つずつ形成されている。 20 前記第2の母基板のそれぞれに、前記第1の電極の分断 あるいは、大判ガラス基板142A、142Bの周縁部 もしくは各パターンP内のいずれかに形成されている。 いすれの場合にも、アライメントマーク140は、一方 の大判パネル基板142Aに形成される図17の(a) に示されるような雌マーク140Aと、他方の大判パネ ル基板142Bに形成される図17の(b)に示される ような雄マーク140Bとから成り、図17の(c)に 示されるように、これらのマーク140A、140Bが 一致するように基板142A, 142B同士が貼り合わ される。

#### [0 0 0 91

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、大判パ ネル基板142A、142Bの周縁部に形成されるアラ イメントマーク140の位置精度は、マスク製造方法に よって左右される。そのため、このアライメントマーク 140を信頼して基板142A, 142B同士を貼り合 わせても、二画面パネルの突き合わせ部分(信号電極1 22の分断部)において高い位置精度を確保すること、 すなわち、アライメントマーク140だけで信号電板1 22の長さ方向での基板142A, 142B同士の組み 40 付けプレを防止することは困難である。また、各パター ンP内におけるアライメントマーク140については、 全方向への組立ズレ防止を目的としているため、二画面 パネルに対して有効になりきれていない。

【0 0 1 0】本発明は前記事情に着目してなされたもの であり、その目的とするところは、液晶パネルを構成す る基板同士の組み付けズレを防止するためのアライメン トマークの位置精度が高い液晶装置、液晶装置の製造方 法および電子機器を提供することにある。

[0011]

(課題を解決するための手段) 前記課題を解決するため に、本発明は、二画面駆動の液晶表示パネルから成る液 品装置において、液晶表示パネルを形成する第1の基板 上に設けられ、その長さ方向で2つに分断された複数の 第1の重極と、前記第1の基板とシール材によって貼り 合わされる第2の基板上に設けられ、前記第1の電極と 略直交するように対向される複数の第2の電極と、前記 第1の基板と前記第2の基板のそれぞれに設けられ、前 記算1の電極の分断領域における前記第1または第2の を風備し、前紀アライメントマークの中心は、前記第1 の電極の分断領域における中心線上にほぼ位置している ことを特徴とする。

【0012】また、本発明は、互いに貼り合わされる2 枚の基板間に液晶を封入して液晶装置を製造する方法に おいて、その長さ方向で2つに分断された複数の第1の 電極を第1の母基板上に形成するとともに、前記第1の 電板と路直交するように対向される複数の第2の電極を 第2の母基板上に形成する工程と、前記第1の母基板と 領域における前記第1または第2の電極の配置形態と同 じ形態を成すアライメントマークを、その中心が前記第 1の電極の分断領域における中心線上にほぼ位置するよ うに形成する工程と、第1の母基板と第2の母基板とを シール材によって貼り合わせて大判パネルを形成する工 程と、前記大利パネルを割断して、短冊状のパネルを形 成する1次プレーク工程と、前記シール材に設けられた 海品注入口を通じて、前記短冊状パネルのセル内に液晶 を注入した後、前記液晶注入口を封止する工程と、液晶 30 が注入された前記短冊状パネルを割断して、所望の大き さのパネルを形成する2次プレーク工程とを具備するこ とを特徴とする。

【0013】これらの液晶装置及びその製造方法によれ ば、アライメントマークの位置を合わせがそのまま分断 領域における電極同士の位置合わとなるため、アライメ ントマークを見ながら2枚の基板同士を組み付けるだけ で、基板間の組み付けズレを防止でき、製造歩留まりを 高めて、結果として製造コストを下げることができる。 【0014】また、上記構成において、液晶が注入され る前記シール材の開口部は、前記第1の電極の分断領域 における前配中心線上に形成され、シール材の前配開口 部に前記アライメントマークが形成されていることが望 ましい。あるいは、前記アライメントマークは、液晶が 注入される前記シール材の開口部と対応する位置に設け られ、その中心が前記第1の電極の分断領域における中 心線上にほぼ位置していることが望ましい。このように シール材の間口(液晶注入口)にアライメントマークを 設けると、液晶注入口を目印にアライメントマークを見 つけることができる(アライメントマークの視認性が良 50 好になる) だけでなく、基板同士の位置合わせを液晶注 入口を用いて大幅把に行なった後、顕微鏡等でアライメントマークを観察しながら微微態と、、分断領域における電極同土を正能に位置合わせして2枚の基板向しを組み付けることができる。また、前記2次プレイク工程で所望の大きさのパネルまで切り出した後でも、液晶注入口とともにアライメントマークが残存するため、この段階で最終的次確認を行なうこともできるようになる。また、シール材の液晶注入口は、各電機パターン間の薄膜処理されていない部分であり、間に各種の膜(薄膜)が介在していないため、この部分にアライメントマークを10歳けると、膜を介すこと無く直接にアライメントマークを破験でき、アライメントマークの視認性が良好とな

【0015】また、前記アライメントマークは、前記第 1の基板上に設けられた第10マークと、前記第2の基 板上に前記第10マークに対応して設けられた第20マ ークとから成り、前記第10マークは、第10電極の分 斯縦域における第10電極の配配形態を成すパターンが 円形の枠内に指面されて成り、前記第20マークは、 3分所領域における第20電板の配配形態を成すパター 20 ンが円形の枠内に指面されて成ら、前記第20マークは、この ような構成によれば、マークの形成わよびマークの位置 合わせが18点えてあっ

【0016】また、前記アライメントマークは、第1または第20電極を母基板上に形成する時にこれらと同時に同様の方法で形成されることが望ましい。このように、各基板上に電板を形成する時に同時に同様の方法でアライメントマークを形成すれば、アライメントマークの位置精度は、電極のパターンの位置精度とも後する。すなわち、分所領域における中心線とアライメントマー30の中心とが一致し、電極の実際のアライメント大線とアライメントマークの中心とが一致し、電極の実際のアライメント状態とアライメントで、自動駆動をあると、一致する。この場合、特に、一両面駆動の液晶表表パペネルの電極パターン形成に用いられるマスクを使用して電極をパターン形成すると、コスト面で有益であり、大型のマスクを使用することもできる。

#### [0017]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明 の一家施形態について説明する。

(0018) 一般に、比較的小型の液晶パネルを有する 40 液晶表置の製造工程においては、図1および図2に示す多数個限りの製造力法を用いる場合が多い。この製造力法においては、まず、透明な2枚の母基板11,12の表面にスパッタリングによって透明な薄電機(例えば、ITO (indium tim oxide) 欄)を形成した後、フォトリソグラフィによって後述する透明電極46,48(図3および図4等脚)を形成する(表面横漕が広、電板形成工程)・・・図2参贈)とともに、配向膜を印刷する(配向処理・図2参贈)とともに、配向膜を印刷する(配向処理・図2参贈)とともに、配向膜を印刷する(配向処理・図2参贈)とともに、配向膜を印刷する(配向処理・図2参贈)とともに、配向膜を印刷する(配向処理・図2参贈)とともに、配向膜を印刷する(配向処理・図2参照)といるに貼り合わせて図1050

(a) に示す大判パネル10を形成する。次に、この大 料パネル10の母基板11,12のそれぞれの表面上に 同様に形成されたスクライブ南は国示せず)を形成し (1次スクライブ)、これらのスクライブ浦16 x に沿 って折割力を加えることによって母基板11,12をそ れぞれ破断させ(1次プレイク)、図1の(b)に示す 相無パネル13を形成する。

【0019】この短冊パネル13を形成すると、母基板 11,12を被断させた部分にシール材の開口部が露出 するので、この開口部から被晶を注入し、その後、開口 部を封止材等によって閉鎖する。

【0021】図3および図4は、前述のように形成され た二両面駆動単純マトリックス型の液晶パネル14の概 路構造を示すものである。この液晶パネル14は、透明 な2つの基板41、基板42同士がシール材43によっ て貼り合わせられ、シール材43の内側であって基板4 1. 42の間に液晶44が封入されている。ここで、液 品注入口43aは封止材45によって封鎖されている。 【0022】基板41の内面上には透明電極としての信 号電板 (パターン電極) 46および配向膜47が形成さ れ、信号電極46はシール材43の外側へ出て基板張出 部41a上に引き出された配線となっている。また、基 板42の内面上には透明電板としての走査電極(パター ン電極) 48および配向膜49が形成され、走査電極4 8 は図示しない上下導通部(例えば異方性導電体として 形成されたシール材43の一部によって構成される。) を介して基板張出部41 a上の配線に接続されている。 【0023】 基板張出部41aの表面上には、液晶駆動 同路を構成した半導体チップ50が実装される。半導体 チップ50は、透明電極46、48に導通した基板張出 部41a上の配線と、基板張出部41aの端部に形成さ れた入力端子51とに共に導通接続された状態となって いる。ここで、液晶装置の構造に応じて、フレキシブル 配線基板を入力端子51に導通接続したり、基板張出部 4 1 a の表面をシリコーン樹脂等の封止材によって封止 したりするなどの処理が行なわれる。

【0024】 このような二両商駆動単純でトリックス型 酸温パネル14の2枚の基板41,42に設けられる電 極46,48の形成形態が関5に平面的に示されてい る。前述した関4にも示されるように、2枚の基板4 1,42は、一方の基板41上に形成される信号電極4 506と他力の基板42上に形成される信号電極48とが略

10

直交する状態で対向するように、互いに貼り合わされ る。この場合、二画面駆動型を実現するために、信号電 極46は、表示領域の中心線し付近で2つに分断されて いる。一方、走査電極48は二画面駆動でない単純マト リックス液晶表示パネルの場合と同様に切れ目無く延び ている。したがって、以下においては、信号電極をセグ メント電極と称し、また、走査電極をコモン電極と称す るととにする。

[0025]また、図5には、セグメント電極46の長 さ方向での基板41、42間の組み付けズレを防止する 10 P2のアライメント状態とが、セグメント電極46の長 第1の実施形態が示されている。この実施形態では、組 み付けズレを防止する手段として、各基板41、42に 円形のアライメントマーク50 (50A, 50B) が設 けられている。このアライメントマーク50は、基板4 1. 42同士が張り合わされた状態では、セグメント電 極46の分断領域(セグメント電極46の端面46a同 十が突き合わされる領域) におけるセグメント電極46 とコモン電極48との配列状態(形成形態)をそのまま 再現した形態、すなわち、図5 に円形で示されるセクメ ント電極46の分断領域Aをコピーして(切り取って) これを中心線しに沿って平行に移動した形態を成してい

[0026] 具体的には、アライメントマーク50(図 6の(c)参照)は、図6の(a)に示される第1のマ ーク50Aと、図6の(b)に示される第2のマーク5 0 Bとから成る。第1のマーク50Aは、分断領域Aに おけるセグメント電極46の配列状態(パターンP1) が円形の枠CI内に描画されて成る。一方、第2のマー ク50Bは、分断領域Aにおけるコモン電極48の配列 状態 (バターンP2) が円形の枠C2内に描画されて成 30 これらのマーク50A、50BのパターンP1、P 2は、前述した表面構造形成(電極形成工程…例2巻 照) において、電極46, 48のパターンを形成する時 に、これらと同時に形成される。つまり、マーク50 A、50Bは、電極46、47と全く同じようにして同 じ材料によりバターニング形成される。そのため、第1 のマーク50Aは、セグメント電極46が形成されてい る一方の基板41側に設けられ、第2のマーク50B は、コモン電極48が形成されている他方の基板42側 ている。また、本実施形態では、アライメントマーク5 0 の中心 (円形の枠の中心) Oが中心線L (本実施形態 において、中心線しは、互いに対向するセグメント電極 46, 46の端面46a, 46a間の中心を通るように 延びている。)上に位置している。なお、ここで言う中 心線しとは、パネル14をその厚さ方向と垂直な任意の 平面で切断した際に、セグメント電極46、46の分断 領域の中心に位置する線のことであり、アライメントマ ~ク50A,50Bが設けられる而と同一の面上に存在 する仮想線のととである。

[0027] このように、各基板41、42上に電極4 6.48をバターンニング形成する時に同時に同様の方 法でアライメントマーク50A、50B(パターンP 1. P2) を形成すれば、マーク50A. 50Bの位置 精度は、電極46、48のバターンの位置精度と合致す る(したがって、マスク製造時の誤差をひろわない)。 すなわち、分断領域Aにおける中心線Lとアライメント マーク50の中心〇とが一致し、電極46,48の実際 のアライメント状態と、マーク50内のパターンP1. さ方向で完全に一致する。つまり、基板41、42をア ライメントして貼り合わせる際には、実際の電極46, 48のアライメント状態がリアルタイムでアライメント マーク50の円形の枠内に映し出される状態となる。し たがって、顕微鏡等でアライメントマーク50A、50 Bを観察しながら、分断領域Aにおける電極46、48 同士を位置合わせして2枚の基板41、42同士を組み 付ければ、セグメント電極46の長さ方向での基板4 1. 42間の組み付けズレを防止でき、製造歩留まりを 高めて、結果として製造コストを下げることができる。 【0028】基板組立時に特に重視すべき分断領域Aと 基板組立時に用いるアライメントマーク50との相対精 度がこのように高ければ、マスク製造時から電極のバタ ーンニングまでの各工程の製造バラツキを合わせて考え てみても、アライメントマーク50の信頼性が向上する 結果として歩留りが向上することは、当然のことと言え る。このようなバターン形成方法であれば、各バターン の絶対精度がそれほど高くなくても、相対精度をある程 度高く確保できる。したがって、マスク費用を抑えられ (精度が高いマスクは価格も高い)、大型加工が可能と なる(大型のマスクが使用できる)。この場合、特に、 一画面駆動の液晶表示パネルの電極バターン形成に用い られるマスクを使用して、電極をバターン形成すると有 益である。 [0029] 図7には、セグメント電極46の長さ方向 での基板41.42間の組み付けズレを防止する第2の 実施形態が示されている。本実施形態においては、第1

の実施形態における具体的な例として、アライメントマ ーク50がシール材43の液晶注入口43aの位置に対 であって第1のマーク50Aと対応する位置に設けられ 40 応して設けられている。具体的には、例えば一方の基板 41上には、セグメント電極46とともにシール材43 が設けられ、この基板41上におけるシール材43の液 品注入口43aの位置(開口の内側)に第1のマーク5 0 Aが形成されている。との場合、液晶注入口43aの 中心軸し、は、セグメント電極46同士が対向する分断 領域Aの中心線Lと一致しており、第1のマーク50A の中心〇を通っている。一方、他方の基板42トには 第1のマーク50Aと対応する位置に、第2のマーク5 0 Bが形成されている。なお、図7は、基板41、42 50 同士が張り合わされた状態で示されている。

[0030] このように、シール材43の液晶注入口4 3 a にアライメントマーク50を設けると、あるいは、 セグメント電極46間士が対向する分断領域Aの中心線 L上にシール材43の液晶注入口43aを設けると、液 基注 A口43gを目的にアライメントマーク50を見つ けることがてきる(アライメントマーク50の視認性が 良好になる)だけでなく、基板41,42同士の位置合 わせを液晶注入口43 aを用いて大雑把に行なった後、 顕微鏡等でアライメントマーク50A、50Bを観察し ながら微調整して、分断領域Aにおける電極46,48 10 同十を正確に位置合わせして2枚の基板41、42同士 を組み付けることができる。また、前述した2次プレイ クによって最終的な液晶パネル14まで切り出した後で も、液晶注入口43aとともにアライメントマーク50 が残存するため、この段階で最終的な確認を行なうこと もできるようになる。

【0031】また、シール材43の液晶注入口43a は、各電極バターン46、48間の薄膜処理されていな い部分であり、間に各種の膜(薄膜)が介在していない ため、この部分にアライメントマーク50を設けると、 腱を介すこと無く直接にアライメントマーク50を観察 でき、アライメントマーク50の視認性が良好となる。 【0032】図8は、アライメントマーク50をシール 材43の液晶注入口43aに設ける前述した第2の実施 形態を 具体的に、大利パネル10に適用した例を示し ている。図示のように、一方の母基板11には、シール 材43とともにセグメント電極46を形成したセグメン ト領域S (最終的な製品となる1パネル分に相当する各 バターンPに対応)が多数形成され、他方の母基板12 には コモン電極4.8を形成したコモン領域C(景終的 30 な製品となる1バネル分に相当する各バターンPに対 応) が多数形成されており、各セグメント領域Sの液晶 注入□43aに第1のマーク50Aが設けられるととも に、各コモン領域Cの第1のマーク50Aと対応する位 置に第2のマーク50Bが設けられている。

【0033】また、セグメント領域S同士(コモン領域 C同十)の間にアライメントマーク50の形成が可能な 空きスペースがあるこのような大利パネル形態にあって は、図9 に示されるように、液晶注入口43 a以外の空 き領域にアライメントマーク50を形成しても良い。と 40 【図2】本発明の第1の実施形態に係る液晶装置の製造 の場合でも アライメントマーク50の中心〇を分断領 域Aの中心線L上に位置させることが重要である。しか しながら、図10に示されるように、セグメント領域S とコモン領域Cとが交互に密集して形成される場合(例 えば携帯電話機の場合) には、アライメントマーク50 の形成用のスペースを確保することが困難であるため、 とのような場合にとそ、アライメントマーク50をシー ル材43の液晶注入<br />
口43a<br />
に設けることが有益とな

【0034】図11は、前述したようにアライメントマ 50 設けられた第2の実施形態を示す概略平面図である。

ーク50が設けられた液晶パネル14を各種の電子機器 の表示装置として用いる場合の一実施例を示している。 ことに示す電子機器は、表示情報出力源70、表示情報 処理回路71、電源回路72、タイミングジェネレータ 73. そして、液晶装置74を有する。また、液晶装置 74は、液晶表示パネル75および駆動回路76を有す る。液晶パネル75としては、前配液品パネル14を用 いることができる。

【0035】表示情報出力源70は、ROM、RAM等 といったメモリ、各種ディスク等といったストレージユ ニット、デジタル画像信号を同調出力する同調回路等を 備え、タイミングジェネレータ73によって生成された 各種のクロック信号に基づいて、所定フォーマットの画 像信号等といった表示情報を表示情報処理回路71に供 給する。

【0036】表示情報処理回路71は、シリアルーバラ レル旁掾同路や、増幅・反転回路、ローテーション同 路、ガンマ補正回路、クランブ回路等といった周知の各 種回路を備え、入力した表示情報の処理を実行して、そ 20 の画像信号をクロック信号CLKとともに駆動回路76 へ供給する。また、電源同路72は、各様成要素に所定 の電圧を供給する。

[0037] 図12は、電子機器の具体例であるモバイ ル型のパーソナルコンピュータ80を示している。ここ に示すパーソナルコンピュータ80は、キーボード81 を備えた本体部82と、液晶表示ユニット83とを有す る。液晶表示ユニット83は、前述した液晶装置14を 含んで構成されている。

【0038】図13は、電子機器の他の実施例である携 帯電話機を示している。 ここに示す携帯電話機90は、 複数の操作ボタン91と液晶装置14とを有している。

[0039]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 液基パネルを構成する基板同士の組み付けズレを防止す るためのアライメントマークの位置精度が高い液晶装置 を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係る液晶装置の製造 工程を概略的に示す斜視図である。

T稈のフローチャートである。

[図3] 本発明の第1の実施形態に係る液晶装置の平面 図である。

【図4】図3の液晶装置の断面図である。

【図5】図3の満品装置の基板上に形成される電極の形 成形態および電極のアライメント用のマークを示す概略 平面図である。

【図6】アライメントマークの形態図である。

【図7】アライメントマークがシール材の液晶注入口に

【図8】 アライメントマークがシール材の液晶注入口に 設けられた第2の実施形態を大判パネルに適用した例を 示す斜視図である。

【図9】 大判パネルにおけるアライメントマークの配置 状態の変形例を示す概念図である。

【図10】セグメント領域とコモン領域とが交互に密集 して形成された電極配置形態におけるアライメントマー クの適用を示す概念図である。

【図11】本発明の液晶装置が適用される電子機器のブ ロック図である。

【図12】電子機器の一実施例であるパーソナルコンピ ュータの斜視図である。

【図13】電子機器の他の実施例である携帯電話機の斜 視図である。

【図14】従来の二画面駆動型液晶表示パネルの一般的 た電極形成形態を示す概略平面図である。

【図15】図14の電極形成形態において、基板同士が

組み付けズレを起こした状態を示す平面図である。

1.4 【図16】従来のアライメントマークの形成形態を示す 斜視図である。

【図17】従来のアライメントマークの形態図である。 【符号の説明】

14…液晶パネル (液晶装置)

11…母基板 (第1の母基板) 12…母基板 (第2の母基板)

41…基板 (第1の基板)

10 42…基板 (第2の基板)

43…シール材

43 a…液晶注入口

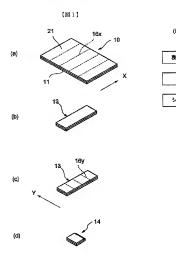
46…セグメント電極(第1の電極)

48…コモン電板 (第2の電極)

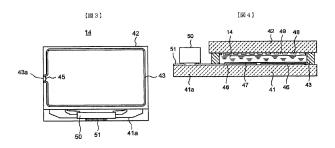
50…アライメントマーク 50A…第1のマーク

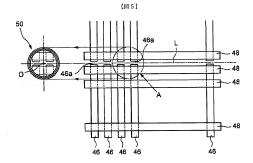
50B…第2のマーク

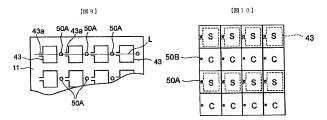
[図2]

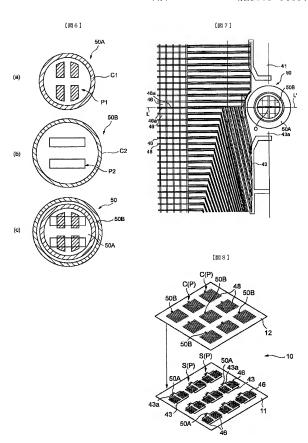




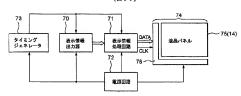


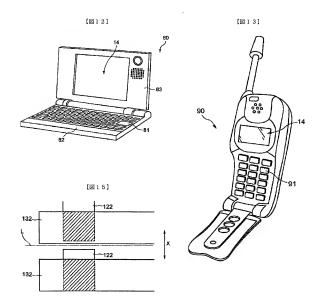


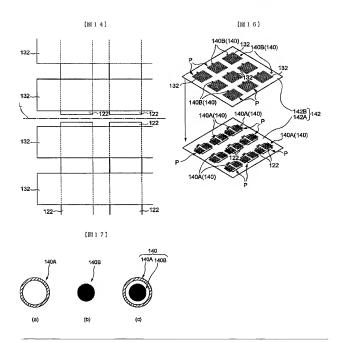












## フロントページの続き

Fターム(参考) 2H088 FA01 HA01 HA02 MA20 2H089 LA22 LA24 LA41 NA24 QA16 2H092 GA13 NA25 5C094 AA42 AA43 BA43 CA19 DA11 EA04 EA07 EB02 CB01 5G438 AA00 AA17 BB12 CC13 DD01

EE33 FF00 KK03 KK05

## PATENT ARSTRACTS OF JAPAN



(11)Publication number:

2000-039599

(43)Date of publication of application: 08.02.2000

(51)Int.CI.

G02F 1/13

(21)Application number: 10-208284 (22)Date of filing:

23 07 1998

(71)Applicant: HITACHI LTD

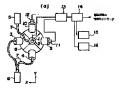
(72)Inventor: MARUYAMA SHIGENOBU

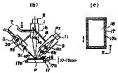
OSHIDA YOSHITADA SASAKI EIJI NIWA SUSUMU

(54) METHOD AND DEVICE FOR INSPECTING LIQUID CRYSTAL DISPLAY SUBSTRATE AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY SUBSTRATE

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To display visually a size measurement result of an inspection objective pattern in a liquid crystal display substrate such as a TFT(thin film transistor) substrate and a CF(color filter) substrate. SOLUTION: This device is provided with a vertical illumination optical system consisting of a vertical illumination mirror barrel 1 illuminating a liquid crystal display substrate 18 loaded on an XY stage 17 from just above to obtain an optical image on the liquid crystal display substrate 18 and a CCD camera 2 and an optical cut-out optical system consisting of slit projection optical X. Y mirror barrels 3, 4 tilted at 45° on the liquid crystal substrate 18 to illuminat and obtain the optical image on the liquid crystal display substrate 18. observation optical system X, Y mirror barrels 9, 10 and CCD cameras 11, 12 to obtain the optical images of the cut-off part of the liquid crystal display substrate 18 and an oriented film, a seal agent and a conductive pattern for every inspection coordinates on the liquid crystal





display substrate 18 by these CCD cameras 2, 11, 12. They are recognized as images by a personal computer 14 to obtain the sizes of these widths and heights, etc., and to make difference values between the obtained sizes and the reference sizes display on a summing up monitor 16.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

Searching PAJ 2/2 ページ

application converted registration]
[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting a

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-39599 (P2000-39599A)

(43)公開日 平成12年2月8日(2000, 2.8)

(51) Int.CL <sup>7</sup>		織別記号	F I		テーヤコート*(参考)
G02F	1/13	101	G 0 2 F 1/13	101	2 F 0 6 5
G01B	11/03		G 0 1 B 11/03	H	2G086
G 0 1 M	11/00		G 0 1 M 11/00	Т	2H088
G09F	9/00	3 3 8	G 0 9 F 9/00	338	5 G 4 3 5

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 15 頁)

(21) 出願番号	特顯平10-208284	(71)出願人	000005108
			株式会社日立製作所
(22)出順日	平成10年7月23日(1998.7.23)		東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(72)発明者	丸山 重信
			神奈川県横浜市戸駅区吉田町292番地 株
			式会社日立製作所生産技術研究所内
		(72)発明者	押田 自忠
		(12) JESTH	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株
			式会社日立製作所生産技術研究所内
		(7.0 (D.D.)	
		(74)代理人	100078134
		1	弁理士 武 顕次郎

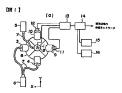
最終百に続く

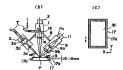
### (54) 【発明の名称】 液晶表示基板の検査方法及び装置並びに液晶表示基板

#### (57)【要約】

【課題】 TFT基板やCF基板などの液晶表示基板で の検査対象パターンの寸法計測結果を可視表示できるよ うにする。

【解決手段】 XYステージ17 に搭載された液晶表示 基板18を真上から照明して液晶表示基板18上の光学 像を得る落射照明鏡筒 1 とCCDカメラ2 とからなる落 射照明光学系と、液晶表示基板18上に45°に傾斜し て照明して液晶表示基板18上の光学像を得るスリット 投影光学X、Y鏡筒3、4と観測光学系X、Y鏡筒9、 10とCCDカメラ11、12とからなる光切断光学系 とが設けられ、これらCCDカメラ2、11,12で液 品表示基板18の切断部や配向膜、シール剤、薬電バタ ーンの光学像を液晶表示基板18上の検査座標毎に得。 パソコン14でとれらを画像認識してその幅や高さなど の寸法を求め、求めたこれらの寸法と基準寸法との差分 値を集計用モニタ16に可視表示させる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 TFT基板やCF基板、STN基板など の液晶表示基板の製造工程において、

該液晶表示基板での検査対象バターンの寸法計測結果を 該検査対象バターンの基準寸法との差分値に換算し、該 検査対象パターン毎に順次該差分値を経時的に表示する ととを特徴とする液晶表示基板の検査方法。

【請求項2】 請求項1に記載の液晶表示基板の検査方 注において、

前記検査対象パターンの計測する寸法としては、前記液 10 品表示基板でのガラス基板の切断寸法、該ガラス基板上 での配向膜の印刷寸法、該ガラス基板上でのシール剤の 塗布位置・塗布幅・塗布高さ, 該ガラス基板上での導電 ベースト塗布位置・塗布径のうちの少なくとも1つであ って、前記検査対象パターンの光学像を画像認識して計 測することを特徴とする液晶表示基板の検査方法。

【請求項3】 TFT基板やCF基板、STN基板など の液晶表示基板の製造工程において、

該液晶表示基板上に形成された検査対象バターンの光学 像を採取するための光学系と、

該光学系で採取した光学像を画像認識する手段と、

光学像から画像認識した該検査対象パターンの寸法を計 測し、その計測結果を該検査対象パターンの基準寸法と の差分値に換算して、該検査対象バターン毎に順次該差 分値を経時的に表示する手段とを備えたことを特徴とす る液晶表示基板の検査装置。

【請求項4】 TFT基板やCF基板、STN基板など の液品表示基板の製造工程において、

診済品表示基板上に形成された検査対象パターンの光学 像を採取するための光学系と、

該光学系で採取した光学像を画像認識する手段と、

該光学像から画像認識した該検査対象パターンの寸法を 計測し、その計測結果を該検査対象パターンの基準寸法 との差分値に換算し、該検査対象パターン毎に順次該差 分値を経時的に表示する手段と、

終計測結果を上位情報系に出力する手段とを備えたこと を特徴とする液晶表示基板の検査装置。

【請求項5】 請求項3または4記載の液晶表示基板の 検査装置において、

表示基板のガラス基板の切断寸法、該ガラス基板上での 配向膜の印刷寸法、該ガラス基板上でのシール剤の塗布 位置・塗布幅・塗布高さ、該ガラス基板上での導電ベー ストの途布位置・途布径のうちの少なくとも1つである ことを特徴とする液晶表示基板の検査装置。

「請求項61 ガラス基板トに液晶の配向膜としての有 機高分子薄膜が印刷されてなる液晶表示基板において、 少なくとも該有機高分子蘸膳の印刷端部の一部分に、該 印刷端部の位置計測のための金属材料もしくは有機材料 からなる不透明膜を設けたことを特徴とする液晶表示基 50 し、パーソナルコンピュータなどの機器に接続・実装す

板. 【請求項7】 請求項6記載の液晶表示基板において、 前記不透明膜は、前記有機高分子薄膜の印刷前に予め前 記ガラス基板上に配置されていることを特徴とする液晶 表示基板。

【請求項8】 請求項6または7記載の液晶表示基板に おいて

前記不透明膜は、配線バターンと同層に設けられている ととを特徴とする液晶表示基板。

【請求項9】 請求項6または7記載の液晶表示基板に おいて.

前記不透明難は、配線パターン上の絶縁膜上に設けられ ていることを特徴とする液晶表示基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示基板の製 造プロセスの監視技術に係り、特に、LCD(L iquid Crystal Display: 液晶表示装置) で液晶表示基板と して主に用いらるTFT(Thin Film Transister)基 20 板やSTN (Super Twisted Nematic)基板,及びそれ ちと組み合わせたCF(Color Filter)基板の組立工程 において、これらの液晶表示基板上に形成された各種パ ターンの寸法の検査方法及び装置、並びに計測の対象と なるかかる液晶表示基板に関する。

[0002]

【従来の技術】TFT-LCDで代表される液晶表示装 置は、パーソナルコンピュータなどの表示画面として従 来のCRT (Cathode Ray Tube) と同等の表示品質が得 られる一方、機器の省スペース化に大きく寄与すること 30 から、その需要が急速に拡大している。また、現在、そ の適用範囲拡大によって大画面化・高精細化・低消費電 力化といった機器の高性能化が要求されており、製造メ 一力では、各社独自方式の製品を開発し、他社製品との 差別化を図っている。

【0003】図14は液品表示装置の製造工程の概略を 示した説明図である。液晶表示装置の製造工程は、一般 に、アレイ工程(通称、前工程)とLCD工程(通称、後 工程)とに区別され、図14は、特に、CのLCD工程 を詳細に示したものである。

前記検査対象パターンの計測する寸法としては、該液晶 40 【0004】アレイ工程では、ガラス基板上にTFT素 子をマトリクス状に形成したTFT基板と、ガラス基板 Fic R (赤), G (緑), B (青) の色フィルタをマト リクス状に形成したCF基板とを夫々別々の製造工程で 製造する。そして、LCD工程において、これらTFT 基板とCF基板とを対向させて、これら間のギャップを 粉μm程度に制御し、精密に位置決めした上で貼り合わ せて、これら基板間に液晶を封入・封止する。以上の工 程で液晶表示パネルとしての製造が終了し、その後の組 立工程において、液晶表示パネルに駆動用ICを実装

3.

【0005】以上の一連の製造工程中、特に、アレイエ 程では、フォト・リソグラフ(製膜・レジスト塗布・露 光・現像・エッチング・レジスト剥離の一連の工程)で 製作された薄膜パターンの外観検査や断線検査、あるい はTFT素子などの特性検査が各製造プロセス単位で全 物行なわれており、検査終了後に不良品と判定されたも のを製造工程から排除する(修正可能なものは、欠陥を 修正して製造工程に戻す)ことにより、不良品がその後 の製造工程に流れ込まないようにするとともに、検査結 10 【0011】最後に、TFT基板とCF基板とを対向さ 里を製造装置にフィードバックすることにより、プロセ ス条件の調節や装置の点検を促すように作用させ、安定 した製造歩留まりを確保している。

【0006】一方、LCD工程についても、アレイ工程 と同様に、図14に示す手順で各製造プロセスの状態の 監視を行なっている。

【0007】即ち、初めに、アレイ工程で用いられてい る大形ガラス基板 (一般に、360mm×460mmな ど) に2面取りあるいは4面取りでバターニングされた TFT基板やCF基板を単位大きさに割断後(ステップ 20 めに、ギャップ検査や点灯検査(ステップ 1 1 3 . 1 1 100)、それらの割断後の寸法と割断部の欠けやクラ ックの有無を検査する(ステップ101)。

【0008】次に、TFT基板やCF基板上に液晶配向 用として機能させるための高分子膜(以下、単に配向膜 という)を転写・焼成し(ステップ102)、ラビングロ ーラを高速に回転させながら押し付けて配向膜をラビン グする(ステップ104)。配向膜としては、ポリイミド 系の高分子材料をNMP(N-メチルーピロリドン)など の溶剤に溶解させてワニス状とした材料が一般に多く用 いられており とれをローラで基板上に転写した後、ホ 30 して、常に低く推移している。従って、LCD工程の検 ットプレートやベーク炉で最大摂氏200度程度まで加 熱・焼成する工程を経て、基板上に高分子薄膜を形成す るものである。焼成後の配向膜の膜厚は、約0.1 μm 以下である。ととでは、配向膜の転写・焼成後、ガラス 基板上における配向膜の印刷寸法やピンホールの有無 と、ラビング後の配向膜に生じた傷やむらなどが検査対

象となる(ステップ103, 105)。 【0009】次に、TFT基板上やCF基板上に、液晶 封止用のシール剤(エポキシ系接着剤)と、TFT基板 とCF基板を貼り合わせた際にこれら基板間の導通を確 40 保するための遺電ペーストとを塗布する (ステップ10 6、108)。 導電ペーストとしては、直径数 µ mのブ ラスチック製の球体にNi、Auなどの金属膜をメッキ した導電性ビーズをシール剤と同様のエポキシ系接着剤 に分散させた溶液として用いられる。シール剤及び導電 ペーストは、マイクロディスペンサによって基板上に塗 布される。ことでは、シール剤や導電ベーストの塗布位 置や幅(塗布径)を検査し、さらに、シール剤について は、途切れの有無なども加えて検査する(ステップ10 7, 109).

【0010】次に、TFT基板やCF基板上に、これら 基板を貼り合わせた際にとれら基板間のギャップを一定 に保つためのスペーサを分散させる(ステップ11

 このスペーサとしては、直径数µmのプラスチッ ク製の球体を蒸留水を主成分とする溶媒に分散させ、霧 状に吹き付けることによって基板上に均一に分散させる 方式が主として採用されている。ととでは、基板上の単 位面積当たりに分散したスペーサの数と、スペーサの密 集の有無などを検査する (ステップ1111)。

せて貼り合わせ(ステップ112)、これら基板間のギ ャップが均一か否かを検査した後 (ステップ113)、 これら基板間に液晶を注入・封止することによって液晶 表示パネルとし(ステップ114)、点灯検査後(ステ ップ115) 次の細立工程で機器との接続が行なわれ

【0012】しかしながら、以上のLCD工程では、ア レイ工程と比較して、ガラス基板の切断寸法などの寸法 誤差がある程度までなら許容される検査対象物が多いた 5) 以外の検査が全て抜き取り検査となっているのが現 状である。さらに、LCDT程の検査は大部分が作業者 による手作業で行なわれているため、検査に時間を要す るし、見落としが生じたりして、作業者によっては計測 結果が異なるといった問題が生じている。また、LCD 工程では、検査結果が可視化されにくいために、検査結 果をタイムリに製造装置にフィードバックすることがで きないといった問題もあり、その結果として、LCDエ 程の製造歩留まりは、アレイ工程の製造歩留まりに比較 査を自動化することにより、LCD工程の製造歩留まり を大きく向上させる効果が期待される。

【0013】とのような状況下において、特開平9-9 0384号公報に記載のように、TFT基板上やCF基 板上に形成された液晶封止用シール剤の途切れを自動検 査し、シール剤の途切れを検出した場合には、その基板 を製造工程から抜き取るようにしてLCD工程の生産効 率を高める手法が提案されている。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記で 提案されている従来技術では、基板上に形成したシール 剤の途切れの有無のみを検査対象としているだけであっ て、その効果がLCD工程全体の製造歩留まりの向上に まで波及するとしても、その効果は著しく小さいものと 予想される。I.CD工程全体の製造場留まりを向上させ るためには、LCD工程における検査作業を可能な限り 自動化し、その検査結果を可視化するとともに、タイム リに製造装置にフィードバックするシステムの開発が必 須課題である。そのためには、TFT基板やCF基板上 50 に形成された各種パターンを必要充分な寸法精度で確実 に検出するための手段を開発する必要がある。

【0015】本発明の第1の目的は、液晶表示基板のL CD工程において、該液晶表示基板でのガラス基板の切 断寸法、配向膜の印刷寸法、シール剤の塗布状態及び導 雷ペーストの途布状態を自動計測し、その計測結果を可 視化するとともに、製造装置に即座にフィードバックす ることができるようにした液晶表示基板の検査方法を提 供することにある。

【0016】本発明の第2の目的は、液晶表示基板のL CD工程において、該液晶表示基板でのガラス基板の切 10 断寸法、配向膜の印刷寸法、シール剤の塗布状態及び導 電ペーストの塗布状態を自動計測し、その計測結果を可 視化するとともに、製造装置に即座にフィードバックす ることができるようにした液晶表示基板の検査装置を提 供することにある。

【0017】本発明の第3の目的は、液晶表示基板のし CD工程において、配向障の印刷寸法を自動計測するに 好適な液晶表示基板を提供することにある。

#### [0018]

【課題を解決するための手段】本発明は、L.C.D.工程の 20 検査対象項目のうち、その種類が共通である(即ち、基 板上におけるパターンの位置と形状の計測を対象とす る) ガラス基板の切断寸法や配向機の印刷寸法、シール 部の途布状態、連電ペーストの途布状態の検査を対象と する。配向膜のラビング状態検査とギャップ検査、点灯 検査については、検査対象がラビングむらや表示むらで あり また、スペーサ分散状態の検査では、検査対象と なるスペーサの寸法が数µmと小さく、他の検査対象物 と比較して極めて微小であることから、本発明の検査対 象から除外する。 30

【0019】上記第1の目的を達成するために、本発明 による検査方法は、検査対象パターンの寸法の自動計測 結果を該検査対象バターンの基準寸法との差分値に換算 し、該検査対象パターン毎に順次該差分値を経時的に表 示するようにする。

【0020】上記第2の目的を達成するために、本発明 による検査装置は、検査対象バターンの光学像を採取す るための光学系と、該光学系で得られた光学像を画像認 識する手段と、該検査対象パターンの寸法の自動計測結 果を該検査対象バターンの基準寸法との差分値に換算し 40 て診検査対象パターン毎に順次該差分値を経時的に表示 する手段と 波計測結果を上位情報系に出力する手段と を備える構成とする。

【0021】上記第3の目的を達成するために、本発明 の液晶表示基板は、配向膜の印刷寸法計測用のパッドを ガラス基板上に予め形成した構成とする。

#### 100221

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に より説明する。図1は本発明による液晶表示基板の検査 方法及び装置の一実施形態を示す図であって、同図

(a) は全体構成図であり、1 は落射照明鏡筒、2 は2 /3 インチ白黒CCDカメラ、3 はスリット投影光学系 X鏡筒、4はスリット投影光学系Y鏡筒、5,6は照明 光源としてのハロゲンランプ、7は光ファイバ、8は光 学系ベース、9は観察光学系X鏡筒、10は観察光学系 Y鏡筒、11は2/3インチ白黒CCDカメラ、12は 光切断鏡筒YのCCDカメラ、13は画像入力/処理ボ ード、14はパソコン、15は画像観察用モニタ、16 は検査結果の集計用モニタである。また、図1(b)は 図1(a)における観察光学系の構造及び検査対象であ STFT基板に対する配置関係を示す図であって、1は 落射照明鏡筒、1 a は2倍対物レンズ、1 b はハーフミ ラー、3aはコリメートレンズ、3bはスリット、3c は3倍対物レンズ、9aはリレーレンズ、9bは10倍 対物レンズ. 17はXYステージ. 17aは反射体. 1 8は液晶表示基板、Pは光照射中心点であって、図1 (a) に対応する部分には同一符号をつけている。 さら に、図1(c)は図1(b)におけるXYステージ17 上での液晶表示基板18の搭載状態を示す図であって、 図1(b)に対応する部分には同一符号をつけている。 【0023】この実施形態は、液晶表示基板としてTF T基板を用いるTFT-LCDの製造工程を例とするも のであり(従って、以下では、液晶表示基板18をTF T基板18とする)、観察光学系によって検査対象とな るTFT基板やSTN基板、CF基板でのガラス基板の 切断部、ガラス基板上での液晶の配向膜の印刷端部、シ ール剤及び導電ペーストの光学像を採取し、画像処理に よってかかる検査対象物の寸法を計測するものとしてい

【0024】図1(a)、(b) において、TFT基板 18がXYステージ17トに搭載されており、観察光学 系は、このTFT基板18に真上から光を照射し、その 光学像を検出する1個の落射昭明光学系と、このTFT 基板18に斜めから光を照射し、その光学像を検出する 2対の光切断光学系とが組み合わされて構成される。 【0025】落射照明光学系は、2倍対物レンズ1aと ハーフミラー1 b とを収納した落射照明鏡筒1に2/3 インチ白黒CCDカメラ(以下、CCDカメラという) 2が取り付けられた構成をなしている。そして、図1 (b) に示すように、ハロゲンランプ5から光ファイバ 7を介して入射される光がハーフミラー1bで真下の方 向(矢印7方向)に反射され、2倍対物レンズ1aによ ってXYステージ17に載置されたTFT基板18上に 集光照射される。この照射範囲の中心点を光照射中心点 Pという。このTFT基板18の光照射範囲からの反射 光は2倍対物レンズ1a、ハーフミラー1bを介してC CDカメラ2で受光される。これにより、TFT基板1 8の光照射範囲内の光像が CCDカメラ2によって検 出され、画像信号として画像入力/処理ボード13 に供 50 給される。

【0026】 CCで、対物レンズ 1aの開口率は0.0 6 作動距離は92mmであり、これにより、TFT基 板18上の3mm角の領域をCCDカメラ2で観察する ことができる。また、CCDカメラ2上での画素寸法は 7 umである。

【0027】一方、光切断光学系は、光照射手段と受光 手段とがX方向に配列されてなるX光切断光学系と、同 じく光照射手段と受光手段とがY方向に配列されてなる Y光切断光学系とで構成されており、これらX、Y光切 断光学系は同じ構成をなしている。図1(b)では、そ 10 の一方であるX光切断光学系が示されており、これによ って光切断光学系について説明する。

【0028】X光切断光学系は、コリメートレンズ3a とスリット3 b と 3 倍対物レンズ 3 c とを収納したスリ ット投影光学系X鏡筒3と、10倍対物レンズ9 b とり レーレンズ9 a とを収納して2/3インチ白黒CCDカ メラ11 (以下、CCDカメラという) が取り付けられ た観察光学系X鏡筒9とから構成されており、これらス リット投影光学系X鏡筒3と観察光学系X鏡筒9とは、 TFT基板18上の上記光軸中心点Pを挟んで、X方向 20

互いに反対側に配置されている。また、スリット投影光 学系X鏡筒3は、そとに収納されているコリメートレン ズ3 a と幅が2 5 μm、長さが5 mmのスリット3 b と 3倍対物レンズ3cとの光軸が光軸中心点Pを通り、か つTFT基板18の表面に対して45度の角度となるよ うに、傾けられており、同様にして、観察光学系X鏡筒 9 A そとに収納されている10倍対物レンズ9 b とり レーレンズ9 a との光軸が光軸中心点Pを通り、かつT FT基板18の表面に対して45度の角度となるよう

明鏡篇1との間でこのような配置関係が固定されるよう に、これらスリット投影光学系X鏡筒3、観察光学系X 鏡筒 9 が、落射照明鏡筒 1 とともに、光学系ベース 8 に 取り付けられている。

【0029】かかる構成において、スリット投影光学系 X鏡筒3では、ハロゲンランプ6から光ファイバ7を介 して入射される光がコリメートレンズ3aで平行光とさ れ、スリット3bでその一部が抽出されて3倍対物レン ズ3cを介し、TFT基板18上の光軸中心点Pを中心 とするスリット3bで決まる範囲に照射される。この範 40 置での光切断鏡筒のCCDカメラ11あるいは12の結 囲からの反射光(以下、スリット光という)は観察光学系 X鏡筒9に入射され、10倍対物レンズ9bとリレーレ ンズ9aを介してССDカメラ11で受光される。これ により、TFT基板18で反射されるスリット光の光像 がCCDカメラ11で検出され、画像信号として画像入 カノ処理ボード13に供給される。

【0030】ととで、3倍対物レンズ3cの開口率は 0.07. 作動距離は72.5mmであって、TFT基板 18上でのスリット3bの投影を幅12μm,長さ1. 7 mmの寸法に縮小する。観察光学系X鏡筒9は、TF 50 る変動量を算出することにより、Zステージの最適な高

T基板18上に縮小投影されたスリット3bの投影領域 からの全反射光をCCDカメラ11で観察する。CCD カメラ11では、TFT基板18上でのスリット3bの 縮小投影領域の長さ1.7mmのうち、長さ1.5mmの 範囲を観察するととができる。対物レンズ9 bの開口率 は0.28、作助距離は33.5mmであって、CCDカ メラ11上での画素寸法は2.5 μmである。

【0031】Y光切断光学系についても、これらを構成 するスリット投影光学系Y鏡筒4と観察光学系Y鏡筒1 Oとが、光軸中心点Pを挟んでX方向に直交するY方向 互いに反対側に配置されていること以外、X 光切断光学 系と同様であり、光学系ベース216で固定されてい る。1対で光切断光学系を形成している。

【0032】 ここで、以下の説明を簡明にするために、 スリット投影光学系X鏡筒3と観察光学系X鏡筒9とを 単に光切断鏡筒Xといい、スリット投影光学系Y鏡筒4 と観察光学系Y鏡筒10とを単に光切断鏡筒YというC とにする.

【0033】TFT基板18はXYステージ17に搭 裁、固定されており、このXYステージ17がXY方向 に移動することにより、TFT基板18の位置決めが行 なわれる。このXYステージ17には、搭載されたTF T基板よりも外周の全周にわたって落射照明鏡筒 1から の昭明光を反射するための反射体 17 a が設けられてい る。この反射体17aは、アルミニウムやステンレスな どの金属の表面をパフ研磨して鏡面とされた正反射体、 あるいはかかる金属に表面処理(例えば、白色アルマイ ト処理など)を施して散乱反射体とした短冊形状の反射 体であり、TFT基板18の搭載面から10mm~15 に、傾けられている。そして、落射照明光学系の落射照 30 mm凹んだ全周領域に配置される。このように構成する と、TFT基板18の切断部の画像認識に好適な光学像 を得ることができる。

> 【0034】なお、以上の構成の観察光学系は図示しな いZステージに固定されており、このZステージが上下 動するととにより、観察光学系の焦点合わせを行なうと とができるように構成されている。この焦点合わせに は、光切断鏡筒XのCCDカメラ11あるいは光切断鏡 筒YのCCDカメラ12で得られる光学像を用いる。 【0035】即ち、落射照明鏡筒1の焦点を合わせた位

> 像面におけるスリット光の結像位置PxあるいはPy (CCDカメラ12に対するもの) をパソコン14のメ モリに予め記憶しておき、TFT基板18の表面の高さ の変動によって変化するスリット光の結像位置Pxある いはPyと記憶した結像位置PxあるいはPyとの差を CCDカメラの結像面における画素数で求め、との結像 位置の差 (画素数) ×画素寸法÷√2により、TFT基 板18の表面の高さの変動量を算出できる。 バソコン1 4では、TFT基板18上の観察位置が変わる度にかか

さを決定する.

【0036】なお、XYステージ17と図示しないZス テージは、図示しないコントローラを介して、パソコン 14からその動作が制御される。また、ハロゲンランプ 5. 6は、パソコン14内のD/Aボードを介して電圧 を設定することにより、その光量制御が行なわれる。さ らに、パソコン14は、製造現場内の情報ネットワーク に接続されており、検査結果を上位情報系に出力するC とが可能である。

q

[0037]次に、TFT基板を例として、液晶表示基 10 板の検査手順を説明する。始めに、作業者は、TFT基 板の夫々の品種毎に、液品表示基板上における検査座標 (画像を採取する座標)と、検査座標に対応した基準寸 法 (設計値) とを図示しない入力手段から入力し、バソ コン14に登録する。

【0038】図2はTFT基板18の基板切断寸法を計 測する際の入力情報を示す図であり、ここでは、アレイ 工程で使用されている360mm×460mm×0.7 mm屋の大形ガラス基板を割断し、230mm×460 mmの大きさに分割した後のガラス基板の寸法を検査す 20 るものとする。

[0039] TFT基板18上には、アレイ工程でアラ イメントマークM1, M2が形成されており、TFT基 板18での有効表示領域18a(例えば、12.1イン チサイズの表示画面)をはじめ、LCD工程で形成され る各種パターンは全てアライメントマークM 1を基準位 置として表現する。作業者は、検査座標として8点の座 標C1~C8と、これら検査座標C1~C8に対応した 基準寸法(切断寸法)とをパソコン14に入力/登録す X1、検査座標C3, C4における基準寸法はY2、検 査座標C5、C6における基準寸法はX2、検査座標C 7. C8における基準寸法は-Y1である。

【0040】図3はTFT基板18での液晶の配向膜1 9の印刷寸法を計測する際の入力情報を示す図である。 ととでは、TFT基板18上の有効表示領域18aに配 向膜19が形成された状態を示している。

【0041】この配向膜19は、ポリイミドなどの有機 高分子材料を、例えば、NMP(N-メチルーピロリド ン)などの溶剤に溶解させてワニス状とした材料を、印 40 て、3点の導電ベースト21a~21cの塗布位置の座 刷ローラでTF T基板18上の有効表示領域18aに転 写した後、ホットプレートやベーク炉で最大摂氏200 度程度まで加熱・焼成する工程を経て形成した高分子薄 膜であって、焼成後の膜厚は約0.1 µmとなってお り、有効表示領域18aを覆う形で形成される。

[0042]作業者は、検査座標として8点の座標C9 ~C16と各検査座標C9~C16に対応した基準寸法 (配向膜印刷寸法)とをパソコン14に入力して登録す る。ととでは、例えば、検査座標C9, C10における 基準寸法はX3、検査座標C11、C12における基準 50 定を行なう。

寸法はY4、検査座標C13、C14における基準寸法 はX4、検査座標C15, C16における基準寸法はY 3である。

【0043】図4はTFT基板18上でのシール剤20 の途布状態を計測する際の入力情報を示す図である。と こでは、TFT基板18上に配向膜19とシール剤20 が形成された状態を示している。

[0044]シール剤20は、粘度10Pa・s前後の エポキシ系接着剤がマイクロディスペンサを用いてTF T基板18上に始点SPから終点EPまで一筆書きで塗 布され、これら始点SP、終点EP間を液晶注入用の開 口とした形状となっている。このシール剤20について は、その塗布位置、塗布幅及び塗布高さを計測する。 [0045] とのため、作業者は、検査座標として8点 の座標C 1 7 ~ C 2 4 とこれら検査座標C 1 7 ~ C 2 4 に対応した基準寸法(塗布位置、塗布幅、塗布高さ)を パソコン14に入力して登録する。例えば、検査座標C 17、C18における塗布位置は-X5、検査座標C1 C20における塗布位置はY6、検査座標C21。 C22における塗布位置はX6、検査座標C23, C2 4における途布位置は-Y5である。さらに、検査座標

布高さを、例えば、10μmと設定する。 【0046】図5はTFT基板18上での導電ペースト の途布状態を計測する際の入力情報を示す図である。と こでは、TFT基板18上に配向膜19とシール剤20 と導電ペースト21a~21cが形成された状態を示し ている。

C17~C24での塗布幅を、例えば、300 μm、塗

【0047】 これら導電ペースト21a~21cは、T る。例えば、検査座標C1, C2における基準寸法は- 30 FT基板18とCF基板とを貼り合わせる際に、これら 基板間の導通を確保する目的で用いられており、直径数 μmのプラスチック製の球体にNi、Auなどの金属膜 をメッキした導電性ビーズをシール剤20と同様のエボ キシ系接着剤に分散させた溶液とし、これをマイクロデ ィスペンサを用いて塗布したものである。

【0048】シール剤20については、その塗布位置と 途布径とを計測する。導電ペースト21a~21cの計 測の場合には、その塗布位置の基準寸法(座標)が検査 座標と一致する。このため、作業者は、検査座標とし

標(以下、座標21a, 21b, 21cという) の基準 寸法(塗布位置、塗布径)をパソコン14に入力して登 録する。例えば、検査座標21aにおける塗布位置は (X7, Y7)、検査座標21bにおける塗布位置は(X Y8)、検査座標21cにおける塗布位置は(X8) Y7)である。さらに、検査座標21a~21cでの塗 布径を、例えば、300μmに設定する。

【0049】なお、上記では、TFT基板18を対象と して説明したが、CF基板の場合でも、同様の手順で設

【0050】以上説明した手順により、作業者は、検査 対象のTFT基板とCF基板との品種毎に、検査座標と 検査座標に対応した基準寸法を設定する。なお、検査座 標については、各計測対象物について、最大100点ま で設定するととが可能であって、作業者の判断によって 適宜増減させることができる。

【0051】作業者は、製造工程中から、例えば、1時 間に1回の頻度でTFT基板とCF基板とを1枚ずつ抜 き取って、図1において、XYステージ17上に搭載す る。そして、かかる基板上から読み取った製造番号と検 10 査対象項目(ガラス基板の切断寸法、ガラス基板上での 配向膝の印刷寸法、ガラス基板上でのシール剤の塗布状 68. ガラス基板トでの導電ペーストの塗布状態のうちの 1つ、あるいは複数個選択することが可能)をパソコン 14に入力し、しかる後、検査の開始を指示する。基板 の製造番号は、その基板の固有値として定義されてい

【0052】次いで、パソコン14内でTFT基板とC F基板との区別及び品種の判断を行ない、TFT基板あ るいはCF基板のアライメント動作後、品種別に予め登 20 ると、図6(a),(b)に示すように、面取り部の輝 録されている検査座標が観察光学系の光照射中心点Pと 一致するように、XYステージ17を順次移動させる (例えば、基板切断寸法の計測であれば、図2におい て、検査座標C1→C2→……→C8の順とする)。 【0053】そして、各検査座標で検査対象物の光学像 を採取し、画像認識によりその寸法を順次計測する。具 体的には 採取画像上での各計測対象物の画像認識座標 とXYステージ17に内蔵されたリニアスケールの座標 とから、TFT基板18上での計測対象物の座標(アラ イメントマークM1からの距離)を算出する。なお、画 像を採取する際のハロゲンランプ5、6の光量は、各計 測対象物毎に予め最適化されているものとし、各計測対 象物毎にパソコン14からその光量を制御する。検査終

【0054】あるいは、例えば、TFT基板やSTN基 板、CF基板といった液晶表示基板のガラス基板の切断 工程を終了した段階で、このガラス基板を撤送装置で自 動で抜き取り、そのガラス基板を図示しない移載装置で XYステージ17上に搭載し、図示しない製造番号読取 40 配線パターンと干渉しない位置に、例えば、この配線パ 部でこのガラス板上の製造番号を読み取った後、ガラス 基板の切断寸法の計測を開始する。検査終了後のガラス 基板は、関示しない移載装置と撤送装置とにより、次の 製造工程(配向膜印刷・焼成工程)に再投入される。 【0055】このように、1つの製造工程が終了する毎

了後のTFT基板及びCF基板は、作業者によって再度

製造工程に戻される。

に、作業者を介すことなく、全自動で検査を行なうこと も可能である。

【0056】次に、各寸法計測対象物の画像認識方法に ついて説明する。

【0057】図6(a)は図2で示したTFT基板18 50 領域に配置される。従って、配向膜19の印刷位置の検

の検査座標C1を視野中心とした範囲でのCCDカメラ 2による採取像(以下、これを落射照明観察像という) を示す図である。ことでは、256階調表現とする。こ のTFT基板18のガラス基板の切断工程では、ガラス 割断後にエッジ部に面取りが施され、図6(a)でハッ チングして示すように、この面取り部は輝度が低い状態 で観察される。

【0058】図6(b)は図6(a)の切断部と直交す る分断線A-A' に沿う輝度を示す図である。

【0059】同図(b) において、この分断線A-A' と予め設定された関値LS1との交点は(ア)。

(ア) の2ヶ所あるが、そのうちのTFT基板18の 外側の交点 (ア) の座標を求め、それを検査座標C1に おけるガラス基板の切断位置とすることができる。そし て、との座標(ア)をTFT基板18上のアライメント マークM1を基準にした座標に換算し、パソコン14の メモリに記憶する。

【0060】なお、ガラス基板の切断位置の画像認識 時、XYステージ17上に反射体17aが配置されてい 度が低い画像認識に好消な画像を得ることができる。こ れは、落射照明鏡筒1 (図1) の照明光が反射体17a で反射し、その反射光が2倍対物レンズ1aに取り込ま れるために、図6(a)において、TFT基板18が存 在しない領域の解度を高くすることができるからであ る。XYステージ17上に反射体17aを設けない場合 には、図6 (a) の分断線A-A' に沿う輝度は、図6 (c) に示すように、TFT基板18の外側が低反射率 のものとなり、図6 (b) で示したようなガラス基板の 30 切断位置の認識が不可能となる。

【0061】図7(a)は図3で示したTFT基板18 上に配向膜19の印刷位置認識用のバッド22a~22 hを配置した様子を示す図である。

[0062]配向膜19は、厚さ0.1 μmと非常に薄 い透明体隙 (ポリイミド薄糠) であるため、TFT基板 1.8 上の配線パターンが存在する部分では、その印刷端 部の認識が極めて困難となる。そこで、図7 (a) に示 すように、TFT基板18のアレイ工程で(少なくと も、配向膜19を印刷する前に)、TFT基板18上の ターンと同層に、予め検査用パッド22a~22hを形 成しておき、LCD工程での配向膜19の印刷・焼成後 の寸法計測を検査用バッド上で行なう方式を採用してい

【0083】 これら検査用パッド22a~22hは、図 7 (h) に示すように、例えば、一辺が9 m m の正三角 形状をなしており、落射照明鏡筒1のCCDカメラ2

(図1) の観察領域 | A (ここでは、3 m m 平方とす ス)を包み かつ配向膜19の印刷位置精度を考慮した 査の前に予め作業者がパソコン14に入力するパラメー タ (基板 1 8 上での検査座標 C 9 ~ C 1 6 ) について は、検査用バッド22a~22hの位置を考慮して指定 する必要がある。

[0064]また、検査用パッド22a~22hには、 CrやAl, Ni, Mo, Wなどの金属材料、あるいは 遮光性有機材料を用いることができる。なお、検査用バ ッド22a~22hは、TFT基板18上の配線パター ン上に層間絶縁膜を介して配置することもでき、これに より、検査用パッドの数(計測点数)を増加することも 10 可能である。

【0065】図8(a)は図3に示したTFT基板18 トの検査座標C9でのCCDカメラ2による落射照明観 察像を示す図である。 ここでは、256階調表現とす

【0066】配向膜19の印刷には、特殊なローラが用 いられているために、TFT基板18上に転写された配 向膜19の辺19aは直線バターンとはならず、特徴的 なパターン(うねり)が生じる。図8(a)に示す落射照 明観察像について、配向膜19の印刷辺部19aと平行 20 方向な3つの分断線B-B', C-C', D-D'での 輝度を観察したところ、夫々図8(b), (c). (d) で示す結果が得られた。

【0067】 これにより、配向膜19の印刷端部19a のうねりバターンの近傍の分断線C-C'に沿う輝度の みに、配向膜19の辺19aのうねりパターンの特徴が 反映されることを確認した。即ち、落射照明観察像にお ける配向膜19の印刷辺部19aと平行な方向に沿う輝 度変化の振幅に着目し、この輝度振幅が最大となる分断 における配向膜 1.9 のED刷付置とすることができる。そ して、落射照明観察像上の分断線C-C'の位置をTF T抹板18 トのアライメントマークM1(図3)を基準 にした座標に換算し、パソコン14のメモリに記憶す

【0068】図9(a)は図4に示したTFT基板18 Fの検査座標C17でのCCDカメラ2(図1)による 基進座標C17を視野中心とする落射照明観察像を示す 図であって、ととでも、256階調表現とする。かかる 落射照明観察像では、TFT基板18上に形成されたシ 40 ール剤20は、図9(a)に示すように、背景に対して 暗く観察される。

【0069】図9(b)は図9(a)での視野中心を通 る分断線E-E'(シール剤20の塗布方向と直交する 方向) に沿う輝度レベルを示す図である。

【0070】同図(b)において、この分断線E-E' での細度レベルと予め設定された關値LS2との交点は (イ)、(ウ) と2ヶ所あり、これら間の距離(=画素 数×画素寸法)を検査座標C17におけるシール削19 の途布幅とすることができる。また、これら交点

14 (イ)、(ウ)間の中点(エ)をシール削19の塗布位 置とする。そして、これらをパソコン14のメモリに記 憶する。また、中点(エ)をTFT基板18上のアライ メントマークM 1を基準にした座標に換算し、パソコン 14のメモリに記憶する。

【0071】シール創20の検査については、その検布 幅と塗布位置の他に、その塗布高さも対象とする。これ はシール剤20が過剰に塗布された場合、TFT基板と CF基板の貼り合わせ時にこれらガラス基板にクラック が生じ、製品の信頼性を低下させる可能性があるからで

【0072】図10 (a) は図4 に示したTFT基板1 8 上の検査座標C17を視野中心とする光切断鏡筒Yの CCDカメラ12 (図1) による採取像(以下、光切断 像という)を示す図であり、これも256階調表現とす

【0073】なお、とこでは、TFT基板18に印刷さ れたシール剤20のY軸方向に伸延する部分の塗布高さ を検査するものとして説明する。この場合には、Y光切 断光学系、即ち、スリット投影光学系Y鏡筒4と観測光 学系Y鎌筒10とCCDカメラ12とからなる光切断光 学系を用いる。

【0074】図10(a)において、CCDカメラ12 の視野内では、それをX軸方向に横切ってスリット投影 光学系Y鏡筒4 (図1) からの線状のスリット光SLが 投影される。また、このスリット光SLは、TFT基板 18の表面に対して45°の傾斜角で照射され、45° の傾斜角でCCDカメラ12に入射されるから、シール 約20の断面形状に応じて曲線状をなしている。そし 線(図8(a)では、分断線C-C')を検査座標C9 30 て、との曲線状の部分の頂部が塗布されたシール剤の頂 部を表わし、また、直線の部分がTFT基板18の表面 を表わしている。従って、スリット光SLの直線状の部 分と曲線状の部分の頂部とのY軸方向の距離が、このシ

ール創20の塗布高さの√2倍ということになる。 【0075】 CCで、TFT基板 18の表面とシール剤 20の頂部とは、Y軸の画素単位の座標毎のスリット光 SLが照射されている画素数(頻度)で判定する。い ま、CCDカメラ12の視野23内において、Y軸の座 標毎に頻度を求めると、図10(b)に示すように、ス リット光SLの直線状の部分が通る座標で最も損度が高 く、この座標を(オ)とする。また、この視野23の中 心(検査座標C17)はほぼシール剤20の塗布幅の中 心に設定されており、この視野中心を中心にシール剤2 ①の途布幅に略等しい幅の最大高さ検出範囲(この範囲) の値は予めバラメータとして設定されている) 内で、同 様にして、Y軸の座標毎に頻度を求める。この場合、塗 布されたシール創20の頂部付近は路平面となってお り、このために、スリット光SLの照射部分でのこの頂 部に相当する部分で傾度が最大となる。図10(b)で 50 は、このときの座標を(カ)として示している。

[0076] そこで、パソコン14(図1)は、このように座標(オ)、(カ)を求めてこれら座標間の距離 (= 画素数×画素寸法)を算出し、これをシール剤20

の途布高さとしてメモリに記憶する。
[0 17 月 以上は海温表所連絡 18 化像布きれたシール利2 0 の Y輪方向に伸延した部分についての陰布高さの検査であったが、 X輪方向に伸延した部分に、他方が近期未受率系 X鏡南 2 を 観測光学系 X鏡南 9 と C D カメラ 11 とからなる X 光 駅影光学系 X鏡南 9 と C D カメラ 11 とからなる X 光 駅脈光学系 H II で同様の検定処理を行なる K 北 [0 0 7 8] なお、シール利2 0 の途切れの有無につい

[0078]なお、シール剤20の差別れの有無については、マイクロディスペンサによる塗布プロセスの特性を考慮し、検査座標を適宜増加することで検査が可能である。ここで、光別断減節の視野内にシール剤が存在する場合の観察光学系の焦点合わせの際には、図10

(b) において、座標(オ)をCCDカメラ12の結像 面でのスリット光SLの結像位置と判断することによ り、TF T 接板18 表面の変位が把握可能であることは 自明である。

[0079]図11(a)は図5に示したTFT基板1 20 る。 8上の導電ペースト21aが途布された検査座様C25 にのCCDカメラ2(図1)による落射限明観察像を示 対図であり、ことでも、25日階減表現している。 デ

[0080] TFT基板18上に形成された導電ベースト21aは、背景に対して暗く観察される。図11 (a) に示すように得られた結射照明観察像を予め設定

(名) たいりょう たいけつないにおいますがあるようななと された2 値化関値で2 値化し、反転像としてラベリング する。さらに、各ラベリング候域の面積を求め、特定の 面積値の範囲(設計情報から決定される)のラベリング 領域のみに着目する。

【0081】即ち、図11(b)に示すように、遊電ペースト21aの着目したラベリング環境24の派の研究 公室質形し、たの新心摩標のを検査整備225における 導電ペースト21aの途布位置とすることができる。また、着目したラベリング領域24の外接円25の直径を 排電ペースト21aの途布位置とすることができる。また、着目したラベリング領域24の外接円25の直径を 排電ペースト21aの途布をとする。

[0082]そして、落結照明頻繁像上における重心座 解Qを下下不蓋板18上のアライメントマークM1(図 5)を基準にした降線に換策し、薄電ペースト21aの 塗布位置としてパソコン14のメモリに記憶する。また、外板円25の直径を導電ペースト21aの塗布径と してパソコン14のメモリに記憶する。

【0083】以上説明した方法により、下F丁基板18 の基板切断寸法やTF丁基板18 上に形成された配向膜 19の印刷寸法、シール剤20の塗布状態、薄電ペース ト21の塗布状態の検査を行なりことができる。

【0084】なお、以上では、検査対象の基板として、 下F「基板を例に説明したが、下FT-LO用のCF 基板や、STN-LCD用のSTN基板及びCF基板と ついても、同様の手法で各様パターンの寸法計測が可能 50 き、検査頻度と検査の信頼性が向上した。

である。

[0085]以上の全ての計測結果は、例えば、図12 に示すような一覧表として、また、図13に示すような グラフ図として大々集計用モニタ16(図1(a))上 に表示する。

[0088]図12に示す一覧表では、下FT基板18 の品種別のシートに、その製造番号単位で計測結果をア ライメントマーク州1基準の登標値として特別してい る。ガラス基板切断工程終了後の下FT基板について、 基板切断寸法の計測を行なった場合には、(キ)で示す 個のない計場を出来を示し、下FT基板を次の製造工程

概のみに計画結果を表示し、TFT基板を次の製造工程 (耐心膜印刷・振成工程) に再度収入する。そして、 戸基板の配向原則・無放工程が 7級と正記のように配 向膜 19の印刷寸法を計画し、その結果を(ク)で示す 概と表示する。以下、各製造工程毎に同様の方法で寸法 計画を採り返すまうたする。

[0087] あるいは、導電ペースト塗布工程、または スペーサ分散工程まで終了したTFT基板に対して、全 ての計測対象を一度に纏めて計測することも可能であ

○。 (10088]また、図12に示す一覧変化格約された計 測データは、その基準寸法、規格値)と比較され、計削 データが万一場機の範囲外となった場合には、格約さ れた計削データを赤色表示する。さらに、計削核束が場 格額の範囲外となった場合や何らかの理由で計劃が不可 能となった場合には、作業者の判断で図示しない入力手 段からパソコン14に指示を行ない、その部分のみの寸 法計劃側外を異な行きせるとかできる。

[0089] 図13は図12に示した一覧表をグラフ表示 元 た 店集を示す図である。同図では、計劃結果から基準 古法を差し引いた数値をプロットしており、計劃結果を検査対象項目別化分類することにおり、夫々の計劃結果の協調等変化を監視することができる。そして、これによることができ、製造プロセスの貿易を早期に下部することができる。また、製造装置のメンテナンス関別の発過を図ることも可能となる。

【0090】なお、最終的な計測結果が規格値の範囲外 となった場合には、パソコン14から上位情報系に警報 40 を出力して該当する製造装置の運転を中断し、製造装置 の調整やメンテナンスを行なう。

【0091】以上説明レル手法で下下落板やCF基板 の寸法計測を行なったところ、失っ5分間で全ての計測 終下することが明らかになった。但し、検査整構(計 測点数)は、基板切断寸法で8点、配向額19の印明寸 法で8点、シール和200章布位置及び煙布後で8点、第二な で8点、第二なりとの空布位置及び煙布後で1 2点である。本発明の連邦により、作業権の手作家によ る計測と比較して、検査等間を大幅に短縮することがで き、検索頻度と検索の信頼性が向上した。 [0092]

[発明の効果]以上説明したように、本発明によれば、 TFT基板やCF基板、STN基板などの液晶表示基板 のLCD工程におけるパターンの寸法検査では、作業者 による計測結果のばらつきや見落としを防ぐことがで き、検査精度と信頼性とが大幅に向上する。

【0093】また、本発明によれば、液晶表示基板のし

CD工程におけるバターンの寸法検査に要する時間を大 幅に短縮でき、検査頻度が大幅に向上する。 【0094】さらに、本発明によれば、液晶表示基板の 10 れる寸法計測結果のグラフを示す図である。

LCD工程におけるバターンの寸法検査の結果を可視化 でき、製造プロセスの異常を早期に予測するとともに、 製造プロセスに検査結果を即座にフィードバックするこ

とが可能となる。

【0095】さらにまた、本発明によれば、液晶表示基 板上に配向膝の臼捌位置の認識用バッドを設けることに より、該液晶表示基板上における配向膜の印刷位置を確

実に検査することが可能となる。 【0096】そして、以上のことから、液晶表示基板の 製造歩留まりが向上して、液晶表示基板の製造原価を低 20 3 b スリット 減し、さらに、産業廃棄物を低減させる効果も奏するも

のである。

【関面の簡単な説明】

【図1】本発明による液晶表示基板の検査方法及び装置 の一実施形態を示す図である。

【図2】図1に示す実施形態での液晶表示基板のガラス 基板の切断寸法を計測する際の入力情報を示す図であ る。

【図3】図1に示す実施形態での液晶表示基板上の配向 膜の印刷寸法を計測する際の入力情報を示す図である。 30 13 画像入力/処理ボード

【図4】図1に示す実施形態での液晶表示基板上のシー ル剤の塗布状態を計測する際の入力情報を示す図であ る。

【図5】図1に示す実施形態での液晶表示基板上の導電 ベーストの塗布状態を計測する際の入力情報を示す図で ある。

【図6】図1に示す実施形態での液晶表示基板のガラス 基板の切断位置の画像認識方法を示す図である。

【図7】図1に示す実施形態での液晶表示基板上の配向 障のED開付層認識用のバッドを配置した液晶表示基板を 40 21a~21c 導電ペースト 示す図である。

【図8】図1に示す実施形態での液晶表示基板上の配向

膜の印刷位置の画像認識方法を示す図である。

【図9】図1に示す実施形態での液晶表示基板上のシー ル剤塗布状態の画像認識方法を示す図である。

【図10】図1に示す実施形態での液晶表示基板上のシ ール剤の塗布高さの画像認識方法を示す図である。

【図11】図1に示す実施形態での液晶表示基板上の導 電ベーストの塗布状態の画像認識方法を示す図である。 【図12】図1における計測結果表示用モニタで表示さ

【図13】図1における計測結果表示用モニタで表示さ

れる寸法計測結果の一覧表を示す図である。

「図14]液晶表示装置の製造工程の概略を示した説明 図である。

【符号の説明】

1 落射昭明鏡筒

1a 2倍対物レンズ

1b ハーフミラー

2 CCDカメラ 3 スリット投影光学系X鏡筒

3a コリメートレンズ

3 c 3倍対物レンズ

4 スリット投影光学系Y鏡筒

5.6 照明光源

7 光ファイバ

9 観察光学系X鏡筒 9a リレーレンズ

9 h 1 0 倍対物レンズ

10 键零光学系Y鏡筒

11.12 CCDカメラ

14 パソコン

15 画像観察用モニタ

16 検査結果の集計用モニタ 17 XYステージ

17a 反射体

18 液晶表示基板

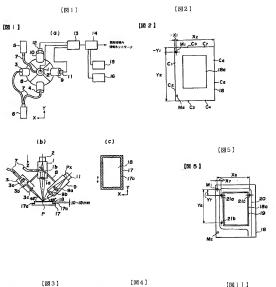
18a 有効表示領域

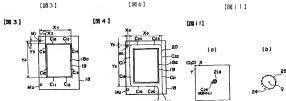
19 配向膜 2.0 シール剤

22a~22h 配向膜の印刷位置認識用パッド

C1~C25 檢查座標

M1. M2 アラインメントマーク







[図6]

(Q, Q) X 面取U部 Y (7) 2 A C1 / 2 A (機野中心) 7 FFT基板 [图7]



(b)



(b)

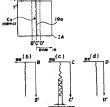


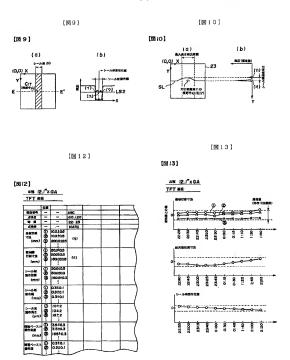
[図8]

(c)



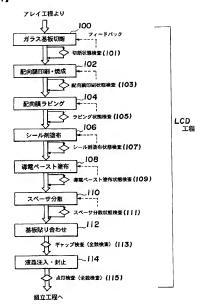
[28 8]





(図14)

# [図14]



フロントページの続き

(72)発明者 佐々木 英司 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 丹羽 進 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 ドターム(参考) 2F065 AA03 AA21 AA24 AA61 8802 CC00 CC21 FF01 FF04 G05 J02 HH04 HH05 J103 J105 J03 J126 LL03 LL04 LL28 IM03 PP12 Q013 Q031 RR08 2G086 FE10 2 H088 FA02 FA03 FA06 FA11 FA25 FA26 H001 H403 M416 Sc435 AA00 AA27 BB12 KK00 KK10